UNIVERSIDAD DE CHILE FACULTAD DE CIENCIAS



SÍNTESIS Y CARACTERIZACIÓN DE FASES CALCOFOSFATO

ANTONIO CÉSAR GALDÁMEZ SILVA

Santiago de Chile, Julio 2004

SÍNTESIS Y CARACTERIZACIÓN DE FASES CALCOFOSFATO

Tesis
entregada a la
Facultad de Ciencias
Universidad de Chile
en cumplimiento parcial de los requisitos
para optar al grado de
Doctor en Química

por

ANTONIO CÉSAR GALDÁMEZ SILVA

Julio, 2004

Director de Tesis: Dr. Víctor Manríquez Castro

UNIVERSIDAD DE CHILE **FACULTAD DE CIENCIAS**



INFORME DE APROBACIÓN TESIS DE DOCTORADO

Se informa a la Escuela de Postgrado de la Facultad de Ciencias que la Tesis de doctorado presentada por el candidato

ANTONIO CÉSAR GALDÁMEZ SILVA

Ha sido aprobada por la Comisión de evaluación de tesis como requisito para optar al grado de Doctor en Química, en el examen de defensa de tesis rendido el 16 de Abril del 2004.

Director de Tesis:

Dr. Víctor Manriquez

Comisión Evaluación Tesis:

Dra. Evgenia Spodine (presidente)

Dra, María Teresa Garland

Dr. Galo Cárdenas

Dr. Nicolás Yutronic

Dr. Juan Luis Gautier



Pensad bien en esto:

Las cosas admirables que aprendéis a conocer en vuestras escuelas son obra de numerosas generaciones, creadas en todos los países de la tierra al precio de grandes penas y esfuerzos apasionados. Todo esto es depositado en vuestras manos como herencia, de manera que la recojáis, que lo veneréis, que lo desarrolléis y lo trasmitáis un día fielmente a vuestros hijos. Así, nosotros los mortales, somos inmortales en lo que creamos en común, contribuyendo a obras imperecederas.

Si pensáis siempre en esto, encontraréis un sentido a la vida y al esfuerzo, y adquiriréis una justa opinión con respecto a los demás pueblos y a las demás edades.

ALBERT EINSTEIN

A SILVIA
A MI FAMILIA

C. DE CHILE + SYL

AGRADECIMIENTOS

Expreso mis agradecimientos a todas las personas que contribuyeron en la realización de este trabajo de investigación,

En especial a mi profesor guía y amigo Dr. Víctor Manríquez; por su amistad, constante apoyo y dedicación en la realización de esta tesis, contribuyendo a mi formación personal y profesional.

A mis amigos y compañeros Patricia Barahona y Domingo Ruiz-León por su amistad y atención en las labores desempeñadas en el Laboratorio.

Al Dr. Octavio Peña por su acogida en mi estadía de investigación.

Al Dr. J. Kasaneva y al Dr. R. Ávila por su tiempo, disposición y buena voluntad en la realización de las medidas eléctricas.

A la comisión de Tesis integrada por: Dra. E. Spodine, Dra. María Teresa Garland, Dr. Galo Cárdenas, Dr. J. L. Gautier y Dr. N. Yutronic.

A Silvia por su amor y apoyo en los momentos difíciles; por su compañía en los momentos de alegría.

A mis Padres y hermanos por su cariño y comprensión,

Finalmente agradezco el financiamiento otorgado por:

Departamento de Postgrado y Postítulo, Vicerrectora de Asuntos Estudiantiles, Universidad de Chile, a través de la Beca PG/11/2000.

Departamento de Química, Facultad de Ciencias, Universidad de Chile; a través de la Beca Luis Sepúlveda.

Departamento de Formación de Recursos Humanos y Becas de Postgrado (CONICYT), a través de la beca de doctorado y beca de apoyo a la realización de tesis doctoral 2002.

Al proyecto PICS CNRS-CONICYT N° 922, por el financiamiento otorgado en la estadía de investigación realizada en el Laboratoire de Chimie du Solide et Inorganique Moléculaire. Université de Rennes 1. RENNES-FRANCIA.

RESUMEN

El objeto de esta tesis fue la preparación, estudio de propiedades estructurales y eléctricas de nuevas fases cristalinas tipo AMP_2Q_6 (A = Li, Na, K, Cu, Ag; M = Bi, Sb y Q = S, Se), soluciones sólidas tipo $A_{1-3x}Bi_{1+x}P_2Se_6$ (A = Cu, Ag; X = 0.1; 0.2), $CuBi_{1-x}Sb_XP_2Se_6$ (X = 0.1; 0.2; 0.3) y $Bi_{1-x}Sb_XPQ_4$ (Q = S, Se, X = 0.1; 0.2; 0.3), estabilizadas por los aniones calcofosfato $[P_2Q_6]^{4-}$ y $[PQ_4]^{3-}$ (Q = S, Se). Los compuestos fueron preparados utilizando el método cerámico (combinación directa, transporte de vapor) y mezcla fundente. Cada uno de los productos de reacción fueron analizados mediante absorción atómica (ICP-Plasma) y Microscopía electrónica de Barrido con analizador de energías dispersivas de rayos X (MEB-EDX). Las estructuras cristalinas fueron analizadas mediante difracción de rayos X (DRX) y espectroscopia Infrarroja (FTIR). El estudio de las propiedades eléctricas se realizó mediante técnicas de corriente continua y alterna (espectroscopia de impedancia compleja).

Los compuestos AMP₂Se₆ (A = Cu, Ag; M = Bi, Sb) $A_{1-3X}Bi_{1+X}P_2Se_6$ (A =Cu, Ag) y CuBi_{1-X}Sb_XP₂Se₆ son isoestructurales y poseen estructura bidimensional 2D relacionada con el compuesto Fe₂P₂S₆ (tipo monoclínico I). Estas fases son semiconductoras, con valores de conductividad σ del orden de $10^{-4} \, \Omega^{-1} \text{cm}^{-1}$ a temperatura ambiente. Medidas de impedancia compleja sugieren que el proceso de conducción eléctrico es controlado por la frontera de grano.

Los compuestos AMP₂Se₆ poseen comportamiento de materiales fotoconductores.

Los compuestos KMP₂S₆ (M = Bi, Sb) y NaSbP₂S₆ poseen estructura 2D que está relacionada con los compuestos Na_{0.16}Bi_{1.28}P₂S₆, Cs₈M₄(P₂Se₆)₅ y β -KSbP₂Se₆. Las fases KBiP₂S₆, NaSbP₂S₆ y KSbP₂S₆ son isoestructurales y poseen ligándos tipo etano P₂S₆⁴⁻ coordinados al metal M. La estructura consiste en láminas [MP₂S₆]_nⁿ⁻ separadas por cationes K⁺ y Na+, respectivamente. Cada lamina esta formada de octaédros distorsionados de azufre (S₆) ocupados alternadamente por pares P₂ y cationes M³⁺.

Soluciones sólidas tipo $Bi_{1-X}Sb_XPS_4$ poseen estructura tridimensional 3D relacionada con la fase $BiPS_4$. El compuesto $Bi_{0.9}Sb_{0.1}PS_4$ es aislante, con valor de conductividad eléctrica $\sigma < 10^{-12}~\Omega^{-1} cm^{-1}$ a temperatura ambiente. Las medidas eléctricas d.c. indican un comportamiento de materiales fotoconductores.

ABSTRACT

The object of this thesis was the preparation, study of structural and electric properties of new crystalline phases of the type AMP_2Q_6 (A = Li, Na, K, Cu, Ag; M = Bi, Sb and Q = S, Se) and solid solutions of the type $A_{1-3x}Bi_{1+x}P_2Se_6$ (A = Cu, Ag; x = 0.1; 0.2), CuBi_{1-x}Sb_xP₂Se₆ (X = 0.1; 0.2; 0.3) and $Bi_{1-x}Sb_xPQ_4$ (Q = S, Se, X = 0.1; 0.2; 0.3), stabilized by chalcophosphate anions $[P_2Q_6]^{4-}$ and $[PQ_4]^{3-}$ (Q = S,Se). The compounds were prepared by the ceramic method (direct combination, transport of vapor) and the flux method. Each one of the reaction products was analyzed by atomic absorption (ICP-plasm) and scanning electron microscopy with energy dispersive X-ray analysis (SEM-EDX). The crystalline structures were analyzed by X-ray Difracction (XRD) and Fourier Tranform Infrared spectroccopy (FTIR). The electrical measurements were recorded for application by d.c. and a.c techniques.

The compounds AMP₂Se₆ (A = Cu, Ag; M = Bi, Sb) $A_{1-3x}Bi_{1+x}P_2Se_6$ (A = Cu, Ag) y CuBi_{1-x}Sb_xP₂Se₆ are isoestructural and possess two-dimensional 2D structure related with Fe₂P₂S₆ (monoclinic I) type. These phases are semiconductors, with values of electrical conductivity σ of about $10^{-4}~\Omega^{-1}$ cm⁻¹ at room temperature. The complex impedance suggests that the process of electric conduction is controlled by the grain frontier. The compound AMP₂Se₆ possesses behavior of photoconductive materials.

The compounds KMP₂S₆ (M = Bi, Sb) and NaSbP₂S₆ possess a 2D structure that is related with the compound Na_{0.16}Bi_{1.28}P₂S₆, Cs₈M₄(P₂Se₆)₅ and β -KSbP₂Se₆. KBiP₂S₆, NaSbP₂S₆ and KSbP₂S₆ phases are isotropic and possess type-ethane P₂S₆⁴⁻ ligand coordinated to M metal. The structure consist of [MP₂S₆]_nⁿ⁻ layered separated by K⁺ y Na+ cations, respectively. Each layer they are formed by condensed S₆ distorted octahedra arternately centered by P₂ pairs and M³⁺ cations.

Solid solutions of the type $Bi_{1-X}Sb_XPQ_4$ possess a 3D three-dimensional structure related with the phase $BiPS_4$. The compound $Bi_{0.9}Sb_{0.1}PS_4$ is insulating with electrical conductivity $\sigma < 10^{-12}\,\Omega^{-1}\text{cm}^{-1}$ at room temperature. The d.c electric measurements indicate a behavior of photoconductive materials.

INDICE

1	Introducción	1
	1.1. Formulación general	1
	1.2. Antecedentes y estado actual de investigación	8
	1.3. Hipótesis	17
	1.4. Objetivo general	18
	1.5. Objetivos específicos	18
	2 Técnicas de caracterización y métodos experimentales	20
	2.1. Métodos preparativos	20
	2.1.1. Método Cerámico	20
	2.1.1.1. Reacciones con metales alcalinos	23
	2.1.2. Mezcla Fundente	24
	2.1.3. Línea de vacío y secado de gases	25
	2.1.4. Manipulación en atmósferas controladas	26
	2.1.5. Hornos	26
	2.1.6. Preparación de fases calcofosfato	27
	2.1.6.1. Preparación de A_2Q (A =Li, Na, K; Q = S, Se)	29
	2.1.6.2. Preparación de P ₄ Se ₁₀	30
	2.2. Caracterización	31
	2.2.1. Análisis elemental y microscopía electrónica de barrido	31

2.2.2. Técnicas de difracción de rayos X	32
2.2.2.1. Monocristales	32
2.2.2.2. Polvo Policristalino	32
2.2.3. Espectroscopia infrarroja	33
2.2.4. Análisis térmico	33
2.2.5. Susceptibilidad magnética	34
2.2.6. Conductividad eléctrica	34
3 Fases AMP ₂ Q ₆ (A = Li, Na, Cu, Ag, K; M = Bi, Sb y Q = S, Se)	36
3.1. Síntesis	36
3.1.1. Seleniodifosfatos AMP ₂ Se ₆ (A = Li, Na, K; M = Bi, Sb)	37
3.1.2. Tiodifosfatos AMP ₂ S ₆ (A = Li, Na, K; M = Bi, Sb)	40
3.1.3. Tiodifosfatos AMP ₂ S ₆ (A = Cu, Ag; M = Bi, Sb)	43
3.1.4. Seleniodifosfatos AMP ₂ Se ₆ (A = Cu, Ag; M = Bi, Sb)	46
3.2. Análisis elemental y microscopía electrónica MEB-EDX	48
3.2.1. Tiodifosfatos KMP_2S_6 (M = Bi, Sb) y $NaSbP_2S_6$	48
3.2.2. Seleniodifosfatos AMP ₂ Se ₆ (A = Cu, Ag; M = Bi, Sb)	51
3.3. Caracterización estructural y vibracional	53
3.3.1. Tiodifosfatos KMP ₂ S ₆ (M = Bi, Sb) y NaSbP ₂ S ₆	53
3.3.1.1. Análisis cristalográfico	53
3.3.1.2. Discusión estructural	55
3.3.1.2. Análisis polvo policristalino	61

3.3.2. Seleniodifosfatos AMP ₂ Se ₆ (A = Cu, Ag; M = Bi, Sb)	4
3.3.2.1. Discusión estructural 6	7
3.4. Propiedades magnéticas 7	' 0
3.5. Análisis térmico 7	'2
3.5.1. Tiodifosfatos KMP ₂ S ₆ (M = Bi, Sb)	′2
3.5.2. Seleniodifosfatos AMP ₂ Se ₆ (A = Cu, Ag; M = Bi, Sb)	73
3.6. Propiedades eléctricas	75
3.7. Cálculos teóricos	30
4 Fases A _{1-3X} Bi _{1+X} P ₂ Se ₆ (A = Cu, Ag) y CuBi _{1-X} Sb _X P ₂ Se ₆	84
4.1. Síntesis	84
4.1.1. Compuestos $A_{1-3x}Bi_{1+x}P_2Se_6$ (A = Cu, Ag; x = 0.1)	84
4.1.2. Compuestos CuBi _{1-X} Sb _X P ₂ Se ₆	85
4.2. Análisis elemental y microscopía electrónica MEB-EDX	86
4.2.1. Compuestos $A_{1-3X}Bi_{1+X}P_2Se_6$ (A = Cu, Ag; x = 0.1)	86
4.2.2. Compuestos CuBi _{1-X} Sb _X P ₂ Se ₆	87
4.3. Caracterización estructural y vibracional	89
4.3.1. Compuestos A _{1-3X} Bi _{1+X} P ₂ Se ₆ (A = Cu, Ag; x = 0.1)	89
4.3.2. Compuestos CuBi _{1-X} Sb _X P ₂ Se ₆	90
4.3.3. Discusión estructural	92
4.4. Ànálisis térmico	95
4.4.1. Compuestos A _{1-3x} Bi _{1+x} P ₂ Se ₆ (A = Cu, Ag; x = 0.1)	95

9 Referencias 161

INDICE DE TABLAS

3.1. Preparación de AMP ₂ Se ₆ (A = Li, Na, K) utilizando mezcla fundente	38
3.2. Preparación de AMP ₂ Se ₆ (A = Li, Na, K) para alta temperatura	39
3.3. Preparación de AMP $_2$ S $_6$ (A = Li, Na; M = Bi, Sb) a alta temperatura	41
3.4. Preparación de KMP ₂ S ₆ (M = Bi, Sb) para alta temperatura	42
3.5. Preparación de AMP $_2$ S $_6$ (A = Cu, Ag) utilizando mezcla fundente	44
3.6. Preparación de AMP ₂ S ₆ (A = Cu, Ag) para alta temperatura	46
3.7. Análisis elemental de las fases KMP ₂ S ₆	48
3.8. Análisis elemental de las fases AMP ₂ Se ₆ (A = Cu, Ag; M = Bi, Sb)	51
3.9. Datos cristalográficos de KBiP ₂ S ₆ (I) y KSbP ₂ S ₆ (II)	54
3.10. Distancias de enlace en KBiP ₂ S ₆	58
3.11. Distancias de enlace en KSbP ₂ S ₆	60
3.12. Constantes de red de las fases AMP ₂ S ₆	62
3.13. Bandas en el espectro de KMP ₂ S ₆ (M = Bi, Sb)	63
3.14. Constantes de red de las fases AMP ₂ Se ₆	65
3.15. Datos cristalográficos de Fe ₂ P ₂ S ₆	65
3.16. Temperatura,χ _M y μ _{eff} para el compuesto CuSbP ₂ Se ₆	71
3.17. Resistencia y capacitancia calculadas de las curvas de Nyquist	76
3.18. Conductividad a oscuras (σ_d) y fotoconductividad (σ_P)	78
3.19. Datos cristalográficos de CuCrP ₂ Se ₆	80

4.1. Análisis elemental de fases Cu _{0.7} Bi _{1.1} P ₂ Se ₆	86
4.2. Análisis elemental de CuBi _{1-X} Sb _X P ₂ Se ₆	88
4.3. Constantes de red de las fases A _{1-3X} Bi _{1+X} P ₂ Se ₆	89
4.4. Constantes de red de las fases CuBi _{1-X} Sb _X P ₂ Se ₆	91
4.5. Conductividad d.c. (σ _d) de CuBi _{1-X} Sb _X P ₂ Se ₆ a 303 K	98
5.1. Preparación de MPSe ₄ (M = Bi, Sb) para alta temperatura	102
5.2. Preparación de MPSe ₄ (M = Bi, Sb) utilizando mezcla fundente	102
5.3. Análisis elemental de Bi _{1-X} Sb _X PS ₄	104
5.4. Constantes de red de las fases Bi _{1-X} Sb _X PS ₄	106
5.5. Conductividad v energía activación en Bi _{1.x} Sb _x PS ₄	109

INDICE DE FIGURAS

1.1. Representación esquemática de sólidos con diferentes dimensiones	1
1.2. Estructura de la fase K ₂ FeP ₂ S ₆	10
1.3. Estructura del compuesto Fe ₂ P ₂ S ₆ y compuesto NaCeP ₂ Se ₆	11
1.4. Estructura de las fases NiPS ₄	12
1.5. Estructura de Na _{0.16} Bi _{1.28} P ₂ S ₆	13
1.6. Esquema de la incorporación de unidades A ₃ PS ₄	14
1.7. Estructura 2D del compuesto Cs ₈ M ₄ (P ₂ Se ₆) ₅	15
2.1. Transporte en fase gaseosa para el crecimiento de cristales	22
2.2. Doble ampolla de reacción	23
2.3. Línea de secado y línea de vacío-argón	25
2.4. Síntesis en amoniaco líquido	30
3.1. Imagen del material policristalino KBiP ₂ S ₆ y KSbP ₂ S ₆	48
3.2. Monocristal de KMP ₂ S ₆	50
3.3. Imagen del material policristalino para la fase CuBiP ₂ Se ₆	52
3.4. Estructura KBiP ₂ S ₆	55
3.5. Representación poliédrica del compuesto KBiP ₂ S ₆	56
3.6. Unidades en KBiP ₂ S ₆	57
3.7. Plano a-b y canal en KBiP ₂ S ₆	57
3.8. Estructura KSbP ₂ S ₆	59
3.9. Unidad básica del compuesto KSbP ₂ S ₆	60

3.10. DRX de poivo y FTIR de KMP ₂ S ₆	62
3.11. DRX de la fase: (a) CuBiP ₂ Se ₆ y (b) AgSbP ₂ Se ₆	64
3.12. Espectro Infrarrojo de: (a) AgSbP ₂ Se ₆ y (b) AgBiP ₂ Se ₆	66
3.13. Estructura fase 2D AMP ₂ Se ₆	67
3.14. Láminas del compuestos AMP ₂ Se ₆	68
3.15. Susceptibilidad magnética versus temperatura para CuSbP ₂ Se ₆	70
3.16. Curva análisis térmico ATD-ATG del compuesto KBiP ₂ S ₆	72
3.17. Curva análisis térmico ATD-ATG de AgBiP ₂ Se ₆	73
3.18. Diagrama de impedancia compleja CuBiP ₂ Se ₆ y AgBiP ₂ Se ₆	76
3.19. Fotoconducción en función del tiempo para CuBiP ₂ Se ₆	78
3.20. Dependencia de la temperatura: (a) fotoconductividad de $CuBiP_2Se_6 \dots$	79
3.21. Estructura CuBiP ₂ Se ₆	81
3.22. Esquema simplificado del diagrama de bandas de CuBiP ₂ Se ₆	82
4.1. Imagen del material policristalino A _{0.7} Bi _{1.1} P ₂ Se ₆	87
4.2. Imagen del material policristalino CuBi _{0.8} Sb _{0.2} P ₂ Se ₆	88
4.3. DRX y Espectro de A _{0.7} Bi _{1.1} P ₂ Se ₆	89
4.4. DRX y espectro de la solución sólida CuBi _{0.9} Sb _{0.1} P ₂ Se ₆	90
4.5. Estructura de CuBi _{1-X} Sb _X P ₂ Se ₆	92
4.6. Láminas de CuBi _{1-X} Sb _X P ₂ Se ₆	93
4.7. Representación de los compuestos tipo A _{0.7} Bi _{1.1} □ _{0.2} P ₂ Se ₆	94
4.8. Curva análisis térmico ATD-ATG de CuBi _{1-x} Sb _x P ₂ Se ₆	96

4.9. Curva Voltaje v/s intensidad de corriente A _{0.7} Bi _{1.1} P ₂ Se ₆	97
4.10. Diagrama de impedancia compleja y de Nyquit (a) CuBi _{0.9} Sb _{0.1} P ₂ Se ₆	99
5.1. Imagen del material Sb, P y S	105
5.2. Diagrama de polvo de rayos x de Bi _{1-X} Sb _X PS ₄	106
5.3. Estructura 3D BiPS ₄	107
5.4. Unidades del compuesto BiPS ₄	108
5.5. Conductividad versus temperatura Bi _{0.9} Sb _{0.1} PS ₄ y BiPS ₄	110
6.1. Esquema de la preparación de compuestos AMP ₂ Se ₆	112
6.2. Esquema de la preparación de AMP ₂ S ₆ (A = Cu, Ag; M = Bi, Sb)	113
6.3. Esquema de la preparación de MPSe ₄	114
6.4. Equilibrios de formación entre diferentes aniones calcofosfato	115
6.5. Estructura de los octaedros	117
6.6. Estructura de los M ₂ P ₂ Q ₆ en donde se indica el eje trigonal	118

GLOSARIO DE SIGLAS Y ABREVIATURAS

SIGLAS	SIGNIFICADO ESPAÑOL
1D	Unidimensional
2D	Bidimensional
3D	Tridimensional
ATD	Análisis térmico diferencial
ATG	Análisis térmico gravimétrico
DRX	Difracción de rayos X
MEB	Microscopía electrónica de barrido
EDX	Energía dispersiva de rayos X
FTIR	Espectroscopia infrarroja con transformada de Fourier
σ	Conductividad eléctrica
a.c.	Corriente alterna
d.c.	Corriente directa
χ	Susceptibilidad magnética
ES	Electrones secundarios
ER	Electrones retrodispersados
DMF	Dimetilformamida
TRPEV	Teoría de repulsión de pares electrónicos de valencia
MB	Magnetones de Bohr
Ef	Energía de Fermi

1 Introducción

1.1. Formulación General

Calcofosfatos del tipo $AM_xP_yQ_z$ (A = metales alcalinos, M = metales de transición y Q = S, Se), son materiales que presentan aniones $[P_yQ_z]^{n-1}$ coordinados a los metales A y M a través de los átomos de calcógeno Q [1-2]. Estos sólidos poseen diferentes ordenamientos espaciales, presentando estructuras de tipo monodimensional 1D, bidimensional 2D y tridimensional 3D (Figura 1.1).

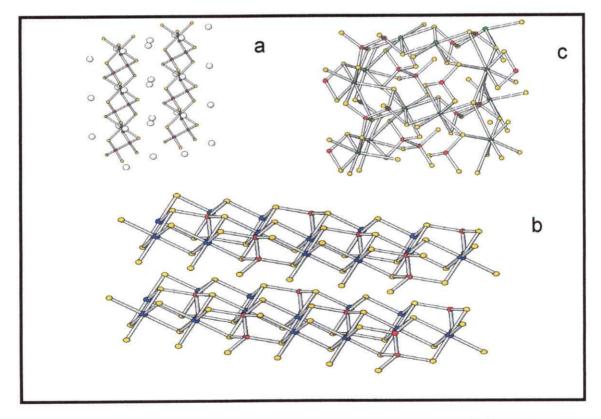


Figura 1.1. Estructuras de sólidos que contiene aniones calcofosfato $[P_yQ_z]^{n-}$: (a) KFeP₂S₆ 1D,(b) FePS₃ 2D y (c) β -Bi₄(P₂Se₆)₃ 3D

El estudio de estos materiales ha recibido una fuerte atención en la última década debido a sus especiales características estructurales y físicas [1,3-5]. Desde el punto de vista de ciencia básica, este interés es debido a que presentan propiedades físicas anisotrópicas, tales como propiedades eléctricas, termoeléctricas y ópticas. Además, se ha observado que compuestos que poseen aniones tipo calcofosfato, presentan coordinaciones inusuales. Esto es debido a que los centros metálicos pueden formar múltiples enlaces con los átomos de calcógeno Q. Además del interés académico, una fuerte motivación se debe a que existen aspectos de importancia tecnológica [6-8]. Estos compuestos presentan aplicaciones como materiales termoeléctricos y en

Fases estables con aniones calcofosfato y policalcogenuro tipo $[P_yQ_z]^{n-}$ y $[Q_z]^{2-}$ pueden ser formadas por el método cerámico a alta temperatura (reacciones sólido-sólido o por transporte de vapor) y métodos a baja temperatura (solventotermales y mezcla fundente) [11-12]. Las reacciones se realizan en ampollas de cuarzo selladas a presión reducida de argón. Las ampollas son sometidas a distintos tratamientos térmicos, dependiendo de las fases que se desea obtener.

dispositivos electro-ópticos [6a, 6b, 9-10].

El método cerámico a alta temperatura consiste en la reacción en estado sólido, en combinación directa de cantidades estequiométricas de sus

elementos puros, en gradientes de temperatura o por utilización de agentes transportadores en fase gas (transporte de vapor). Las reacciones a alta temperatura permiten la formación de fases calcofosfato con baja incorporación de calcógeno en la estructura; favoreciendo la obtención de calcofosfatos y policalcogenuros tipo $[P_yQ_z]^{n-}$ y $[Q_z]^{2-}$ (y =1,2; Z = 1,2,3,4).

Los métodos solventótermales consisten en la reacción de los precursores adecuados en solución. Las condiciones de síntesis son a presiones y temperaturas supercríticas de los solventes utilizados (agua, amoniaco, etanol, etilendiamina). Este tipo de reacciones necesitan periodos de tiempo mas cortos (horas) qué las reacciones sólido-sólido (Semanas). Sin embargo, la posibilidad de obtener fases puras es muy baja, debido a que no es posible controlar la formación de un solo producto de reacción.

Métodos de síntesis a baja temperatura (mezcla fundente), permiten la obtención de una gran variedad de aniones calcofosfato $[P_2S_6]^{4-}$, $[P_2Se_6]^{4-}$, $[PS_4]^{3-}$ y $[P_2Q_7]^{4-}$ [1]. Este tipo de aniones se presentan en compuestos tales como $K_2Fe_2P_2S_6$, $CuCrP_2Se_6$, $Cu_{0.4}Ce_{1.2}P_2Se_6$, $K_3Bi(PS_4)_2$ y $KBiP_2S_7$, entre otros. El método de la mezcla fundente consiste en la reacción entre el metal y una mezcla de punto de fusión mínimo A_2Q/Q ó $A_2Q/P_2Q_5/Q$ (A =metales alcalinos, Q = S, Se). Esta mezcla fundente cumple dos funciones: medio de reacción (movilidad) y reactivo, ayudando a la formación y cristalización de los

compuestos obtenidos. Este método permite la formación de nuevas fases por control de las cantidades del metal M, A_2Q , P_2Q_5 , Q y la temperatura de reacción.

Actualmente, compuestos tio- y selenofosfatos ternarios han sido extensamente estudiados e informados en literatura [1,5-6]. Estos son predominantemente fases tipo $M_2P_2Q_6$ (M = metal divalente); las cuales contienen el anión tipo etano $[P_2Q_6]^{4-}$ en su estructura [13-15]. En la síntesis de estas fases se han observado complejos equilibrios entre especies tales como $[P_2Q_6]^{4-}$; $[P_2Q_6]^{2-}$; $[P_2Q_7]^{4-}$ y $[PQ_4]^{3-}$ (Q = S, Se) [16].

El estudio de fases calcofosfato de metales del grupo 15 (Bi y Sb) presenta gran interés. El Bismuto en estado de oxidación +3 pueden manifestar sus electrones s^2 (efecto de pares inertes) en la estructura [17-19]. Los pares de electrones pueden influir en la estereoquímica de los enlaces M-Q (M = Bi, Sb; Q = S, Se), presentando una distribución que no es simétricamente esférica. Esto produce distorsión de la coordinación del ión metálico M^{3+} . Además, cuando estos pares forman uniones, conducen a coordinaciones inusuales. Por ejemplo, en compuestos tales como $K_3Bi(PS_4)_2$ y β -KSbP $_2$ Se $_6$ se observa que el Bi ó el Sb poseen una coordinación octaédrica altamente distorsionada. En los compuestos $BiPS_4$ y β - $Bi_4[P_2Se_6]_3$, el Bismuto posee coordinación cho BiS_8 .

Fases sólidas y aleaciones de calcogenuros de Bismuto y Antimonio, tales como Bi_{2-x}Sb_xTe_{3-y}Se_y, poseen aplicaciones tecnológicas. Estas fases son utilizadas como materiales termoeléctricos a temperatura ambiente. Además se sabe que calcogenuros basados en modificaciones estructurales de Sb₂Q₃ y Bi₂Q₃ (Q = Se, Te) poseen alta conductividad eléctrica y termoelectricidad [18, 20,21].

La preparación y caracterización de nuevos sólidos con Bismuto y Antimonio ofrece amplias posibilidades para conseguir materiales con nuevos ordenamientos estructurales. Un aspecto que no ha sido desarrollado en los sistemas tipo AM_xP_vQ_z es determinar la influencia del metal A en las propiedades físicas y su relación con la dimensionalidad. La gran mayoría de las fases reportadas en literatura poseen cationes alcalinos de gran tamaño (Potasio, Rubidio, Cesio). Debido a esto, la síntesis con cationes más pequeños (Litio, Sodio, Cobre, Plata) permitirá establecer la influencia del tamaño del catión en la estabilización de las fases calcofosfato y su efecto en las propiedades eléctricas. Las propiedades eléctricas de compuestos estabilizados con aniones calcofosfato han sido poco estudiadas. Sólo se posee información acerca de propiedades eléctricas de compuestos M₄(P₂Se₆)₃ y Cs₈M₄(P₂Se₆)₅ (M = Bi, Sb). Estos compuestos son aislantes con valores de conductividad $\sigma \approx 10^{-8} - 10^{-9} \ \Omega^{-1} \text{cm}^{-1}$ [22]. La utilización de cobre y plata como cationes A (cationes propuestos en esta tesis), permitirá estudiar la influencia de metales

de transición en las propiedades de los compuestos calcofosfato y su comparación con fases estabilizadas por cationes de metales alcalinos.

El objetivo general de este trabajo de tesis es preparar nuevas fases calcofosfato con aniones $[PQ_4]^{3-}$ y $[P_2Q_6]^{4-}$ (Q = S, Se), que presenten características de semiconductores eléctricos. Además, se espera evaluar la influencia del metal A⁺ en las propiedades físicas y en la dimensionalidad de las fases sólidas. Se propone realizar una investigación sistemática de la síntesis, características estructurales y propiedades eléctricas de compuestos tipo $A^+M^{3+}P_2Q_6$ (A = Li, Na, K, Cu, Ag; M = Bi, Sb), $A^+_{1-3x}Bi^{3+}_{1+x}P_2Se_6$ (A = Cu, Ag; x = 0.1;0.2), $Cu^+Bi^{3+}_{1-x}Sb^{3+}_{x}P_2Se_6$ (x = 0.1-0.9) y $Bi^{3+}_{1-x}Sb^{3+}_{x}PQ_4$ (x = 0.1-1.0) estabilizados por los aniones calcofosfato $[P_2Q_6]^{4-}$ y $[PQ_4]^{3-}$ (Q = S, Se).

Se realizará un estudio de las condiciones y método de síntesis en la preparación de nuevas fases cristalinas. La síntesis a alta temperatura se utilizará para la preparación de calcofosfatos estabilizados por el anión $[PQ_4]^3$. El método de la mezcla fundente se utilizará en la formación calcofosfatos estabilizados por el anión $[P_2Q_6]^4$.

Se propone el estudio de la influencia del método de síntesis en la preparación de los aniones $\left[P_2Q_6\right]^4$ y $\left[PQ_4\right]^3$. Además, se espera establecer el

efecto del calcógeno (S \rightarrow Se), presente en los aniones $[P_2S_6]^4$, $[P_2Se_6]^4$, $[PS_4]^3$ y $[PS_4]^3$, en los ordenamientos estructurales y propiedades eléctricas.

Se realizará un estudio de las condiciones de formación de fases bimetálicas, que posean los cationes Bi^{3+} y Sb^{3+} . En analogía a las fases $Bi_{2-x}Sb_xTe_{3-y}Se_y$, $CsBiSe_6$ y $K(Bi_{2-x}Sb_x)Se_z$, se espera obtener compuestos que poseen alta conductividad eléctrica.

El Litio, Sodio y Potasio se utilizarán para determinar si el tamaño del catión es capaz de producir una transformación estructural.

Catión	Radio (Å)	Catión	Radio (Å)
K ⁺	1.33	Ag ⁺	1.26
Na⁺	0.98	Cu ⁺	0.98
Li ⁺	0.60		====

Finalmente, debido a que los cationes Ag⁺ y Cu⁺ poseen tamaños similares a los cationes K⁺ y Na⁺, se utilizarán para determinar la influencia de los metales de transición en las propiedades eléctricas y estructurales.

1.2. Antecedentes y estado actual de la investigación

Calcofosfatos del tipo M2P2S6 y MPS4 son preparados por métodos cerámicos para alta temperatura y presentan el anión [P₂S₆]⁴⁻ y el anion [PS₄]³⁻ en su estructura. Estos materiales poseen propiedades físicas con aplicaciones tecnológicas. Sn₂P₂S₆ cristaliza en el grupo espacial Pc y tiene una transición de fase exotérmica a 60 °C [23]. La transición es de un comportamiento ferroeléctrico (Pc) a paraeléctrico (P21/c). Esta propiedad lo identifica como un prometedor material para uso en dispositivos de memoria electrónica [24]. La fase InPS4 cristaliza en el grupo espacial tetraédrico nocentrosimétrico I-4 y tiene una alta susceptibilidad óptica no-linear [25]. BiPS4 presenta estructura tridimensional 3D v posee propiedades piezo-eléctricas [26].

Entre los compuestos que poseen el anión tíofosfato [P2S6]4- se encuentran los M₂P₂S₆ de estructura laminar. El metal M se encuentra en estado de oxidación 2+ (M = Mn, Cd, Fe, Zn y Ni). Estas fases cristalizan en el grupo espacial monoclínico C2/m, en un empaquetamiento cúbico compacto distorsionado de átomos de azufre [27-29]. Los átomos metálicos M y los pares P-P ocupan huecos octaédricos distorsionados en una relación 2:1. Las capas están formadas de unidades [P2S6]4 coordinadas al catión M2+.

La investigación en las fases M2P2S6 ha sido orientada a estudiar la capacidad de intercalar especies como litio y moléculas cromóforas; logrando obtener compuestos adecuados para ser utilizados en baterías secundarias de litio y en óptica no-lineal [30]. Un aspecto relevante de la intercalación en estas fases [31-35], son los cambios en las propiedades magnéticas del material, como es la transición desde un comportamiento antiferromagnético a ferromagnético: producto de la inserción de la especie huésped [36, 37a, 38-40].

Fases cuaternarias tipo MM'P2S6, que contienen el anión [P2S6]4, poseen estructuras 2D y 1D [41,42]. Estos compuestos pueden ser formados por sustitución catiónica homocarga o heterocarga; donde el anión [P₂S₆]⁴⁻ se distorsiona de manera adecuada para estabilizar cationes en diferentes estados de oxidación. Ejemplos de la sustitución heterocarga son las fases $M^{2+}_{2-2x}M^{-1+}_{4x}P_2S_6$ y $M^{3+}M^{-1+}P_2S_6$. Los compuestos $Mn^{2+}_{2-2x}M^{-1+}_{4x}P_2S_6$ (M' = Cu, Ag; x = 0.1 y 0.2) y $Cu^{1+}Cr^{3+}P_2S_6$ [43-44], pueden ser vistos como una sustitución del catión M2+, ubicado en un sitio octaédrico en la fase M2P2S6 (ver Figura 1.2a), por dos cationes M y M' en diferentes estados de oxidación (M²⁺M⁻¹⁺ ó M¹⁺M⁻³⁺). La fase V_{1.56}P₂S₆ presenta dos estados de oxidación del vanadio en su estructura (V2+ y V3+). Por sustitución de la mitad de los átomos de V²⁺, por un catión M¹⁺, se obtienen compuestos de estructura 2D, tales como $Ag^{1+}V^{3+}P_2S_6$, $Cu^{1+}V^{3+}P_2S_6$ y $Rb^{1+}V^{3+}P_2S_6$ [45-47]. Selenuros tipo $M^{1+}M'^{3+}P_2Se_6$ (M = Cu, Aq; M' = Cr, Al, Ga) retienen la estructura tipo Fe₂P₂S₆, en donde los cationes M^{1+} y M^{*3+} ocupan las mismas posiciones cristalográficas (distribución estadística). Sin embargo, cuando el catión es de mayor tamaño, la estructura se puede modificar [41]. Por ejemplo, La estructura de las fases $K_2MP_2S_6$ (M=Mn, Fe) puede ser vista como una modificación del compuesto de la estructura del compuesto $Fe_2P_2S_6$ [48,49]. La estructura bidimensional de $Fe_2P_2S_6$, es reemplazada por un ordenamiento monodimensional de $K_2MP_2S_6$, constituido por columnas tipo $[-P_2S_6^{-4}-M^{2+}-P_2S_6^{-4-}]$ (Figura 1.2). Esta modificación puede ser explicada debido a que la sustitución del catión divalente M^{2+} , ubicado en el sitio octaédrico del compuesto $Fe_2P_2S_6$, por 2 cationes monovalentes K^+ , produce la formación de las cadenas como consecuencia del desplazamiento de los cationes K^+ hacia caras opuestas del octaedro FeS_6 .

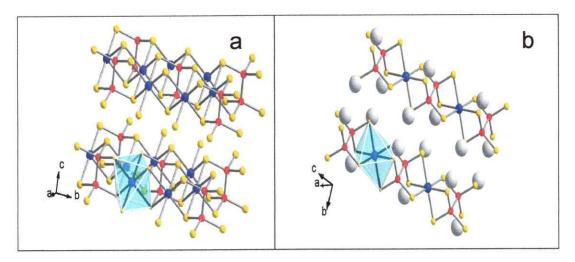


Figura 1.2. Estructura de la fase $K_2FeP_2S_6$: (a) estructura del compuesto $Fe_2P_2S_6$ b) Representación estructural de $K_2FeP_2S_6$ K^{\odot} , Fe^{\odot} , P^{\odot} , S^{\odot} .

Selenodifosfatos del tipo $M^{1+}Ce^{3+}P_2Se_6$ (M=Na, Ag), $Ce^{3+}_4(P_2Se_6)_3$ y $Cu^+_{0.4}Ce^{3+}_{1.2}P_2Se_6$ presentan estructuras relacionadas con la familia de compuestos $KLnP_2Se_6$ (Ln=Lantánidos) [50]. La estructura de $NaCeP_2Se_6$ puede ser derivada del compuesto $Fe^{2+}_2P_2S_6$ (tipo monoclinico-I), por la condensación de dos láminas $Fe_2P_2S_6$ y la remoción de la mitad de los átomos dispuestos en los espacios octaédricos (ver Figura 1.3). La esfera de coordinación del metal se expande y los aniones $[P_2Se_6]^{4-}$ se deforman durante la condensación. La Figura 1.3 muestra la estructura laminar de $Na^+Ce^{3+}P_2Se_6$. Los cationes Ce^{3+} presentan coordinación nueve ($CeSe_9$) y los cationes Na^+ se encuentran ubicados entre las láminas en una estructura bidimensional 2D.

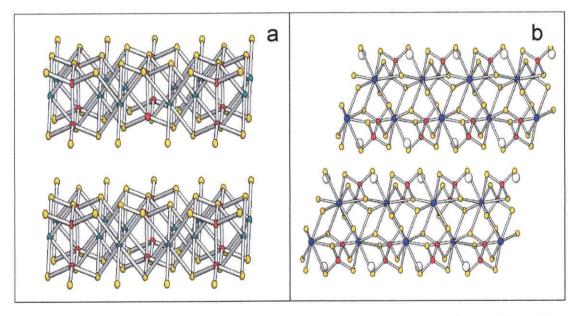


Figura 1.3. a) Estructura del compuesto $Fe_2P_2S_6$ (monoclinico-I) \bullet Fe, \bullet P, \bullet S. b) Compuesto NaCeP₂Se₆ \circ Na, \bullet Ce, \bullet P, \bullet Se.

El compuesto Cu_{0.4}Ce_{1.2}P₂Se₆ es similar a NaCeP₂Se₆. Sin embargo, este compuesto es tridimensional 3D debido a que los átomos de Ce y Cu,

reemplazan las posiciones de los átomos de Na conectando las láminas. La coordinación de los átomos de Ce en este compuesto es ocho (CeSe₈). $Ce_4(P_2Se_6)_3$ adopta una estructura 3D relacionada con la estructura de los compuestos ($M^{2+})_2P_2Q_6$, con M=Pb, Sn, Sr, Ba Ca y Q=S, Se (tipo monoclínico-II). En este caso el metal M^{2+} es reemplazado por el catión Ce^{3+} creándose vacancias en la red. Esto fenómeno estructural, puede ser explicado debido a que para mantener la electroneutralidad de la red, se necesitan dos cationes Ce^{3+} por cada tres cationes M^{2+} sustituidos.

Otro arreglo estructural se presenta en la fase KNiPS₄ [51]. El catión Ni²⁺ se encuentra rodeado con cuatro átomos de azufre, en un entorno cuadrado plano. Las unidades NiS₄ se encuentran unidas por grupos tetraédricos PS_4^{3-} , formando cadenas tipo [- PS_4^{3-} - Ni^{2+} - PS_4^{3-} -] (Ver Figura 1.4).

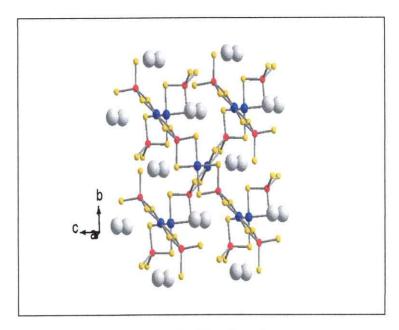


Figura 1.4. Estructura de KNiPS₄.

K;

Ni

P

S.



Fases calcofosfatos cuaternarias del tipo $AM[P_xQ_y]$ (A = metales alcalinos, M = Sb, Bi; Q = S, Se), forman una clase de materiales sólidos con interesantes propiedades estructurales. Los primeros calcofosfatos cuaternarios de Bi y Sb informados en literatura fueron $A_3M[PS_4]_2$ (A = K, Rb, Cs; M = Sb, Bi), $Cs_3Bi_2[PS_4]_3$ y $Na_{0.16}Bi_{1.28}[P_2S_6]$ [52]. En la estructura 2D de $K_3Bi(PS_4)_2$ el Bi posee una coordinación octaédrica altamente distorsionada (pares inertes), presentando cuatro enlaces y dos interacciones a larga distancia. En $Na_{0.16}Bi_{1.28}[P_2S_6]$, la mínima incorporación de Na^+ en la estructura, resulta en la formación de una fase tridimensional (3D); la cual requiere que los aniones $[P_2S_6]^{4-}$ se encuentren unidos a los centros metálicos con coordinación ocho $Bi^{3+}S_8$ (Figura 1.5).

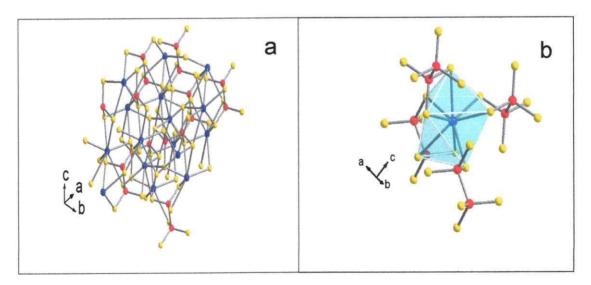


Figura 1.5. Estructura de $Na_{0.16}Bi_{1.28}P_2S_6$. a) Estructura 3D. b) Unidades estructurales donde se muestra la coordinación del Bismuto. lacktriangle M lacktriangle P locktriangle S (M = Na, Bi).

Las estructuras de los compuestos $A_3M[PS_4]_2$, $Cs_3Bi_2[PS_4]_3$ y $Na_{0.16}Bi_{1.28}[P_2S_6]$ pueden ser relacionadas con la estructura del compuesto $BiPS_4$. La red laminar 2D $Bi_2[PS_4]_3^3$ pueden ser vistas como una distorsión de la red 3D de $BiPS_4$ al incorporar una unidad A_3PS_4 (Figura 1.6).

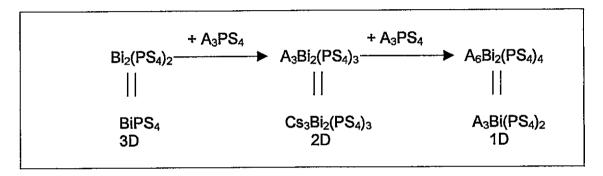


Figura 1.6. Esquema de la incorporación de unidades A₃PS₄.

Del mismo modo, las cadenas seudo-helicoidales no-centrosimétricas 1D $Bi[PS_4]_2^{3-}$, pueden ser vistas como una distorsión de la red 2D $Bi_2[PS_4]_3^{3-}$ por la incorporación de una unidad A_3PS_4 .

Selenodifosfatos ternarios que contienen Bi y Sb, han sido sintetizados por reacción en estado sólido de sus elementos a temperaturas entre 400 y 550 °C. Las fases α -M₄[P₂Se₆]₃ (M = Bi, Sb) presentan una estructura cristalina relacionada con el compuesto Pb₂[P₂Se₆] (tipo monoclinico-II). Mientras que, en la fase β -Bi₄[P₂Se₆]₃ la estructura tipo monoclínico-II se rompe debido a la coordinación del Bismuto (BiSe₈) [53,54].

Selenodifosfatos cuaternarios α -KMP $_2$ Se $_6$, β -KMP $_2$ Se $_6$ y Cs $_8$ M $_4$ (P $_2$ Se $_6$) $_5$ (M = Bi, Sb) han sido sintetizados por el uso de métodos de preparación para baja y alta temperatura [55-57]. Las fases sólidas α -KMP $_2$ Se $_6$ (M=Sb,Bi) contiene el anión [P $_2$ Se $_6$] 4 y poseen estructura laminar 2D con capas MP $_2$ Se $_6$, en donde el metal M se encuentra hexacoordinado. Las fases β - poseen estructura 2D y cristalizan en el grupo espacial quiral P2 $_1$ con grupos tipo etano P $_2$ Se $_6$ 4 . Las fases α -KMP $_2$ Se $_6$ son termodinámicamente estables y las β -KMP $_2$ Se $_6$ son cinéticamente estables. Las fases β - son productos de una cristalización cinética y se transforman en compuestos termodinámicamente estables (fases α -) por tratamientos a elevadas temperaturas (>500°C). Los compuestos Cs $_8$ M $_4$ (P $_2$ Se $_6$) $_5$ (M=Sb, Bi) poseen estructura 2D y presentan interacciones débiles M···M [57].

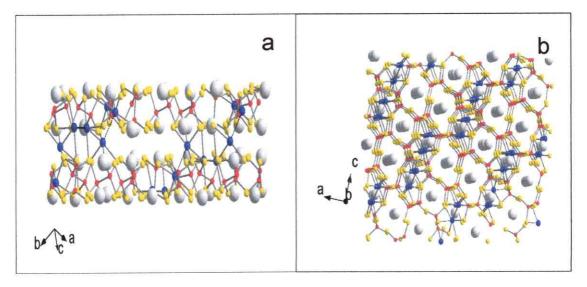


Figura 1.7. Estructura del compuesto $Cs_8Sb_4(P_2Se_6)_5$: a) Estructura laminar, b) Vista [010] de los canales. $^{\circ}$ Cs $^{\circ}$ Sb $^{\circ}$ P $^{\circ}$ Se .

La Figura 1.7 muestra la estructura laminar de estas fases. Una vista de la cara **ac** (ver Figura 1.7b), muestra que estos compuestos poseen canales. Los cationes Cs^+ se ubican en los canales, ocupando posiciones en las láminas de la red (Figura 1.7 a). Medidas de conductividad eléctrica, realizadas en $Cs_8M_4(P_2Se_6)_5$, indican comportamiento de aislantes eléctricos con valores de conductividad $\sigma \approx 10^{-9}$ S/cm a temperatura ambiente.

1.3 Hipótesis de Trabajo

- 1.3.1. El uso de métodos de síntesis cerámica, para alta temperatura, permite la obtención de fases del tipo $AM_X[PQ_4]$ (A = Sb; M = Bi, Sb), estabilizadas por los aniones calcofosfatos $[PQ_4]^{3-}$ (Q = S, Se). La utilización de mezcla fundente, permite la formación de nuevas fases del tipo $AM[P_2Q_6]$ (A = Cu, Ag, Li, Na, K y Sb; M = Bi, Sb), con aniones calcofosfato $[P_2Q_6]^{4-}$ (Q = S, Se).
- 1.3.2. Los compuestos $AM[P_2Q_6]$ (M = Bi, Sb) presentan estructura bidimensional, independiente del radio iónico del metal A (A = Cu, Ag, Li, Na y K). El anión tipo $[PQ_4]^3$, favorece la formación de compuestos tipo $Bi_{1-x}Sb_x[PQ_4]$ con estructura tridimensional 3D.
- 1.3.3. La utilización de metales de transición como cationes A^+ (A = Cu, Ag), permite un aumento de la conductividad eléctrica de compuestos $AM[P_2Q_6]$ (M=Bi, Sb) respecto de los estabilizados con metales alcalinos tipo $Cs_8M_4[P_2Se_6]_5$.

1.4. Objetivo general

La idea central que inspira esta tesis es preparar materiales estables con nuevos ordenamientos estructurales. De este modo, se espera obtener fases sólidas con variaciones en las propiedades eléctricas respecto de las fases conocidas. Se propone la preparación de compuestos que presenten características de semiconductores eléctricos.

1.5. Objetivos específicos

- 1.5.1.- Preparación de nuevas fases cristalinas basadas en los sistemas tipo A $^{+}$ M $^{3+}$ P $_{2}$ Q $_{6}$ (A = Li, Na, K, Cu, Ag; M = Bi, Sb), A $^{+}$ _{1-3X}Bi $^{3+}$ _{1+X}P $_{2}$ Se $_{6}$ (A = Cu, Ag; x = 0.1 y 0.2), Cu $^{+}$ Bi $^{3+}$ _{1-X}Sb $^{3+}$ _XP $_{2}$ Se $_{6}$ (x = 0.1; 0.2; 0.3) y Bi $^{3+}$ _{1-X}Sb $^{3+}$ _XPQ $_{4}$ (x = 0.1; 0.2; 0.3 y 1) estabilizados por los aniones calcofosfato [P $_{2}$ Q $_{6}$] $^{4-}$ y [PQ $_{4}$] $^{3-}$ (Q = S, Se). Se trata de evaluar si la combinación de tales elementos puede ser adecuada para obtener nuevas fases estables.
- 1.5.2. La caracterización y estudio de las propiedades eléctricas de las nuevas fases cristalinas.
- 1.5.2.1. Análisis elemental (MEB-EDX, ICP-Plasma) y caracterización espectroscópica (FTIR): Determinación de homogeneidad, pureza y

estequiometría de los productos de síntesis. Identificación de señales asignadas a la presencia de aniones calcofosfato en la estructura.

- 1.5.2.2. Análisis térmico simultáneo (ATD-ATG): Estudio de estabilidad térmica y posibles transiciones de fases.
- 1.5.2.3. Métodos de difracción: Determinación de los parámetros reticulares en orden a obtener evidencias de la estructura y formación de fases nuevas. Determinación de la estructura cristalina por difracción de rayos X en monocristales.
- 1.5.2.4. Estudio de las propiedades eléctricas: Medición de conductividad eléctrica a corriente alterna (Impedancia compleja), corriente directa y foto corriente de los compuestos obtenidos.

2 Técnicas de caracterización y métodos experimentales

2.1. Métodos Preparativos

2.1.1. Método cerámico

El método cerámico a alta temperatura (600-1000 °C), consiste en la reacción en estado sólido de sus elementos y precursores. Debido a esto, los tiempos de reacción necesarios son entre dos semanas y un mes. Las reacciones se realizan en ampollas de cuarzo selladas a presión reducida y atmósfera inerte (argón seco y libre de oxígeno). Para obtener compuestos puros, se homogenizan los productos de reacción (en atmósfera inerte) y se depositan en ampollas de cuarzo (selladas a presión reducida), para realizar nuevos tratamientos térmicos. Enfriamientos programados (50-20 °C/hora) permiten la obtención de material cristalino.

El método a alta temperatura posee dos variantes: a) combinación directa de sus elementos, b) utilización de agentes transportadores en gradientes de temperatura:

a) La combinación directa se realiza mezclando los elementos puros en polvo o precursores en cantidades estequiométricas. Dependiendo de los materiales a formar, se pueden agregar los precursores en exceso, para lograr

que la reacción sea estequiométrica. Los precursores deben ser solubles en solventes adecuados, para posteriormente purificar los productos de reacción. Otra posibilidad, es eliminar las sustancias en exceso a través de calentamientos a presión reducida. Esto procedimiento permite la sublimación de las impurezas o de los agentes en exceso.

Las reacciones se realizan en ampollas tubulares de cuarzo de aproximadamente 9 cm de largo y 2 cm de diámetro interno. La temperatura del sistema permanece constante durante el tiempo de reacción y se realiza homogenización de los productos para obtener materiales puros.

b) El método de transporte químico vía agentes en fase vapor, es utilizado para crecimiento de cristales o purificación de compuestos. Básicamente, el método consiste en un tubo, usualmente de cuarzo, donde se deposita el ó los reactante(s) A y el agente transportador B. El agente B debe estar en fase gaseosa a la temperatura de síntesis. El (los) reactante(s) A y el agente transportados B pueden ubicarse juntos ó separadamente en los dos extremos de la ampolla de reacción (Figura 2.1). En algunos casos, se favorece el crecimiento de cristales, cuando los precursores son depositados en los extremos de la ampolla de reacción. En estas condiciones, al menos uno de los precursores debe estar en fase gaseosa a la temperatura de reacción. Los materiales A y B reaccionan, para posteriormente depositarse y cristalizar al final del tubo. El proceso de la figura 2.1b, muestra el transporte del material (A) a lo largo del tubo de reacción.

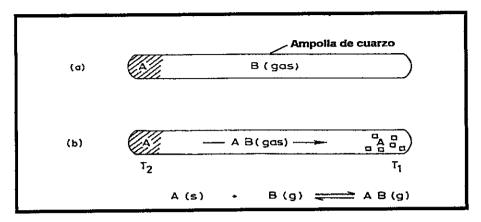


Figura 2.1. Transporte en fase gaseosa para el crecimiento de cristales de la fase A. La etapa a y b, ilustran el proceso de preparación y cristalización de la sustancia A por gradiente de temperatura, entre una zona caliente T2 y una zona fría T1.

En términos generales, se puede describir el método de transporte como una reacción acoplada del agente transportador B con los reactivos A y C, en gradiente de temperatura:

 $A_{(s)} + B_{(q)} \Leftrightarrow AB_{(q)}$ Para T₂:

 $AB_{(g)} + C_{(s)} \Leftrightarrow AC_{(s)} + B_{(g)}$ Para T₁:

 $A_{(s)} + C_{(s)} \Leftrightarrow AC_{(s)}$ Reacción Global:

Algunos agentes utilizados son el yodo y el cloruro de teluro. Las ampollas tubulares de cuarzo son de aproximadamente 16-18 cm de largo y entre 1.0 -1.5 cm de diámetro interno. El tamaño adecuado se obtiene luego de realizar la calibración del gradiente de temperatura del horno. Típicamente el gradiente es de aproximadamente 50 °C a lo largo de la ampolla de reacción. La purificación de los productos se realiza por calentamiento entre 100-150 °C por 48 horas a presión reducida.

2.1.1.1. Reacciones con Metales alcalinos

Representa una gran dificultad técnica trabajar con metales alcalinos para altas temperaturas. Estos metales debilitan las ampollas de reacción, aumentando la posibilidad de explosiones y fisuras. Para poder mantener por largos periodos de reacción los elementos puros (metales alcalinos, fósforo, selenio, azufre, bismuto y antimonio), se recubrió el interior de las ampollas de reacción con carbón. Este recubrimiento impide la reducción del dióxido de silicio; componente fundamental de las ampollas de reacción. Otra forma de evitar las explosiones, es la utilización de una doble ampolla de reacción (Figura 2.2).

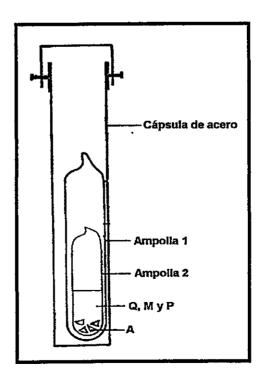


Figura 2.2. Doble ampolla de reacción. La ampolla 2 está cubierta con carbón en el interior. La ampolla 1 y 2 están selladas a presión reducida de argón. El metal alcalino A es ubicado entre la mezcla del calcógeno Q (S ó Se), M (Bi ó Sb) y el fósforo (P).

La dobla ampolla consiste en colocar una ampolla de reacción dentro de otra ampolla de reacción. Cada una de ellas es sellada a presión reducida de argón. De esta manera, si se rompe la ampolla 2 de reacción, los elementos y precursores se mantienen libres de la acción del aire (ver Figura 2.2). Las reacciones se mantiene por largos períodos de tiempo (21 días) para descartar factores difusionales en la síntesis.

2.1.2. Mezcla Fundente

El método de la mezcla fundente consiste en la reacción entre los precursores y una mezcla de punto de fusión mínimo (A₂Q/ P₂Q₅/Q ó P₂Q₅/Q; Q = S, Se y A = Metales alcalinos). Esta mezcla actúa como reactivo en exceso, permitiendo que todo el metal M reaccione completamente (reactivo limitante). Las reacciones se realizan en ampollas de cuarzo selladas a presión reducida y atmósfera inerte (argón seco y libre de oxígeno).

Los productos de reacción son obtenidos por control de las cantidades molares del metal M, A₂Q, P₂Q₅, Q y la temperatura de reacción. Los periodos de reacción utilizados son entre 4 a 6 días. Después de completada la reacción, los productos son tratados con solvente adecuados (Etanol, metanol, DMF) para extraer el exceso del fundente $A_x P_y Q_z$ ó $P_y Q_z$. Se utiliza Éter etílico para limpiar y secar los productos obtenidos.

2.1.3. Línea de vacío y secado de gases

Se utilizó una línea que consta de las siguientes partes: línea de secado y línea de vacío-argón. Línea de secado de gases (ver Figura 2.3), consta de una columna con catalizador de cobre (BTS), una columna con tamices moleculares y una columna con pentóxido de fósforo (P2O5). La columna con catalizador de cobre tiene la función de fijar el oxígeno presente en el argón. La temperatura adecuada para el óptimo funcionamiento del catalizador es de 200 °C. La columna de tamices moleculares y columna de pentóxido de fósforo tienen la función de fijar la humedad presente en el argón.

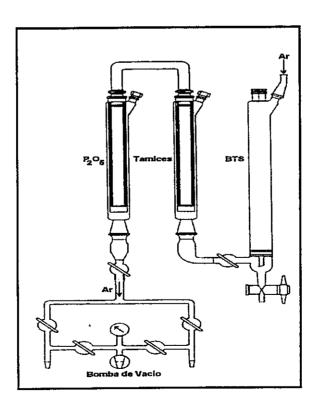


Figura 2.3. Línea de secado y línea de vacío-argón.

Formando un solo sistema, se une a la línea de secado y la línea de vacíoargón (ver Figura 2.3), que consta de las siguientes partes: Una bomba de vacío, una red para argón y una red para vacío.

2.1.4. Manipulación en atmósferas controladas

La manipulación de calcogenuros y calcofosfatos se realizó en atmósfera de argón libre de humedad. Para ello se dispuso de un balón con llave lateral conectado a la línea de vacío-argón. La homogenización de los productos de reacción, previamente tratados entre 500 y 850 °C, se realizó en una cámara seca (Atmosbag).

2.1.5. Hornos de reacción

En la síntesis a alta y baja temperatura se utilizó hornos cerámicos tubulares: a) Horno tubular Heraus Hanau, con termocupla Pt/Rh, (Temp. máx. 1600 °C); b) Horno tubular Lindberg Hevi-Duty, con termocupla Ni/Cr, (Temp. máx. 1200 ° C); c) Horno tubular de 2 Zonas, (Temp. máx. 900 °C); d) Horno tubular, con termocupla Pt/Rh, (Temp. máx. 1200 °C) y regulador de temperatura. La rapidez de calentamiento y enfriamiento utilizada fue entre ± 3-50 °C/hora. Estos hornos permiten realizar gradientes de temperatura en las ampollas de reacción (zona fría y zona caliente).

2.1.6. Preparación de fases calcofosfato

Las fases calcofosfato fueron preparadas utilizando método cerámico y de mezcla fundente. Los procedimientos de cada uno de los métodos fueron descritos anteriormente. Los reactivos utilizados en la síntesis de precursores y fases calcofosfato fueron los siguientes:

Metales alcalinos, Potasio (K), Sodio (Na), Litio (Li) son reactivos MERCK con purezas > 99 %. Los metales en polvo Cobre (Cu), Plata (Ag), Bismuto (Bi) y Antimonio (Sb) son reactivos ALDRICH Chemical Co. con purezas de 99.99 %.

P₄S₁₀ es un reactivo MERCK con pureza > 99%. P₄Se₁₀ no es un reactivo comercial. La preparación de este compuesto se realizó a partir de Fósforo y Selenio de acuerdo a procedimientos informados en literatura [54]. Fósforo rojo en polvo es un reactivo MERCK con pureza > 99.99 %. Selenio en polvo, es un reactivo ALDRICH Chemical Co., con pureza de 99.5 %.

por mezcla fundente utilizó los solventes síntesis se En la Dimetilformamida DMF (MERCK pureza > 99 %), Éter Etílico (MERCK pureza 98 %), Etanol y Metanol (MERCK P. A.).

En la preparación de las fases A+M3+P2Q6 (A = Li, Na, K; M = Bi, Sb; Q = S, Se) se utilizó el método cerámico y mezcla fundente. Las reacciones entre los metales alcalinos A (Li, Na y K), metal M (Bi, Sb), Fósforo rojo en polvo y calcógeno Q (S, Se), fueron realizadas en ampollas de cuarzo selladas a presión reducida (ver 2.1.1.1). Las cantidades fueron calculadas de acuerdo a las estequiometrías propuestas. Además, se utilizó la mezcla fundente A₂Q/P₄Q₁₀/Q (ver 2.1.2). Se buscaron las condiciones óptimas de temperatura y tiempo de reacción.

En la preparación de las fases $A^{+}M^{3+}P_{2}Q_{6}$ (A = Cu, Ag; M = Bi, Sb), $A_{1-3X}^{+}B_{1}^{3+}+xP_{2}Se_{6}$ (A = Cu, Ag; x = 0.1 y 0.2), $Cu_{1}^{+}B_{1}^{3+}+xSb_{1$ 0.3), se utilizó el método cerámico y mezcla fundente. Las reacciones entre los metales de transición A (Cu, Ag), metal M (Bi, Sb), Fósforo rojo en polvo y calcógeno Q (S, Se), fueron realizadas en ampollas de cuarzo selladas a presión reducida (ver 2.1.1). Las cantidades fueron establecidas de acuerdo a las estequiometrías propuestas. Además, se utilizó la mezcla fundente P₄Q₁₀/Q (ver 2.1.2). Se buscaron las condiciones óptimas de temperatura y tiempo de reacción.

La preparación de las fases $Bi_{1-x}^{3+}Sb_{x}^{3+}PQ_{4}$ (x = 0.1; 0.2; 0.3), se realizó por transporte de vapor. En ampollas de cuarzo (ver 2.1.1), se depositaron los metales metal M (Bi, Sb), Fósforo rojo en polvo, calcógeno Q (S, Se) y Yodo (agente Transportador). Las cantidades fueron establecidas de acuerdo a las estequiometrías propuestas. Además, se realizó la preparación de los compuestos utilizando la mezcla fundente P₄Se₁₀/Se (ver 2.1.2). Se buscaron las condiciones óptimas de temperatura y tiempo de reacción.

2.1.6.1. Preparación de A_2Q (A =Li, Na, K; Q = S, Se)

La preparación de los precursores tipo A_2Q (Q = S, Se; A =Li, Na, K) se realizó en amoniaco líquido. Los precursores se prepararon a partir de cantidades estequiométricas de calcógeno Q y metal alcalino A. Es necesario agregar un pequeño exceso de metal alcalino A (1% en masa) para asegurar que el calcógeno Q reaccione completamente. El amoniaco líquido es condensado a -78 °C (mezcla frigorifica hielo seco-acetona). En el procedimiento de condensación del amoniaco; también puede ser utilizado nitrógeno líquido (Figura 2.4). La mezcla se agita hasta obtener una solución azul. Es importante la agitación durante todo el tiempo de reacción para que sea estequiométrica. Una vez completada la reacción (4 horas), el NH3 líquido es removido por evaporación sobre corriente de argón a temperatura ambiente. El material obtenido es secado al vacío, homogenizado y mantenido en atmósfera de argón. Análisis elemental y análisis térmico, permiten establecer la obtención de los precursores. Los rendimientos se encuentran entre 92% y 95%. Hay que destacar, que estos compuestos no son comerciales con las especificaciones de pureza necesarias.

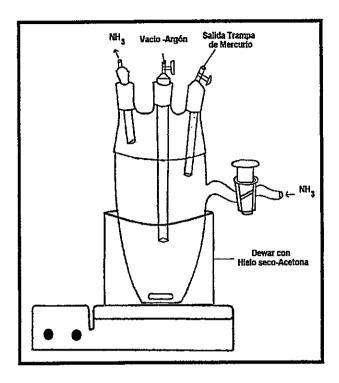


Figura 2.4. Síntesis en amoniaco líquido.

En un típico experimento se mezclaron en cantidades estequiométricas alcalinos y calcógeno para dar 5 gramos de sulfuro, metales aproximadamente 100 ml de amoniaco líquido. Los Sulfuros de metales alcalinos obtenidos son materiales de color amarillo y los Selenuros de color naranja.

2.1.6.2. Preparación de P₄Se₁₀

La preparación se realizó por reacción en estado sólido a partir de sus elementos puros, en cantidades estequiométricas, en ampollas de cuarzo selladas a presión reducida de argón. Los reactivos fueron calentados a 460°C por 3 días. Luego el material fue homogenizado en atmósfera de argón [54].

2.2. Caracterización

2.2.1. Microscopía electrónica de barrido MEB-EDX y análisis elemental

Los productos de reacción fueron analizados por microscopía electrónica de barrido (MEB) en un equipo JEOL 6400 scanning electron microscopy. equipado con detector de energía dispersivas de rayos X (EDX) Oxford Link Isis. Las muestras fueron preparadas prensando el polvo policristalino con una presión de 1 Tonelada/cm² generando una pastilla cilíndrica. Las pastillas fueron pulidas y metalizadas por "sputtering" con una capa fina de oro o carbón. Los análisis de microscopía electrónica de barrido (MEB) con analizador de energías dispersivas de rayos x (microsonda-EDX), se llevaron a cabo mediante un muestreo puntual y promedio, con el fin de evaluar homogeneidad, pureza y estequiometrías. Se obtuvieron imágenes de electrones secundarios (ES) y retrodispersados (ER). Las imágenes ER se utilizaron para determinar la distribución de metales pesados en los productos obtenidos.

El análisis elemental de metales alcalinos y de transición fue obtenido por espectrometría de absorción atómica con fuente de plasma (induced coupled plasma ICP), utilizando un equipo Perkin Elmer modelo 2000. La digestión de las muestras sólidas se realizó en solución alcalina.

2.2.2. Técnicas de difracción de rayos X

2.2.2.1. Monocristales

Cristales con dimensiones apropiadas (aprox. 0.02 x 0.05 x 0.05 mm³), fueron registrados en fibras de vidrio, utilizando un Difractómetro Bruker SMART, equipado con detector de área (plataforma CCD). El equipo opera a 50 KV y 40 mA con radiación MoKα (monocromador de grafito). La recolección de datos se realizó utilizando el programa 'Bruker SMART (BRUKER 1996)'. En la reducción, solución y refinamiento de datos experimentales se utilizaron los programas 'Bruker SAINTPLUS V6.02 (BRUKER 1997)', 'Bruker SHELXTL V6.10 (BRUKER 2000)' y 'SHELXS-97 (Sheldrick, 1997)'. Los programas Atoms 4.1 (Dowty E., 1996) y Diamond 2.1e (Branderburg K., 2001) fueron utilizados en la visualización gráfica de las estructuras cristalinas.

2.2.2.2. Polvo Policristalino

Los diagramas de rayos X fueron obtenidos utilizando un difractómetro SIEMENS D5000, equipado con ánodo de cobre (radiación $CuK\alpha$) y un filtro de níquel. Las medidas se realizaron en un rango 2 < 20 < 80. El equipo opera a 40kV y 25 mA. La identificación se realizó por comparación de los diagramas de rayos X en muestras de polvo cristalino (DRX), con los informados en la base de datos JCPDS-ICDD (Join Committe on Powder Diffraction Standard). La indexación de los diagramas se realizó utilizando rutinas de refinamiento Powder Diffraction Package (PDP) y Powder Pattern Lattice Parameter (PPLP) del programa NRCVAX. Diagramas de polvo calculado y determinación de constantes de red se realizó con los programas XPOW (SHELXS-97) y X-Powder, Cheng Dong, National Lab. for Superconductivity (NCSC), Intitut of Physics. Chinese Academy of Science.

2.2.3. Espectroscopia Infrarroja

Los espectros infrarrojos en la región de 4000-450 cm⁻¹, fueron obtenidos en un espectrofotómetro IR-Raman con transformada de Fourier (FTIR) Perkin Elmer 2000. Las muestras fueron preparadas en pastillas cilíndricas en KBr. Los espectros infrarrojos en la región de 500-200 cm⁻¹, fueron obtenidos en un espectrofotómetro BRUKER VECTOR 22 con transformada de Fourier. Las muestras fueron preparadas en óxido de polietileno.

2.2.4. Análisis térmico (ATD-ATG)

El análisis térmico diferencial (ATD) y termogravimétrico (ATG) fue obtenido en un analizador STA 1500H/625 con registro simultáneo de temperatura. Las curvas simultáneas ATD/ATG fueron obtenidas calentando las muestras en atmósfera de nitrógeno en crisoles de cerámica, con una velocidad de calentamiento de 10 °C/min desde la temperatura ambiente hasta 1000 °C.

2.2.5. Susceptibilidad Magnética

Las medidas de susceptibilidad magnética (x) fueron realizadas usando un sistema SHE VTS-906 SQUID. Las muestras en polvo policristalino fueron analizadas a fuerza de campo constante (1KG) entre 5K y temperatura ambiente.

2.2.6. Conductividad Eléctrica

La conductividad eléctrica fue medida por métodos a corriente directa (d.c.) y corriente alterna (a.c.). Medidas de impedancia compleja (a.c.) fueron realizadas en un analizador de respuestas en frecuencia FRA Solartron SI-1260. El rango de frecuencias analizado fue 0.1 a 10 MHz, con un nivel de señal entre 25 mV y 1V (Anexo 8.1). Las medidas se efectuaron sobre pastillas cilíndricas de espesores entre 0.1-0.3 cm y superficies entre 0.65-0.8 cm². Los materiales de polvo policristalino fueron prensados (1 Tonelada/cm²). Esta presión fue escogida para comparar los resultados de las medidas de conductividad con las fases informadas en literatura. Las pastillas fueron sometidas a un tratamiento térmico a 150 °C por 5 horas. Posteriormente, la superficie fue metalizada por "sputtered"

con oro y colocadas entre dos electrodos de platino. Se realizó diagramas de Nyquit a tiempo y temperatura variable.

Las medidas a corriente directa (d.c.) fueron realizadas en un electrómetro programable Keithley 237. Estudios de conductividad a oscuras e iluminadas fueron realizadas a tiempo y temperatura variable. El rango de temperatura utilizado fue entre 20-200 °C a una presión de aproximadamente 10-3 atmósferas de argón. Las medidas se efectuaron sobre pastillas cilíndricas de espesores entre 0.1-0.3 cm y superficies entre 0.65-0.8 cm². Los materiales de polvo policristalino fueron prensados (1 Tonelada/cm²) y sometidas a un tratamiento térmico. Esta presión fue escogida para comparar los resultados de las medidas de conductividad con las fases informadas en literatura. Las muestras fueron monitoreadas en un cámara metálica, donde la iluminación pasa a través de una ventana transparente (Anexo 8.2). Los contactos eléctricos se realizaron con pintura de plata, en una configuración plana de los electrodos. En las medidas de foto corriente, se utilizó una lámpara halógena Doolan Jenner Fiberlite A3200 con densidad de luz de 50 mW/cm². A partir de curvas de intensidad versus voltaje (I-V), fue verificado el carácter Ohmico de los contactos.

3 Fases AMP_2Q_6 (A = Li, Na, Cu, Ag, K; M = Bi, Sb y Q = S, Se)

Los primeros tiofosfatos cuaternarios de Bi y Sb informados en literatura fueron $A_3M(PS_4)_2$ (A = K, Rb, Cs; M = Sb, Bi), $Cs_3Bi_2(PS_4)_3$ y $Na_{0.16}Bi_{1.28}P_2S_6$. Posteriormente se obtuvieron selenofosfatos tipo $M_4(P_2Se_6)_3$, α -KMP $_2Se_6$, β -KMP $_2Se_6$ y $Cs_8M_4(P_2Se_6)_5$ (M = Bi, Sb). Estos compuestos son estabilizados por metales alcalinos y presentan aniones calcofosfato tipo etano $P_2Q_6^{4-}$ en su estructura. La síntesis de estas fases se realizó utilizando mezcla fundente ($A_2Q/P_4Q_{10}/Q$) a baja temperatura (250-500 °C).

Las fases tipo AMP₂Q₆ reportadas en literatura poseen cationes alcalinos de gran tamaño (Potasio, Rubidio, Cesio). La síntesis con cationes más pequeños (Litio, Sodio, Cobre, Plata) permitirá establecer la influencia del tamaño del catión en la dimensionalidad y propiedades eléctricas.

3.1. Síntesis

La preparación de la familia de compuestos tipo AMP_2Q_6 (A = Li, Na, K, Cu, Ag; M = Bi, Sb; Q = S, Se) se realizó por el método cerámico y de mezcla fundente ($A_2Se/P_4Se_{10}/Se$), de acuerdo a los procedimientos descritos en el punto 2.1.

Se intento la síntesis de las fases cuaternarias con metales alcalinos tipo AMP_2Q_6 (A = Li, Na, K; M = Bi, Sb; Q = S, Se). En este caso, solo fue posible la obtención de Nuevas fases tipo KMP_2S_6 (M = Bi, Sb) y $NaSbP_2S_6$. Los productos de reacción para compuestos con A = Li y Q = S, Se fueron mezclas de compuestos binarios y ternarios. En el caso de la familia de compuestos AMP_2Q_6 (A = Cu, Ag; M = Bi, Sb; Q = S, Se) se obtuvo fases puras para Q = Se.

A continuación, se informan las condiciones de preparación y los resultados para cada una de las estequiometrías propuestas.

3.1.1. Seleniodifosfatos AMP_2Se_6 (A = Li, Na, K; M = Bi, Sb)

La preparación de los compuestos por el método a alta temperatura, se realizó a partir de sus elementos en cantidades estequiométricas. La síntesis se realizó utilizando recubrimientos con carbón y doble ampolla de reacción (ver punto 2.1.1.1). Se mezclaron inicialmente cantidades de Selenio en polvo, metal alcalino A, Fósforo rojo y Bismuto o Antimonio en polvo. Un resumen de las cantidades iniciales, temperatura, tiempo y productos obtenidos se muestran en la Tabla 3.1.

Tabla 3.1. Preparación de AMP_2Se_6 (A = Li, Na, K; M = Bi, Sb) a alta temperatura. Cantidades molares iniciales de cada una de los reactivos y temperatura de reacción.

∴ Se	A	· P	M	्रTemp. (°C)	tiempo (días)	Productos
6.0	1.1	2.2	1.0	870	14	AMSe ₂ + P ₂ Se _Z
6.2	1.2	2.3	1.0	750	13	K ₂ Se ₃ + KMP ₂ Se ₆
7.1	1.2	3.1	1.1	850	30	A ₂ Se + M ₂ Se ₃ + P ₂ Se _Z
6.6	1.3	2.5	1.0	700	12	A ₂ Se + P ₂ Se _z + M ₂ Se ₃
6.5	1.4	3.1	1.0	850	12	A ₂ Se + M ₂ Se _X + P ₂ Se _Z

Los compuestos calcofosfato $M_2P_2Se_6$, informados en literatura, son formados a temperaturas entre 700 y 850 °C. A esta temperatura es posible estabilizar el anión $P_2Se_6^{4-}$. Por lo tanto, las reacciones fueron llevadas a cabo en este rango de temperaturas (Tabla 3.1). Los productos fueron enfriados lentamente hasta temperatura ambiente a razones entre 6-20 °C/hora.

La mezcla fundente utilizada fue A_2 Se/ P_4 Se $_{10}$ /Se (A = Li, Na y K). Se realizó un barrido de temperatura entre 300 y 500 °C. Se utilizó mezcla fundente a ~ 800 °C para poder establecer si la temperatura era un factor importante en la preparación de estos compuestos. Un resumen de las condiciones de síntesis se muestran en la Tabla 3.2. En ampollas de cuarzo (ver punto 2.1) se depositaron inicialmente cantidades de los precursores A_2 Se, P_4 Se $_{10}$, Se y M en diferentes proporciones (ver Tabla 3.2). Las cantidades de P_4 Se $_{10}$ y M se mantuvieron constantes, mientras que las cantidades iniciales de P_4 Se y Se fueron variables.

Tabla 3.2. Preparación de AMP₂Se₆ (A = Li, Na, K; M = Bi, Sb) utilizando mezcla fundente. Cantidades molares iniciales de cada uno de los reactivos y temperatura de reacción.

, Li₂Se/Se√	P₄Se ₁₀	M	Temp. (°C)	tiempo (días)	Productos
1/2	2.0	0.25	250	5	Li ₂ Se _Z + β-M ₄ (P ₂ Se ₆) ₃
1/3.5	2.0	0.25	370	6	Li ₂ Se + M ₂ Se ₃ + P ₂ Se _Z
1/4	2.0	0.25	770	14	LiMSe ₂ + P ₂ Se _z
1/6	4.0	0.50	370	4	Li ₂ Se + P ₂ Se _Z + M ₂ Se ₃ + Se
1 / 4.5	6.0	0.25	380	5	Li ₂ Se + M ₂ Se ₃ + β -M ₄ (P ₂ Se ₆) ₃
Na ₂ Se/Se	P ₄ Se ₁₀	* M	Temp. (°C)	tiempo (días)	Productos
1/2	2.0	0.25	800	15	NaMSe ₂ + P ₂ Se ₂
1/3	2.0	0.50	375	6	Na ₂ Se _z + P ₂ Se _z + M ₂ Se ₃
1/4	2.0	0.25	550	5	Na ₂ Se _Z + P ₂ Se _Z + M ₂ Se ₃
1/7	4.0	0.30	330	6	Na ₂ Se _Z + β-M ₄ (P ₂ Se ₆) ₃
1/9	4.0	1.00	400	4	Na ₂ Se + M ₂ Se ₃ + P ₂ Se _z
≲K₂Se/Se {	P ₄ Se ₁₀	₩.	Temp. (°C)	tiempo (días)	Productos
1/3	2.0	0.50	380	6	β -Bi₄(P₂Se₆)₃ y M₂Se₃
1/4	2.0	0.25	550	6	α-KMP ₂ Se ₆ + M ₂ Se ₃
1/3	4.0	1.00	550	6	α-KMP ₂ Se ₆ + M ₂ Se ₃ + P ₂ Se _Z
1 /2	6.0	0.25	850	17	β -Bi ₄ (P ₂ Se ₆) ₃ + M ₂ Se ₃ + P ₂ Se _Z

Cada uno de los productos de reacción, obtenidos por mezcla fundente o método cerámico, fueron separados al microscopio óptico para su posterior identificación. En general, los productos A_2 Se y AMSe $_2$ son materiales en polvo de tonalidad naranja y negra, respectivamente. Las fases β -Bi $_4$ (P_2 Se $_6$) $_3$ y β -KMP $_2$ Se $_6$ se presenta como material en polvo de color rojo oscuro ó negrorojizo. Los selenuros tipo M_2 Se $_3$ son polvo policristalino de tonalidad plomo oscuro.

El análisis al microscopio óptico, difracción de rayos X de muestras de polvo y MEB-EDX de los productos de reacción (síntesis a alta temperatura y mezcla fundente), permite establecer que se trata de mezclas heterogéneas. Los diagramas de rayos X de los productos muestran señales que son identificables como compuestos informados en literatura α -KMP $_2$ Se $_6$, β -Bi $_4$ (P $_2$ Se $_6$) $_3$ y M $_2$ Q $_3$. A las temperaturas de trabajo empleadas, se favorece la formación de dicalcogenuros tipo M $_2$ Q $_3$ como producto mayoritario. Finalmente se destaca que algunas reacciones se mantuvieron por largos períodos de tiempo (3-4 semanas) para descartar factores difusionales en la síntesis.

3.1.2. Tiodifosfatos AMP_2S_6 (A = Li, Na, K; M = Bi, Sb)

La preparación de los compuestos por el método a alta temperatura, se realizó a partir de sus elementos en cantidades estequiométricas. La síntesis se realizó utilizando recubrimientos con carbón y doble ampolla de reacción (ver punto 2.1.1.1). Se mezclaron inicialmente cantidades de Azufre en polvo, metal A, Fósforo rojo y Bismuto o Antimonio en polvo. Un resumen de las cantidades iniciales, temperatura, tiempo y productos obtenidos para compuestos de Litio se muestran en la Tabla 3.3.

Tabla 3.3. Preparación de LiMP₂S₆ (M = Bi, Sb) a alta temperatura. Cantidades molares iniciales de cada reactivo y temperatura de reacción.

្នុះS ្ន	A	*P.\.\	<u></u> M. ₹	Temp. (°C)	tiempo (días)	Productos ?
6.1	1.1	2.0	1.0	850	12	LiMS ₂ + BiPS ₄
6.0	1.3	2.1	1.0	770	12	Li ₂ S + M ₂ S ₃ + BiPS ₄
7.3	0.9	3.1	1.0	860	15	$Li_2S + M_2S_3 + P_2S_Z$
6.5	1.2	2.5	1.0	740	13	Li ₂ S _Z + BiPS ₄
6.5	1.2	3.2	1.0	860	32	LiMS ₂ + M ₂ S _X + BiPS ₄

Cada uno de los productos de reacción fueron separados al microscopio óptico para su posterior identificación. En general, los productos Li₂S y LiMS₂ son materiales en polvo de tonalidad blanco y negro respectivamente. La fase BiPS₄ se presenta como material en polvo de color rojo o cristales de hábito romboédrico. Los sulfuros tipo M₂S₃ son polvo policristalino de tonalidad plomobrillante.

El análisis de difracción de rayos X de muestras de polvo y MEB-EDX de los productos de reacción indican la formación de fase ternaria $BiPS_4$ y de fases binarias M_2S_3 , A_2S_2 y P_2S_2 . Las condiciones de las reacciones conducen a la formación de M_2S_3 como producto mayoritario (~60%) y de $BiPS_4$, A_2S_2 y P_2S_2 como productos minoritarios (~35%). El resto del material son impurezas no identificables.

En el caso de las fases con potasio tipo AMP_2S_6 (A = Na, K; M = Bi, Sb), la síntesis para alta temperatura permitió la formación de nuevas fases

cuaternarias. Un resumen de las cantidades iniciales y temperatura de reacción se muestran en la Tabla 3.4. La utilización de la mezcla fundente ($A_2S/P_4S_{10}/S$) para baja y alta temperatura favorece la obtención de las fases informadas en literatura tipo $K_3M(PS_4)_2$ y $Na_{0.16}Bi_{1.28}P_2S_6$ [52].

Tabla 3.4. Preparación de AMP_2S_6 (A = Na, K; M = Bi, Sb) a alta temperatura. Cantidades molares iniciales de cada uno de los reactivos y temperatura de reacción.

₹S.	,A	P.	M	Temp.*(°C)	tiempo (días)	Productos
6.1	1.2	2.4	1.1	850	14	$A_xP_yS_Z + M_2Q_3 + KMP_2S_6$
7.4	1.4	2.5	1.0	860	15	M ₂ Q ₃ + KMP ₂ S ₆
9.1	1.1	2.1	0.9	850	14	PySz + KMP2S6 + S
6.4	1.2	2.2	1.1	870	30	NaSbP ₂ S ₆ +P _y S _Z +S
6.1	1.3	2.2	0.9	850	28	NaSbP ₂ S ₆ +P _y S _Z

Se mezclaron inicialmente cantidades de Azufre en polvo, metal alcalino A, Fósforo rojo y Bismuto o Antimonio en polvo (ver Tabla 3.4). Cada uno de los productos de reacción fueron separados al microscopio óptico para su posterior identificación. En general, los productos $A_x P_y S_Z$ y S son materiales en polvo de color amarillo. Los sulfuros tipo $M_2 Q_3$, son materiales en polvo policristalino de tonalidad plomo-brillante. Cristales y polvo policristalino del compuesto $KBiP_2S_6$ son de color rojo y del compuesto $KSbP_2S_6$ son de color amarillo. Polvo policristalino del compuesto $NaSbP_2S_6$ es de color amarillo.

Representa una gran dificultad técnica realizar la preparación de compuestos con Sodio. La mayoría de las ampollas de reacción explotan

durante los periodos de enfriamiento, debido a la existencia de una transición exotérmica para temperaturas entre 400 y 500 °C. Sólo en algunas ocasiones, es posible obtener el compuestos NaSbP₂S₆. Por otro lado, existen evidencias de la formación de la fase NaBiP₂S₆. Polvo policristalino de color rojo, aislado de reacciones entre Na, Bi, P y S indican una composición promedio de Na_{0.8}Bi_{1.1}P_{1.9}S_{6.2}. Diagramas de polvo de rayos X presentan señales que pueden ser asignadas a la presencia de un compuesto isoestructural a KBiP₂S₆.

El análisis elemental (MEB-EDX) y de difracción de rayos X de muestras de polvo policristalino, permite establecer la formación de nuevas fases con estequiometría KMP₂S₆ (M = Bi, Sb) y NaSbP₂S₆. Sin embargo, pequeñas cantidades de impurezas se encuentran presentes en los productos de reacción. Los productos resultaron ser una mezcla de material policristalino y monocristales (95/5%). Se seleccionó cristales y material policristalino de las diferentes muestras, con ayuda de un microscopio óptico, para realizar análisis elemental, espectroscópico y DRX. Este material, es tratado con Dimetilformamida (DMF) y Etilendiamina (en) para remover impurezas de A_xP_yS_Z y P_yS_Z. Finalmente, los productos son lavados y secados con éter anhidro.

3.1.3. Tiodifosfatos AMP_2S_6 (A = Cu, Ag; M = Bi, Sb)

Los procedimientos de síntesis fueron descritos en el punto 2.1.2. La mezcla fundente utilizada fue P_4S_{10}/S . Se realizaron pruebas con cantidades estequiométricas y con exceso de los precursores P_4S_{10} y S. Los resultados de las reacciones a baja temperatura son presentados en la Tabla 3.5.

Tabla 3.5. Preparación de AMP_2S_6 (A = Cu, Ag; M = Bi, Sb) utilizando mezcla fundente. Cantidades molares iniciales de cada una de los reactivos y temperatura de reacción.

	gyar g	i were	T (00)	tiempo 🗧	Producto
P ₂ S ₅ /S	A	W ×	remps ("C)	(días)	
1/1	1.1	1.2	270	4	$Cu_2S/Ag_2S + M_2S_3 + P_2S_Z$
1/2	1.0	1.1	250	4	Cu ₂ S/Ag ₂ S + M ₂ S ₃ + P ₂ S _Z
1/3.3	1.2	1.0	375	5	Cu ₂ S/Ag ₂ S + P ₂ S ₂ + M ₂ S ₃
1/4	1.4	1.5	365	4	Cu ₂ S/Ag ₂ S + M ₂ S ₃ + BiPS ₄
1/4.5	2.1	1.3	390	4	Cu ₃ PS ₄ /Ag ₂ P ₂ S ₆ + BiPS ₄ + M ₂ S _y
1/9	2.2	1.1	550	4	Cu ₃ PS ₄ /Ag ₂ P ₂ S ₆ + BiPS ₄ + M ₂ S _y

Debido a la posibilidad de formación de calcogenuros de plata y cobre, se utilizaron cantidades estequiométricas de Cu y Ag como exceso de P_4S_{10}/S . Los productos de reacción mostrados en la Tabla 3.5, indican los resultados para la síntesis con A = Ag, Cu.

En el caso de la preparación de compuestos con Plata se obtuvo Ag₂S y Ag₂P₂S₆ como producto de reacción (ver Tabla 3.5). En la preparación de compuestos con Cobre se obtuvo Cu₂S y Cu₃PS₄ como producto de reacción.

Todas las reacciones mostraron la formación de BiPS₄. Cada uno de estos materiales fueron separados al microscopio óptico para su posterior identificación. En general, los productos Cu_2S , Ag_2S , Cu_3PS_4 y $Ag_2P_2S_6$ son materiales en polvo de tonalidad Negro. La fase $BiPS_4$ se presenta como material en polvo de color rojo o cristales de hábito romboédrico. Los sulfuros tipo M_2Q_3 son polvo policristalino de tonalidad plomo-brillante.

El análisis al microscopio óptico y MEB-EDX, permite establecer que se trata de mezclas heterogéneas. Los difractogramas de rayos X muestran señales de compuestos informados en literatura Cu₃PS₄, Ag₂P₂S₆, BiPS₄ y M₂Q₃. Las reacciones indicadas en la tabla 3.5 se realizaron 2 veces obteniendo los mismo productos de reacción. A las temperaturas de trabajo empleadas se favorece la formación de BiPS₄ como producto mayoritario.

Debido a que no fue posible obtener compuestos tipo AMP_2S_6 (A = Cu, Ag; M = Bi, Sb), por utilización de mezcla fundente, se intento su preparación para alta temperatura. La preparación de los compuestos por el método a alta temperatura, se realizó a partir de sus elementos en cantidades estequiométricas (ver punto 2.1.1). Se mezclaron inicialmente cantidades de Azufre en polvo, Cobre o plata, Fósforo rojo y Bismuto o Antimonio en polvo. Un resumen de la síntesis, a alta temperatura, de los compuestos Tiodifosfatos AMP_2S_6 (A = Cu, Ag; M = Bi, Sb), se muestra en la Tabla 3.6.

Tabla 3.6. Preparación de AMP_2S_6 (A = Cu, Ag; M = Bi, Sb) a alta temperatura. Cantidades molares iniciales de cada una de los reactivos y temperatura de reacción.

S	A	P.	M	Temp. (°C)	tiempo (días)	Producto
6.0	1.1	2.2	1.0	870	4	Cu ₃ PS ₄ / Ag ₂ S + M ₂ S ₃ + BiPS ₄
6.2	1.2	2.3	1.0	750	12	Cu ₃ PS ₄ / Ag ₂ S + M ₂ S ₃ + BiPS ₄
7.1	1.2	3.1	1.1	850	27	Cu ₃ PS ₄ / Ag ₂ P ₂ S ₆ + M ₂ S ₃
6.6	1.3	2.5	1.0	700	13	Cu ₃ PS ₄ /Ag ₂ P ₂ S ₆ + M ₂ S ₃ + BiPS ₄
6.5	1.4	3.1	1.0	850	14	Cu ₃ PS ₄ / Ag ₂ P ₂ S ₆ + M ₂ S ₃ + BiPS ₄

El análisis de los productos de reacción, permite establecer que se trata de mezclas de compuestos informados en literatura. A temperaturas intermedias (300-600°C) se favorece la formación de las fases Ag₂P₂S₆, Cu₃PS₄ y BiPS₄. A mayores temperaturas se favorece la formación de BiPS₄ y dicalcogenuros tipo M₂S₃ como producto mayoritario. Finalmente, se destaca que algunas reacciones se mantuvieron por largos períodos de tiempo (3-4 semanas) para descartar factores difusionales en la síntesis.

3.1.4. Seleniodifosfatos AMP₂Se₆ (A = Cu, Ag; M = Bi, Sb)

Las fases AMP₂Se₆ (A = Cu, Ag; M = Bi, Sb) fueron preparadas mediante dos procedimientos a alta temperatura. En el primer procedimiento, los productos fueron obtenidos por reacción en estado sólido de sus elementos puros en cantidades estequiométricas. Se agrega un exceso de selenio y

fósforo (~1% masa) para evitar la formación de impurezas (Cu_3PSe_4 , $Ag_4P_2Se_6$ y M_2Se_3).

Los compuestos CuGaP₂Se₆ , informados en literatura, son formados a temperaturas entre 700 y 800 °C durante tres semanas. A esta temperatura es posible estabilizar el anión P₂Se₆⁴⁻ en fases que contienen los cationes Cu⁺ y M³⁺. Por lo tanto, la mezcla de reacción es calentada a 750 °C por una semana y enfriada lentamente hasta temperatura ambiente. Se obtuvo material homogéneo y muy cristalino luego de moler y calentar a 750 °C por una semana.

En el segundo procedimiento, la síntesis se realiza por combinación directa de los metales. A y M con un exceso de P₄Se₁₀ y Se. Esto permite que los metales reaccionen completamente y ayuda a la obtención de material muy cristalino. Los precursores A, M, P₄Se₁₀ y Se fueron mezclados en razones molares 1.0; 1.0; 1.5; 2.0. La mezcla de reacción es calentada hasta 750°C a razón de 30 °C/h. La temperatura es mantenida a 750°C por 5 días y luego enfriada hasta temperatura ambiente a una razón de 6 °C/h. La mezcla de reacción es tratada con DMF/Etilendiamina (3:1), para remover el exceso de P_ySe_z y Se. Cristales laminares negros son obtenidos después de lavar con éter anhidro.

3.2. Microscopía electrónica MEB-EDX y análisis elemental

Los resultados de la preparación de los compuestos AMP₂Q₆ (A = Li, Na, K, Cu, Ag; M = Bi, Sb; Q = S, Se), permitió la formación de Nuevas fases con las estequiometrías KBiP₂S₆, KSbP₂S₆, NaSbP₂S₆, AgBiP₂Se₆, AgSbP₂Se₆, CuBiP₂Se₆ y CuSbP₂Se₆. En el caso de KBiP₂S₆, KSbP₂S₆ y NaSbP₂S₆, cristales y material policristalino fueron separados de los productos de reacción. La preparación de compuestos con A = Ag, Cu permitió la formación de material policristalino puro y homogéneo (mezcla fundente). Los resultados del Análisis de microscopía electrónica con analizador de EDX acoplado y medidas de absorción atómica se informan a continuación.

3.2.1. Tiodifosfatos KMP_2S_6 (M = Bi, Sb) y $NaSbP_2S_6$

Se realizó análisis SEM-EDX general y puntual (5 adquisiciones por muestra), a los productos de tres reacciones (ver 3.1.2). Cada una de las muestras indicaban la presencia de fases con estequiometrías AMP₂S₆.

Los análisis de microscopía electrónica ES y ER, en muestras de polvo policristalino, permiten establecer que se trata de una mezcla heterogénea. Una imagen de la morfología observada en estas muestras de polvo policristalino se muestra en la Figura 3.1.

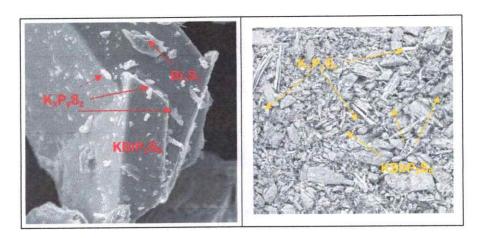


Figura 3.1. Imagen del material policristalino. A la Izquierda electrones secundarios de $KBiP_2S_6$. A la derecha electrones secundarios de $KSbP_2S_6$.

Los productos de reacción están formados por compuestos KMP_2S_6 (M = Bi, Sb) y $NaSbP_2S_6$ como productos mayoritarios (~94%) y compuestos tipo M_2S_3 y $K_xP_yS_z$ como productos minoritarios (~5%). El resto del material (~1%) son impurezas no identificables. El análisis elemental (promedio) de los compuestos cuaternarios, en las muestras de polvo policristalino, se informa en la Tabla 3.7.

Tabla 3.7. Análisis Elemental de las fases AMP₂S₆

		KBiP ₂ S ₆			
	K	Bi	Р	S	
% masa calculado	7.8	41.6	12.3	38.3	
% Experimental	6.2(4)	40.5(13)	13.2(3)	40.1(7)	
		KSbP ₂ S ₆			
	К	Sb	Р	S	
% masa calculado	9.5	29.3	14.9	46.3	
% Experimental	10.1(2)	28.1(9)	13.1(2)	48.7(5)	
				L	

Tabla 3.7. Análisis Elemental de las fases AMP₂S₆ (continuación)

NaSbP ₂ S ₆									
	Na	Sb	Р	S					
% masa calculado	5.8	30.5	15.5	48.2					
% Experimental	5.6(4)	31.1(9)	16.7(2)	46.6(5)					

Los análisis de los productos de reacción entre Sodio, Bismuto, Fósforo rojo y Azufre, permiten obtener evidencias de la formación de la fase NaBiP₂S₆. Es necesario realizar estudios de análisis térmico diferencial en las ampollas de reacción. Esta metodología permitiría obtener mayor información del rango de temperatura óptimo para la formación de dicho compuesto.

Monocristales seleccionados, estables al aire y a la humedad, indican una composición de $K_{1.1}Bi_{1.1}P_{1.8}S_{6.3}$ y $K_{0.9}Sb_{1.0}P_{1.9}S_{6.1}$ (Figura 3.2).

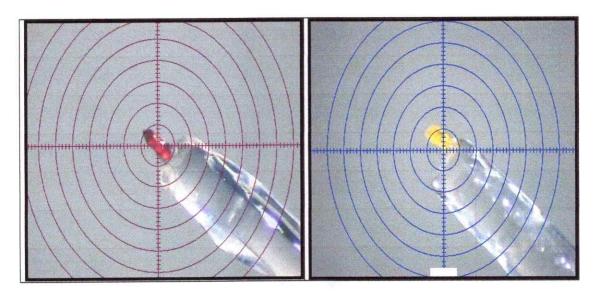


Figura 3.2. Monocristales de KMP_2S_6 . A la izquierda se muestra el compuesto $KBiP_2S_6$ y a la derecha $KSbP_2S_6$.

Los análisis de los metales (K, Na, Bi, Sb), también se realizaron por Absorción atómica ICP-Plasma. Los contenidos ponderales experimentales se encuentran de acuerdo a los valores esperados y a las cantidades obtenidas por microsonda EDX.

3.2.2. Seleniodifosfatos AMP₂Se₆ (A = Cu, Ag; M = Bi, Sb)

En el primer procedimiento de preparación, los compuestos fueron obtenidos por reacción en estado sólido de los reactantes (ver punto 3.1.4). Los productos de reacción fueron materiales en polvo policristalino. Se realizó análisis general y puntual (30 adquisiciones por muestra), para cada una de las muestras obtenidas de cuatro reacciones. Los resultados (promedio) del análisis elemental se muestran en la Tabla 3.8.

Tabla 3.8. Análisis Elemental de las fases AMP₂Se₆ (A = Cu, Ag; M = Bi, Sb)

That is a family	C C	uBiP ₂ Se ₆	THE COLUMN THE	
,	Cu	Bi	P	Se
% masa calculado	7.9	25.8	7.6	58.7
% Experimental	7.8(2)	25.7(2)	7.3(5)	59.2(5)
	A A	gBiP ₂ Se ₆		Mark I Treft 19
	Ag	Bi	Р	Se
% masa calculado	12.7	24.4	7.3	55.6
% Experimental	13.2(1)	24.2(2)	7.2(4)	55.4(3)
Constitution of the second	CI	uSbP₂Se ₆ ∴		阿塞特尼斯斯 \$193
	Cu	Sb	Р	Se
% masa calculado	10.1	16.6	8.5	64.8
% Experimental	10.0(4)	16.5(6)	8.2(2)	65.3(4)
the see that when with	A ₁	յՏbP₂Se ₆ ՀՏՀ	amenda de la companya	
	Ag	Sb	Р	Se
% masa calculado	14.1	15.9	8.1	61.9
% Experimental	14.3(3)	16.1(3)	7.8(4)	61.8(3)

Las imágenes de microscopía de electrones secundarios (ES) y de electrones retrodispersados (ER), permiten establecer que se trata de fases puras y homogéneas. Las imágenes ER indican que la distribución de metales pesados es homogénea. Una imagen de la morfología observada en estas muestras de polvo policristalino se muestra en la Figura 3.3.

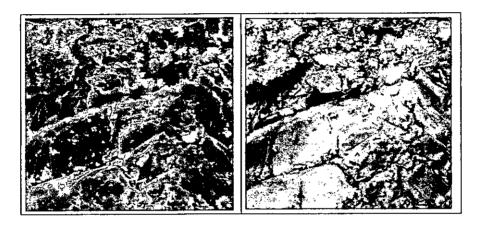


Figura 3.3. Imagen del material policristalino para la fase CuBiP₂Se₆. A la Izquierda electrones secundarios. A la derecha electrones retrodispersados.

En el segundo procedimiento, la síntesis se realiza por combinación directa de los metales. A y M con un exceso de P₄Se₁₀ y Se. Medidas de MEB-EDX realizadas en 20 cristales seleccionados (5 adquisiciones por cristal), indica una composición promedio Cu_{1.0}Bi_{1.0}P_{1.8}Se_{6.1}. Los análisis de los metales (Cu, Ag, Bi, Sb) también se realizaron por Absorción atómica ICP-Plasma. Los contenidos ponderales experimentales se encuentran de acuerdo a los valores esperados y a las cantidades obtenidas por microsonda EDX.

3.3. Caracterización estructural y vibracional

3.3.1. Tiofosfatos KMP_2S_6 (M = Bi, Sb)

3.3.1.1. Análisis Cristalográfico

Las estructuras de KBiP₂S₆ (I) y KSbP₂S₆ (II), fueron resueltas a partir de medidas de difracción de rayos x en monocristales. Un cristal rojo (I) con dimensiones 0.2 x 0.075 x 0.075 mm³ y un cristal amarillo (II) con dimensiones 0.22 x 0.1 x 0.09 mm³, fueron medidos en fibras de vidrio. Las correcciones por absorción de rayos X fueron realizadas usando rutina SADABS. El tratamiento de las intensidades medidas y el refinamiento de las estructuras se realizó con el paquete de programas cristalográficos SHELXTL (punto 2.2.2.1).

Los resultados indican que ambos compuestos son isoestructurales y cristaliza en el grupo espacial monoclínico P12₁1 (Tabla 3.9). La configuración absoluta fue establecida a partir de los valores de wR_{ref}(*F*²) para las dos posibles orientaciones (ver Anexo 8.3). Los valores refinados para el compuesto I fueron 0.0595 y 0.1907. Para el compuesto II fueron 0.0437 y 0.1811. El primero representa la estructura absoluta del cristal estudiado. Los datos cristalográficos, condiciones de medida e índices refinados (ver Anexo 8.3), son presentados en la Tabla 3.9. Las coordenadas atómicas y factores térmicos son mostrados en el Anexo 8.4.

Tabla 3.9. Datos cristalográficos de KBiP₂S₆ (I) y KSbP₂S₆ (II)

KBiP ₂ S ₆	KSbP ₂ S ₆
Rojo	Amarilio
$0.2 \times 0.075 \times 0.075 \text{mm}^3$	$0.22 \times 0.1 \times 0.09 \text{mm}^3$
P12 ₁ 1(N° 4), 2	P12 ₁ 1(N° 4), 2
Monoclínico	Monoclínico
6.6200(6)	6.6050(13)
7.4058(7)	7.6511(15)
9.9002(9)	9.754(2)
92.108(1)°	92.11(3)
485.04(8)	492.60(17)
20.148	4.740
56.0°	27.92°
3908 [R _{int} = 0.0342]	4075 [R _{int} = 0.0160]
2071	2078
1901	2037
91	91
0.676	1.035
0.0265	0.0184
0.0595	0.0437
0.0290	0.0189
0.012(7)	0.00
	Rojo 0.2 x 0.075 x 0.075 mm ³ P12 ₁ 1(N° 4), 2 Monoclínico 6.6200(6) 7.4058(7) 9.9002(9) 92.108(1)° 485.04(8) 20.148 56.0° 3908 [R _{int} = 0.0342] 2071 1901 91 0.676 0.0265 0.0595 0.0290

^a GooF = $\sqrt{[w(F_o^2 - F_c^2)/n - p]}$; ^b R1 = $\sum |F_o| - |F_c|/\sum F_o$; ^c WR2 = $\sqrt{\sum w(F_o|-|F_c|)^2/\sum w|F_o|^2}$; Donde $w = 1/[\sigma F_o^2 + aP^2]$,

 $P = (F_o^2 + 2F_c^2)/3$, a = 0.000 para i y a = 0.0219 para ii

3.3.1.2. Discusión estructural

Los compuestos KMP_2S_6 (M = Bi, Sb) presentan estructura bidimensional 2D, con aniones calcofosfato tipo etano $[P_2S_6]^{4-}$. La estructura consiste en láminas $[MP_2S_6]^{1-}$ separadas por cationes K^+ (Figura 3.4).

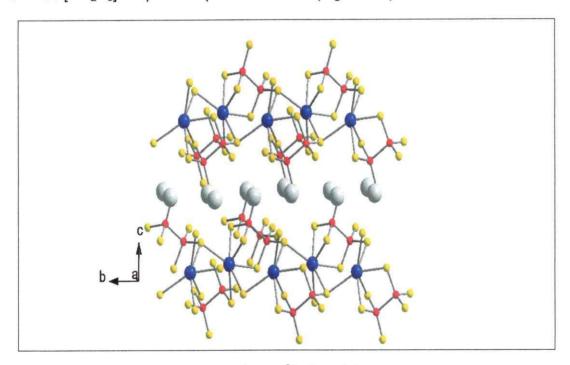


Figura 3.4. Estructura de KBiP $_2$ S $_6$. $^{\circ}$ K $^{+}$; $^{\bullet}$ Bi $^{3+}$; $^{\bullet}$ P; $^{\circ}$ S.

Estos compuestos pueden ser descritos a través de poliedros de coordinación (Figura 3.5). En esta representación, los átomos de azufre ocupan los vértices de los octaedros. Las láminas [MP₂S₆]¹⁻, en los compuestos KMP₂S₆, están formadas por octaedros distorsionados S₆ unidos a través de los cantos y los vértices. El interior de estos octaédros son ocupados alternadamente por pares P₂ y átomos de M.

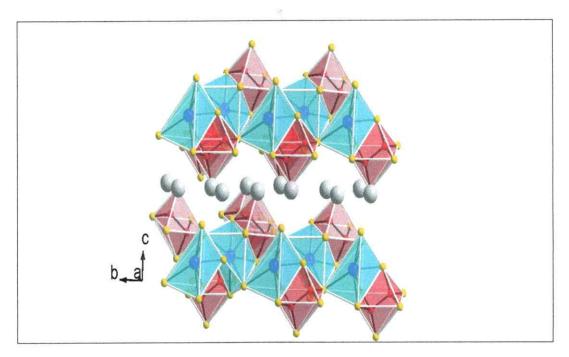


Figura 3.5. Representación poliédrica del compuesto $KBiP_2S_6$: Los átomos de azufre ocupan los vértices de los octaedros. Los pares P_2 se encuentran situados dentro de poliedros rojos; Bi^{3+} se encuentra situado dentro de poliedros celestes.

El anión tipo etano $[P_2S_6]^{4-}$ esta unido a 4 átomos M (Figura 3.6). Un átomo M esta coordinado por tres átomos de azufre; los otros tres átomos M, se encuentran unidos a un átomo de azufre de un grupo $[P_2S_6]^{4-}$.

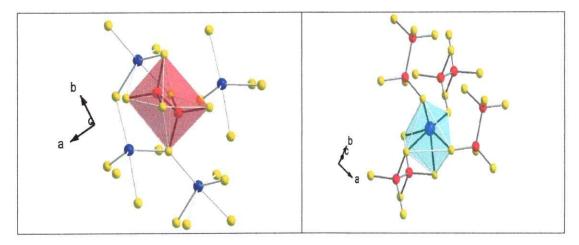


Figura 3.6. Unidades en KBiP₂S₆. Bi³⁺, P; S. A la izquierda se muestra el anión tipo etano $P_2S_6^{4-}$. A la derecha la coordinación del catión Bi³⁺.

Los cationes M^{3+} están unidos a seis átomos de azufre formando un octaedro distorsionado. Tres átomos de azufre pertenecen a un grupo $[P_2S_6]^{4-}$ y los otros tres son de grupos diferentes (Figura 3.6).

En el plano a-b se observa que los átomos de potasio se encuentran en túneles definidos por las láminas $[M^{3+}P_2S_6]^-$ (Figura 3.7). Estos túneles están formados por la unión de dos grupos MS_6 con los grupos calcofosfato $[P_2S_6]^{4-}$.

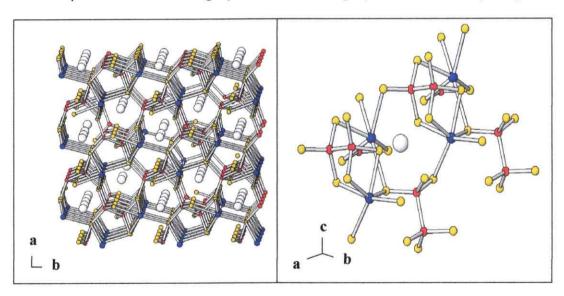


Figura 3.7. Plano a-b y canal en KBiP₂S₆: A la izquierda una representación del plano a-b en la estructura. A la derecha el canal y sitio de coordinación.

Las distancias de enlaces d(Bi-S), en el compuesto KBiP $_2$ S $_6$ (I), están en el rango de 2.706(2) Å a 3.141(2) Å (Tabla 3.10). Estas distancias son comparables a las observadas en el compuesto Na $_{0.16}$ Bi $_{1.28}$ P $_2$ S $_6$ (2.839(3) - 3.190(4) Å) [52]. La distorsión del octaedro BiS $_6$, puede ser explicada por la existencia de pares de electrones 6s 2 no compartidos en el

catión Bi³⁺. De acuerdo con el modelo TRPEV, los pares no compartidos aumentan las repulsiones electrónicas, resultando una esfera de coordinación distorsionada del catión Bi³⁺. Se observan longitudes de enlace mayores, para los enlaces cercanos a los pares no compartidos y mas cortas para los más alejados.

Tabla 3.10. Distancias de enlace a (Å) del compuesto KBiP₂S₆

Bi.	P1-	P2-
S1 2.734(2)	S1 2.057(3)	S4 2.058(3)
S2 2.895(2)	S2 2.042(3)	S5 2.030(3)
S3 3.141(2)	S3 1.992(3)	S6 1.962(3)
S4 2.706(2)	P2 2.219(3)	P1 2.219(3)
S3b 2.804(2)		
S2c 3.138(2)		

Las desviaciones estándar estimadas son calculadas mediante la ecuación $\sigma(l) = \sqrt{\sum_{n} [l_n - l]^n / n(n-l)}$; Donde l_n es la longitud de n enlaces, l la distancia promedio y n el número de enlaces.

Los ángulos de enlace S-P-S de $[P_2S_6]^{4-}$ están en el rango de 111.87(13)° a 113.72(12)°. Estos son comparables a los encontrados en Na_{0.16}Bi_{1.28}P₂S₆ (110.0(2)°-115.5(2)°) [52], NaSmP₂S₆ (110.3(1)°-116.12(1)°) y NaYbP₂S₆ (110.82(7)°-117.80(7)°) [1]. El anión tipo etano $[S_3P-PS_3]^{4-}$, posee configuración alternada de los grupos PS₃. Los ángulos S-P-P están en el rango de 103.83(11) y 108.58(12)°. Las longitudes de enlace en los aniones hexatiodifosfato $[P_2S_6]^{4-}$ son d(P-P) = 2.219(3) Å y d(P-S) en el rango de 1.962(3) Å a 2.058(3) Å. Similares distancias P-S han sido observadas en Na_{0.16}Bi_{1.28}P₂S₆ [52], NaMP₂S₆ (M = Yb, Sm) [4b], KSbP₂S₆ [37c] y Fe₂P₂S₆ [27].

El compuesto $KSbP_2S_6$ (II) presenta los átomos de Sb tricoordinados por un anion $[P_2S_6]^{4-}$ (Figura 3.8), con distancias de enlace d(Sb-S) en el rango de 2.5450(11) Å a 2.6676(12) Å.

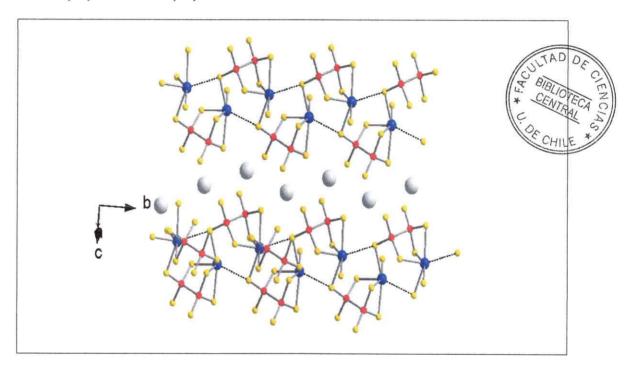


Figura 3.8. Estructura KSbP₂S₆: ° K⁺ , Sb³⁺; • P, S. Representación de la estructura bidimensional.

Un segundo anión $[P_2S_6]^{4-}$ se conecta a través de un enlace d(Sb-S)=2.8363(12) Å. Un tercer anión $[P_2S_6]^{4-}$ se conecta a través de un enlace d(Sb-S)=3.1471(5) Å (Tabla 3.11). Las cadenas son unidas lado a lado formando capas, a través de un contacto a larga distancia $Sb\cdots S$ a 3.4187(9) Å con un cuarto anión $[P_2S_6]^{4-}$ (Figura 3.9). La interacción a larga distancia $Sb\cdots S$ es más corta que la suma de los radios de van der Waals del SbyS (4.03 Å) [60]. Este tipo de coordinación, con interacciones a larga distancia, ha sido

observada en los compuestos $K_3Bi(PS_4)_2$ (dos contactos Bi-S) y β -KSbP $_2$ Se $_6$ (un contacto Bi-Se) [52,55].

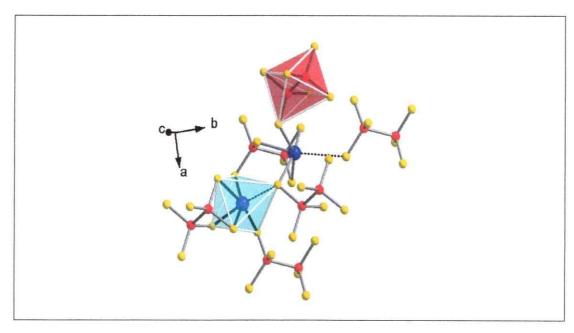


Figura 3.9. Unidad básica del compuesto KSbP₂S₆: • Sb³⁺; • P; • S.

Las distancias de enlace Sb-S (ver Tabla 3.11), son comparables a las encontradas en Sb_2S_3 y Sb_2S_4 [58-59].

Tabla 3.11. Distancias de enlace a (Å) del compuesto KSbP₂S₆

Sb-	P1-	P2-
S1 2.5450(11)	S3 1.9918(13)	S4 2.0695(14)
S2 2.6676(12)	S1 2.0768(13)	S5 2.0185(14)
S4 2.5484(12)	S2 2.0490(13)	S6 1.9625(14)
S5 2.8364(12)	P2 2.2244(13)	P1 2.2244(13)
S3b 3.1471(5)	,	
S2c 3.4187(9)*		

a Las desviaciones estándar estimadas son calculadas mediante la ecuación $\sigma(l) = \sqrt{\sum_{n} [l_n - l]^2 / n(n-l)}$; Donde l_n es la longitud de n enlaces, l la distancia promedio y n el número de enlaces.

Los ángulos de enlace S-P-S de $[P_2S_6]^{4-}$ están en el rango de 105.60(6) ° a 118.87(6). Estos son comparables a los encontrados en NaSmP₂S₆ [5b] (110.3(1)°-116.12(1)°) y NaYbP₂S₆ [5b] (110.82(7)°-117.80(7)°). El anion tipo etano $[S_3P-PS_3]^{4-}$, posee configuración alternada de los grupos PS₃. Los ángulos S-P-P están en el rango de 100.35(5) y 109.63(6)°. Las longitudes de enlace en los aniones hexatiodifosfato $[P_2S_6]^{4-}$ d(P-P) = 2.2244(13) Å y d(P-S) en el rango de 1.9625(14) Å a 2.0768(13) Å (Tabla 11). Similares distancias P-S han sido observadas en Fe₂P₂S₆ y KBiP₂S₆ [27, 37b].

3.3.1.3. Análisis polvo policristalino

Se realizaron medidas de difracción de rayos X en polvo policristalino para los compuestos KBiP₂S₆ (rojo), KSbP₂S₆ (amarillo) y NaSbP₂S₆ (amarillo). El polvo policristalino fue obtenido a partir de cristales y material cristalino separados de los productos de reacción. Los DRX calculados (ver Anexo 8.4) a partir de las estructuras resueltas de KBiP₂S₆ y KSbP₂S₆, fueron comparados con los diagramas de rayos X en muestras policristalinas de KBiP₂S₆, KSbP₂S₆ y NaSbP₂S₆ (Figura 3.10a). La indexación de los diagramas de polvo permite establecer que todos los compuestos son isoestructurales y cristalizan en el grupo espacial monoclínico P12₁1 (N° 4). Las constantes de red calculadas a partir de los diagramas de polvo son mostradas en la Tabla 3.12.

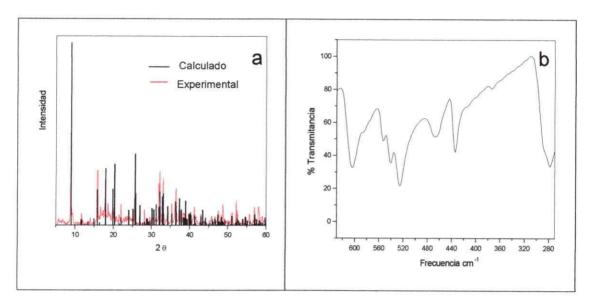


Figura 3.10. a) DRX de KBiP₂S₆; b) Espectro IR de KSbP₂S₆.

Tabla 3.12. Constantes de red de las fases AMP_2S_6

Fase	a (Å)	b (Å)	c (Å)	β (°)	V (Å ³)
KBiP ₂ S ₆	6.64(2)	7.45(3)	9.914(7)	92.3(4)	489.3
KBiP ₂ S ₆ [37b]	6.6200 (6)	7.4058 (7)	9.9002 (9)	92.108 (1)	485.0
KSbP ₂ S ₆	6.59(4)	7.67(5)	9.77(6)	92.1(5)	493.7
NaSbP ₂ S ₆	6.61(6)	7.66(7)	9.79(8)	92.2(5)	495.4
KSbP ₂ S ₆ [37c]	6.605 (1)	7.651 (2)	9.754 (2)	92.11 (3)	492.6

Los espectros infrarrojos fueron medidos entre 650 y 250 cm⁻¹ (Figura 3.10b). La Tabla 3.13 muestra los valores de número de onda y la respectiva asignación de las señales presentes en cada fase [52, 56].

Tabla 3.13. Bandas en el espectro infrarrojo^a en números de onda (cm⁻¹) de las fases KMP₂S₆ y NaSbP₂S₆ en estado sólido a temperatura ambiente (M = Bi, Sb).

KSbP ₂ S ₆	KBiP ₂ S ₆	NaSbP ₂ S ₆	Vibración
611 f 582 m 561 h 541 f 519 f	604 f 585 h 553 d 541 d 525 f	609 f 595 h 558 d 541 d 530 f	v _d (PS ₃)
461 d	467 m	457 d	ν(P-P)
437 m	434 f	434 d	δ(S-P-S)
397 h 372 md 340 md 309 f 297 md 281 f	373 md 278 f	375 md 280 f 254 d 226 m	δ(S-P-S) y ν(M-S)

a f : fuerte, m: media, d: débil, md: muy débil, h: hombro

El espectro infrarrojo de las fases KMP₂S₆ (M = Bi, Sb) y NaSbP₂S₆ muestra absorciones entre 611 y 519 cm⁻¹, asignadas al estiramiento degenerado de los grupos $v_d(PS_3)$, indicando la presencia de unidades tipo etano P₂S₆⁴⁻ en la estructura. Absorciones a 461 y 467 cm⁻¹ son asignadas a la deformación de los grupos $\delta(P-S-P)$. Absorciones bajo 400 cm⁻¹, son asignadas a modos de deformación (bending) de los grupos S-P-S y modos de vibración de los enlaces M-S (M = Bi, Sb) .

3.3.2. Seleniodifosfatos AMP₂Se₆ (A = Cu, Ag; M = Bi, Sb)

La indexación de los difractogramas de polvo de rayos X (DRX) muestra que las fases AMP_2Se_6 (A = Cu, Ag; M = Bi, Sb) pertenecen al grupo espacial C2/m. Los DRX indican que los compuestos son isoestructurales entre sí y presentan estructura tipo $Fe_2P_2S_6$ (Figura 3.11).

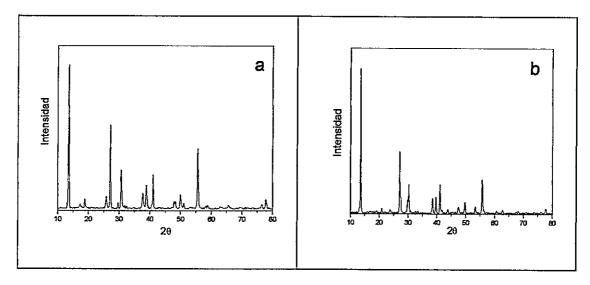


Figura 3.11. DRX de la fase: (a) CuBiP₂Se₆ y (b) AgSbP₂Se₆

Los valores de las constantes de red calculados a partir de los DRX y los datos cristalográficos de $Fe_2P_2S_6$ son informados en las Tablas 3.14 y 3.15, respectivamente. La indexación de los difractogramas se muestra en el Anexo 8.4.

Tabla 3.14. Constantes de red de las fases AMP₂Se₆

Fase	a (Å)	b (Å)	c (Å)	β(°)	V (Å*)
CuBiP ₂ Se ₆	6.19 (2)	10.73 (2)	6.94 (2)	107.46 (6)	439.37
AgBiP ₂ Se ₆	6.20 (2)	10.71(3)	6.90 (2)	107.20 (7)	437.55
CuSbP ₂ Se ₆	6.16 (2)	10.71 (4)	6.89 (2)	106.48 (6)	436.13
AgSbP ₂ Se ₆	6.20 (2)	10.73 (3)	6.90 (2)	107.34 (9)	437.88
CuCrP ₂ Se ₆ [41]	6.193 (3)	10.724 (2)	6.909 (4)	107.27 (4)	438.33

Tabla 3.15. Datos cristalográficos de Fe₂P₂S₆ [33].

Formula	A Company		Fe ₂ P ₂ S ₆		
Grupo espacial, Z			C2/m (N° 12),	2	
Sistema cristalino			Monoclínico		
a, Å			5.949(2)		
b, Å			10.288(3)		
c, Å			6.720(5)		
β			107.17(2)°		
Estructura			Tipo CdCl ₂		
Refinamiento			Monocristales		
Átomo	Sitio	x	у	z	Ocupación
Fe	4g	0.00	0.32288 (4)	0.00	1.0
P	4 j	0.0571(8)	0.00	0.1708(7)	1.0
S1	4 j	0.7508(6)	0.00	0.2474(8)	1.0
S2	8j	0.2481(4)	0.1659(7)	0.2479(3)	1.0

El espectro infrarrojo en la zona baja (Figura 3.12) muestra una fuerte absorción a 428cm⁻¹ en CuBiP₂Se₆; 430cm⁻¹ en AgBiP₂Se₆; 432cm⁻¹ en

CuSbP₂Se₆ y 429cm⁻¹ en AgSbP₂Se₆. Esta vibración puede ser asignada al estiramiento asimétrico $\nu(PSe_3)$ de los enlaces P-Se, indicando la presencia de unidades tipo etano [P₂Se₆]⁴⁻ [13b].

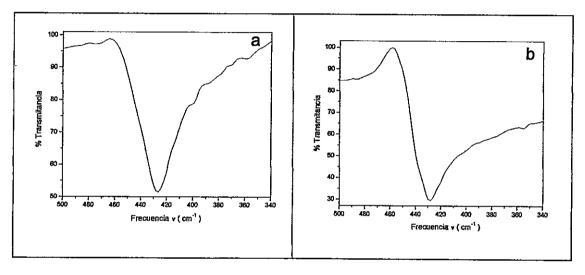


Figura 3.12. Espectro Infrarrojo de: (a) $AgSbP_2Se_6y$ (b) $AgBiP_2Se_6$.

3.3.2.1. Discusión estructural

La familia de compuestos AMP₂Se₆ presentan estructura bidimensional 2D con aniones calcofosfato tipo etano [P₂Se₆]⁴. La estructura consiste en láminas MP₂Se₆; donde los cationes metálicos A¹⁺ y M³⁺ poseen las mismas posiciones cristalográficas (Figura 3.13).

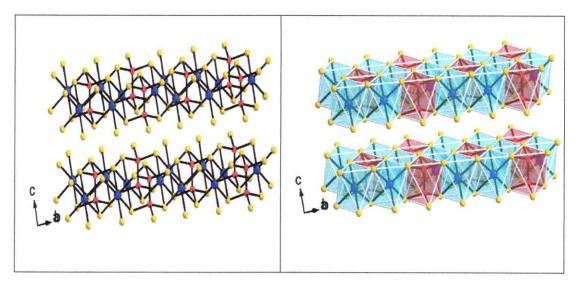


Figura 3.13. A la izquierda la estructura de AMP₂Se₆: • A^I y M^{III}; • P; • Se. A la derecha un representación poliédrica: Los átomos de selenio ocupan los vértices de los octaedros. Los pares P₂ se encuentran situados dentro de poliedros rojos; A^I y M^{III} se encuentran situados dentro de poliedros celestes (distribución estadística).

Estos compuestos pueden ser vistos como una sustitución del Fe^{2+} , en las láminas del compuesto $Fe_2P_2S_6$ (ver tabla 3.15), por los cationes A^{1+} y M^{3+} . La estructura puede ser descrita por láminas formadas por octaedros distorsionados de Se_6 ocupados alternadamente por cationes A^{1+} , M^{3+} y pares Fósforo-Fósforo P_2 (ver Figura 3.13).

El análisis de los DRX y de los espectros infrarrojos permiten afirmar que los metales A⁺¹ y M³⁺ se encuentran en la intralámina de las fases AMP₂Se₆ de estructura 2D. La distancia interlaminar 00l (Figura 3.14) de los compuestos AMP₂Se₆ (~6.6 Å), es comparable a la distancia 00l de los compuestos CuCrP₂Se₆ y Fe₂P₂S₆. Se ha observado que esta distancia aumenta cuando una especie huésped se encuentra ubicada entre las láminas de dichos compuestos.

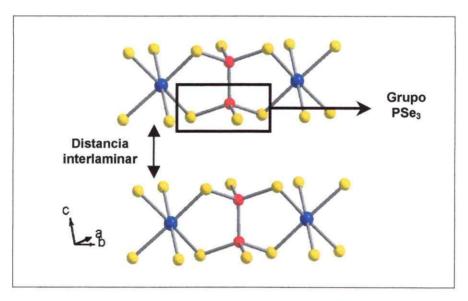


Figura 3.14. Láminas del compuestos AMP₂Se₆. A^I y M^{III}; P; Se. A la izquierda se indica la distancia interlaminar. A la derecha los grupos PSe₃.

Por su parte, el especto Infrarrojo muestra una señal asignada al estiramiento asimétrico vPSe₃ (ver Figura 3.14). Esta señal aparece desdoblada en dos o más grupos de absorción cuando las fases laminares presentan especies intercaladas. Por lo tanto, es posible postular que los metales A⁺¹ y M³⁺ no están intercalados, si no que se encuentran formando parte de las láminas, ocupando posiciones en la subred catiónica.

Fases cuaternarias de bismuto y antimonio informadas en literatura también poseen estructura laminar. Compuestos α,β -KMP₂Se₆ (M = Sb, Bi) presentan el catión K⁺ entre las láminas [MP₂Se₆]¹⁻ [55-56], y los compuestos Cs₈M₄(P₂Se₆)₅ (M = Bi, Sb) presentan el catión Cs⁺¹ en las láminas, formando túneles [57]. De acuerdo con nuestro conocimiento actual de literatura, estas fases 2D AMP₂Se₆ (A = Cu, Ag; M = Bi, Sb) son los primeros compuestos cuaternarios de Bi y Sb, que poseen metales de transición como catión A⁺¹.

3.4. Propiedades Magnéticas

Con la finalidad de confirmar los estados de oxidación en los compuestos AMP₂Se₆ (A = Cu, Ag; M = Bi, Sb), se realizaron medidas de susceptibilidad magnética en función de la temperatura. Los compuestos CuBiP₂Se₆, AgBiP₂Se₆ y AgSbP₂Se₆ muestran un comportamiento diamagnético. Este comportamiento magnético indica que el estado de oxidación de los metales de transición A (A = Cu, Ag) es +1 y el estado de oxidación de los metales M (M = Bi, Sb) es +3. Sin embargo, medidas magnética realizadas en el compuesto CuSbP₂Se₆, muestran un comportamiento paramagnético independiente de la temperatura (Figura 3.15).

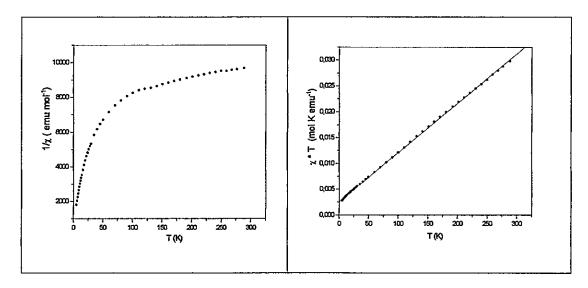


Figura 3.15. Susceptibilidad magnética versus temperatura para CuSbP₂Se₆.

El momento μ_{eff} calculado, utilizando la ecuación $\mu_{\text{eff}} = 2.828\,\sqrt{\chi_{_M}\,^*\,T} \; \text{, se muestra en la Tabla 3.16.}$

Tabla 3.16. Temperatura, χ_M y μ_{eff} para el compuesto CuSbP₂Se₆.

T(K)	χ _M (mol/emu)*10 ⁴	μ _{eff} (MB)
288,3	1,03	0,488
276,45	1,04	0,479
267,9	1,04	0,473
258,95	1,05	0,466
249,5	1,05	0,458
240	1,06	0,45
230,35	1,06	0,443
220,7	1,07	0,435
211,05	1,08	0,427
201,35	1,09	0,419
191,5	1,1	0,41
180,3	1,11	0,4
170,3	1,12	0,39
160,4	1,13	0,381
150,55	1,14	0,371
140,7	1,16	0,361
130,85	1,17	0,35
120,4	1,18	0,337
110,45	1,19	0,324
100,2	1,21	0,312
90,1	1,24	0,299
80,05	1,28	0,286
69,95	1,33	0,273

T(K)	χ _M (mol/emu)*104	μ _{eff} (MB)
59,85	1,4	0,259
49,69	1,49	0,243
44,92	1,55	0,236
39,94	1,62	0,227
35,02	1,71	0,219
29,99	1,88	0,212
27,98	1,93	0,208
25,99	1,99	0,204
23,99	2,07	0,2
21,99	2,17	0,195
20	2,29	0,191
18,01	2,43	0,187
15,99	2,61	0,183
14,01	2,83	0,178
13,01	2,97	0,176
12	3,12	0,173
10,99	3,3	0,17
10,01	3,51	0,168
9,01	3,76	0,165
7,99	4,07	0,161
7,01	4,44	0,158
6,01	4,92	0,154
5	5,52	0,149

Este comportamiento se puede atribuir a la presencia de Cu^{2+} en la red de Cobre. De esta manera, la red estaría compuesta de cationes Cu^{+} y Cu^{2+} . A partir del valor de μ_{eff} a 288,3 K se puede estimar que el porcentaje aproximado de Cu^{2+} es de un 28 %. Sin embargo, para tener una confirmación inequívoca de la presencia de Cu^{2+} , sería necesario realizar medidas de resonancia de espin electrónico (EPR).

3.5. Análisis Térmico

3.5.1. Compuestos KMP₂S₆

Para estudiar la estabilidad térmica y posibles transiciones de fases, se realizó análisis termogravimétrico (ATG) y análisis térmico diferencial (ATD). Los compuestos KBiP₂S₆ KSbP₂S₆ y NaSbP₂S₆ presentan curvas muy similares entre si (Figura 3.16).

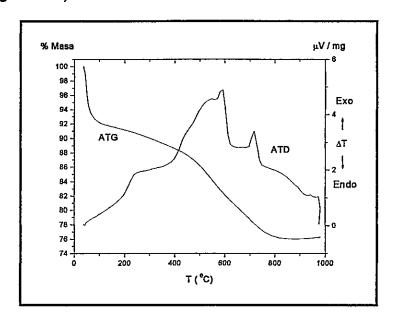


Figura 3.16. Curva análisis térmico simultáneo ATD-ATG del compuesto KBiP₂S₆

El Análisis térmico muestra la descomposición de los compuestos en dos pasos. El primer paso, entre 60°C y 120°C, corresponde a una pérdida de peso de aproximadamente 8% y el segundo paso a 435 °C, corresponde a una

pérdida de peso de aproximadamente 20%. La ecuación de descomposición es la siguiente:

$$2KBiP_{2}S_{6} \xrightarrow{\triangle} K_{2}S_{2} + Bi_{2}S_{3} + P_{4}S_{3} + 4S$$
$$2KSbP_{2}S_{6} \xrightarrow{\triangle} K_{2}S_{3} + Sb_{2}S_{3} + P_{4}S_{3} + 3S$$

Los DRX y análisis por microsonda EDX de los residuos, indican la presencia de los compuestos M_2S_3 , S y K_2S_y . El compuesto P_4S_3 fue confirmado por Espectroscopía IR y microsonda EDX.

3.5.2. Compuestos AMP_2Se_6 (A = Cu, Ag;M = Bi, Sb)

Los compuestos CuBiP₂Se₆, AgBiP₂Se₆, CuSbP₂Se₆ y AgSbP₂Se₆ presentan curvas ATG y ATD muy similares entre si (Figura 3.17).

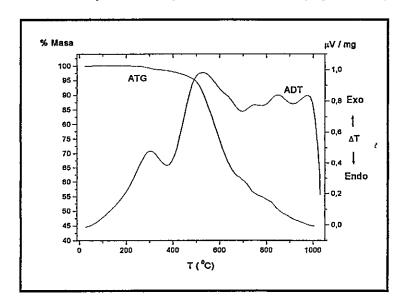


Figura 3.17. Curva análisis térmico simultáneo ATD-ATG del calcofosfato AgBiP₂Se₆.

El análisis térmico muestra la descomposición de los compuestos en dos pasos. El primer paso, entre 250°C y 400°C, corresponde a una pérdida de peso de aproximadamente 2% y el segundo paso a 523 °C, a una pérdida de peso de aproximadamente 50%. Las ecuaciones de descomposición son las siguientes:

$$2CuMP_2Se_6 \xrightarrow{\Delta} CuSe + Cu^0 + M_2Se_3 + P_4Se_3 + 5Se$$

 $2AgMP_2Se_6 \xrightarrow{\Delta} Ag_2Se + M_2Se_3 + P_4Se_3 + 5Se \qquad M = Bi,Sb$

Los DRX y análisis por microsonda EDX de los residuos, indican la presencia de los compuestos M_2Se_3 , Se, CuSe, Ag_2Se , y Cu. El P_4Se_3 compuesto fue confirmado por microsonda EDX.

3.6. Propiedades eléctricas

Se realizaron medidas de impedancia compleja, conductividad d.c y fotocorriente d.c. en función del tiempo y temperatura. Debido a que los compuestos absorben humedad del ambiente y varían sus valores de conductividad eléctrica, todas las medidas fueron realizadas desde 200°C hasta temperatura ambiente. El compuesto CuSbP₂Se₆ se descompone al aire (dos semanas) y en vacío a temperaturas sobre 130 °C.

Los compuestos cuaternarios AMP₂Se₆ (A = Cu, Ag; M = Bi, Sb) son semiconductores, con valores de conductividad σ del orden de $10^{-4}~\Omega^{-1}$ cm⁻¹ a temperatura ambiente. Este valor de σ es 10^5 veces mayor, que el valor de conductividad de los compuestos cuaternarios relacionados $Cs_8M_4(P_2Se_6)_5$ (M=Sb, Bi). El compuesto $Cs_8Sb_4(P_2Se_6)_5$ es aislante y el compuesto $Cs_8Bi_4(P_2Se_6)_5$ es semiconductor con σ = $10^{-9}~\Omega^{-1}$ cm⁻¹ a temperatura ambiente. De los resultados se observa que la presencia de los cationes Ag^+ y Cu^+ , en las fases AMP_2Se_6 , produce este gran aumento en la conductividad eléctrica.

Las medidas de impedancia compleja conducen a diagramas de Nyquist consistentes con semicircunferencias, sugiriendo distribuciones anchas en los tiempos de relajación. Medidas realizadas a temperaturas entre 12 y 200 °C muestran semicircunferencias para cada temperatura estudiada. La Figura 3.18

muestra los gráficos representativos de CuBiP₂Se₆ y AgBiP₂Se₆ a temperatura ambiente.

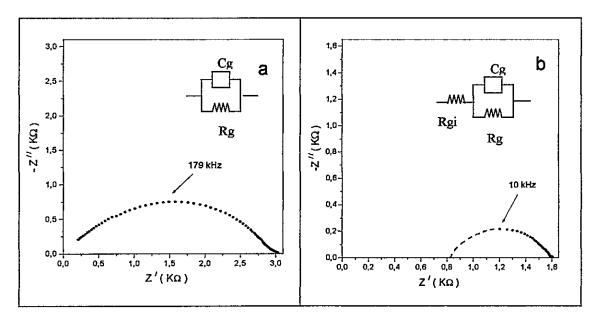


Figura 3.18. Diagrama de impedancia compleja y de Nyquit (a) $CuBiP_2Se_6$, (b) $AgBiP_2Se_6$, a temperatura ambiente.

La resistencia y capacitancia efectiva correspondiente a la semicircunferencia resultante se encuentra resumida en la Tabla 3.17.

Tabla 3.17. Resistencia y capacitancia calculadas para las curvas de Nyquist

Fase	Temperatura (K)	$R_{\mathfrak{g}}(\Omega)$	Cg (F)
CuBiP ₂ Se ₆	293	3040	3.01* 10 ⁻¹⁰
AgBiP₂Se ₆	288	R _{gi} :864, R _g :1593	7.10* 10 ⁻¹¹
CuSbP ₂ Se ₆	295	17890	1.93* 10 ⁻¹¹
AgSbP ₂ Se ₆	297	3125	3.20* 10 ⁻¹¹

Los valores de capacitancia efectiva sugieren que el proceso de conducción eléctrica, en los compuestos AMP_2Se_6 , es controlado por la frontera de grano. En el caso del compuesto $AgBiP_2Se_6$, el gráfico de Nyquist se encuentra desviado del origen. Este arco alcanza el máximo valor de impedancia Z", para el máximo de frecuencia disponible por el sistema experimental. La combinación de una resistencia R_{gl} en serie con una combinación de una resistencia (R_g) en paralelo con un elemento constante C_g , permite ajustar los datos experimentales. El valor de capacitancia efectiva indica un control intergranular. Sin embargo, el desplazamiento representado por R_{gi} sugiere la aparición de un segundo arco asociado a transporte intragranular, activo para frecuencias mayores al registro experimental (Tabla 3.17).

los compuestos medidas eléctricas d.c. de indican Las un fotoconductores. comportamiento materiales Los gráficos de de fotoconductividad en función del tiempo son mostrados en la Figura 3.19. Los conductividad a oscuras (σ_d) y fotoconductividad (σ_p) valores de son presentados en la Tabla 3.18.

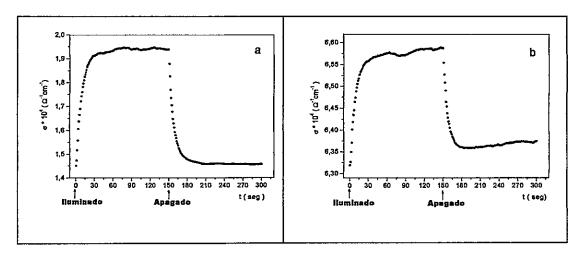


Figura 3.19. Conducción en función del tiempo para (a) CuBiP₂Se₆, (b) AgBiP₂Se₆

Tabla 3.18. Conductividad a oscuras (o) v fotoconductividad	(σ _P) a 303 K
--	-----------------------	---------------------------

Fase	σ _d (Ω (cm ⁻¹)	$\sigma_{\rm p}$ (Ω^{-1} cm ⁻¹)	σ_p/σ_d
CuBiP ₂ Se ₆	1.46 * 10 ⁻⁴	1.94 * 10-4	1.3
AgBiP ₂ Se ₆	6.34 * 10 ⁻⁴	6.59 * 10 ⁻⁴	~1.0
CuSbP ₂ Se ₆	4.56 * 10 ⁻⁵	5.96 * 10 ⁻⁵	1.2
AgSbP ₂ Se ₆	1.45 * 10-4	1.65 * 10 ⁻⁴	1.1

La fase $AgBiP_2Se_6$ presenta fotoconducción persistente después de retirar la fuente de iluminación. Este tipo de comportamiento de histéresis ha sido reportado en calcogenuros y compuesto de intercalación. Los compuestos AMP_2Se_6 con A=Cu muestran una razón σ_p / σ_d mas grande que los compuestos con A=Ag (ver Tabla 3.18).

La conductividad versus temperatura presenta diferentes comportamientos de Arrhenius (Figura 3.20). En todas las fases, la

conductividad aumenta cuando la temperatura aumenta. Este comportamiento indica que se trata de materiales semiconductores. Debido a la baja razón σ_p / σ_d de los compuestos CuSbP₂Se₆, AgBiP₂Se₆ y AgSbP₂Se₆; sólo fue posible determinar la dependencia de la fotoconducción respecto de la temperatura para la fase CuBiP₂Se₆. La fotoconductividad σ_p y conductividad a oscuras σ_d , son térmicamente activados en todo el rango de temperatura estudiado (ver Figura 3.20).

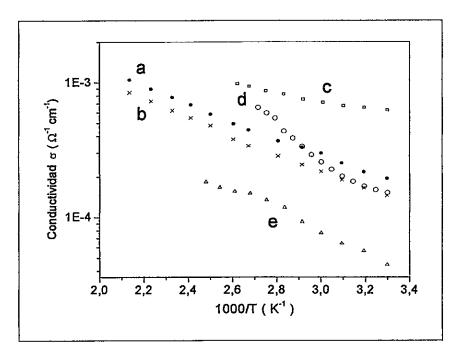


Figura 3.20. Dependencia de la temperatura de: (a) Fotoconductividad de $CuBiP_2Se_6$, (b) Conductividad a oscuras de $CuBiP_2Se_6$, (c) Conductividad a oscuras de $AgBiP_2Se_6$, (d) Conductividad a oscuras de $AgSiP_2Se_6$ y (e) Conductividad a oscuras de $CuSiP_2Se_6$

3.7. Cálculos Teóricos

Para la interpretación de la fotoconductividad y conductividad en los calcofosfatos cuaternarios AMP₂Se₆, se utilizaron esquemas de cálculo Huckel Extendido (EH) con el programa YAehMOP [62], basados en la estructura cristalina reportada para la fase CuCrP₂Se₆. La estructura de este compuesto, fue resuelta utilizando el método de Rietveld y es isoestructural con AMP₂Se₆ (Tabla 3.14). Los valores de constantes de red y posiciones cristalográficas son mostrados en la Tabla 3.19.

Tabla 3.19. Datos cristalográficos de CuCrP₂Se₆ [41].

Formula :			CuCrP ₂ Se ₆			
Grupo espac	ial, Z		C2/m (N° 12), 2			
Sistema cristalino			Monoclínico			
a, Å			6.193(2)			
b, Å			10.724(2)			
c, Å			6.909(9)			
β			107.2(7)°			
V, Å ³			690.9			
Rango 20			9° < 20 < 70°			
Refinamiento)		Método de Rietveld			
ωRp; R(l, h k	1)		8.6; 10			
Átomo	x	у	Z	Ocupación	U _{iso} (Å)	
Cu	0.00	0.3288 (5)	0.00	0.5	0.0674(9)	
Cr	0.00	0.3288 (5)	0.00	0.5	0.0674(9)	
Р	0.0538(2)	0.00	0.1537(6)	1.0	0.0204(2)	
Se1	0.7402(6)	0.00	0.2539(9)	1.0	0.0185(9)	
Se2	0.2486(5)	0.1722(2)	0.2503(2)	1.0	0.0257(5)	

El cálculo se realizó considerando una lámina de compuesto AMP₂Se₆ (Figura 3.21). Se escogió como fragmento representativo de la estructura la unidad presentada en la Figura 3.21b.

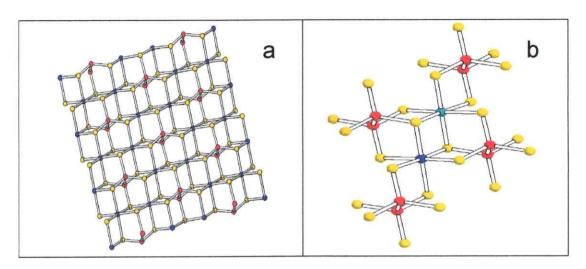


Figura 3.21. Estructura CuBiP₂Se₆: a) • Cu, Bi; • P • Se. b) Unidad básica.

En este esquema (Figura 3.22), la banda de valencia, en la cercanía del nivel de Fermi, esta compuesta de contribuciones de orbitales enlazantes (P-P),orbitales p no enlazantes (Se) y de orbitales p híbridos (P-Se). Los orbitales s del Bi y Sb, presentes en la banda de valencia, se encuentran a menor energía. En general, se puede establecer que para cada uno de los compuestos tipo AMP₂Se₆ la banda de valencia, en las cercanías del nivel de Fermi, esta formada por orbitales provenientes del anión calcofosfato P₂Se₆⁴⁻.

La banda de conducción, en la cercanía del nivel de Fermi, esta compuesta de contribuciones de orbitales s (Ag y Cu), orbitales antienlazantes (P-P) y orbitales p enlazantes (Se).

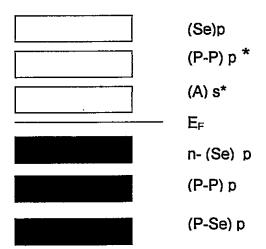


Figura 3.22. Esquema simplificado del diagrama de bandas de AMP_2Se_6 (A = Cu, Ag; M = Bi, Sb).

Este diagrama permite establecer que la presencia del Metal A en las fases AMP_2Se_6 es responsable de la conductividad eléctrica observada. La banda de conducción (LUMO) esta formada fundamentalmente por orbitales antienlazantes del metal A = Cu, Ag. Los orbitales S del bismuto no participan de los orbitales cercanos a la banda de valencia y conducción (LUMO y HOMO). La banda de valencia (HOMO) compuesta fundamentalmente por orbitales del anión $P_2Se_6^{4-}$ [37d]. Esto permite establecer que la presencia del metal de transición A, en la estructura de los compuestos, produce que el valor de σ es 10^5 veces mayor, que el valor de conductividad de los compuestos cuaternarios $Cs_8M_4(P_2Se_6)_5$ (M = Sb, Bi), estabilizados por el metal alcalino Cs^+ .

El compuesto $Cs_8Sb_4(P_2Se_6)_5$ es aislante y el compuesto $Cs_8Bi_4(P_2Se_6)_5$ es semiconductor con $\sigma = 10^{-9} \, \Omega^{-1} cm^{-1}$ a temperatura ambiente.

El fenómeno de fotoconductividad puede ser interpretado a partir del diagrama de bandas mostrado en la figura 3.22. La exposición a la luz de las muestras produciría huecos positivos en la banda de valencia y electrones en la banda de conducción, compuesta fundamentalmente por orbitales s vacíos del Metal A. Este fenómeno permitiría el aumento de la conductividad eléctrica cuando las muestras están iluminadas. Los centros libres en la banda de valencia (orbitales p enlazantes), actuarían como centros de recombinación de electrones y huecos positivos [76,77].

4 Fases $A_{1-3X}Bi_{1+X}P_2Se_6$ (A = Cu, Ag) y CuBi_{1-X}Sb_XP₂Se₆

Dada la analogía estructural de las fases tipo AMP₂Se₆ (A = Cu, Ag; M = Bi, Sb), así como la similitud de los radios iónicos de M³⁺ y A⁺, planteamos la posibilidad de preparar los compuestos tipo A_{1-3X}Bi_{1+X}P₂Se₆ y CuBi_{1-X}Sb_XP₂Se₆ por el método de síntesis a alta temperatura. Se estudiaron las condiciones de síntesis, características estructurales y propiedades eléctricas.

4.1. Síntesis

4.1.1. Compuestos $A_{1-3X}Bi_{1+X}P_2Se_6$ (A = Cu, Ag; x = 0.1)

La preparación de este tipo de compuestos se realizó por combinación directa de los metales A y Bi con un exceso de P₄Se₁₀ y Se. Esto permite que los metales reaccionen completamente y ayuda a la cristalinidad del material obtenido. Los precursores A y M fueron mezclados inicialmente en cantidades molares 0.7:1.1. P₂Se₅ y Se fueron agregados en el rango de razones molares 2-4:6-10. Por ejemplo, en un experimento típico se mezclo A/M/P₂Se₅ y Se en razón molar 0.7/1.1/2 y 8.

Los compuestos CuBiP₂Se₆ son formados a temperaturas entre 700 y 800 °C durante tres semanas. A esta temperatura es posible estabilizar el anión P₂Se₆⁴⁻ en fases que contienen los cationes Cu⁺ y M³⁺. Por lo tanto, la mezcla

4.1.2. Compuestos CuBi_{1-X}Sb_XP₂Se₆

Las soluciones sólidas fueron obtenidas por reacción de sus elementos puros en cantidades estequiométricas. Se agrega una exceso de Selenio y Fósforo (1% masa) para evitar la formación de impurezas (Cu₃PSe₄ y M₂Se₃). La mezcla de reacción es calentada hasta 750°C a una razón de 40°C/h. La temperatura fue mantenida a 750°C por 5 días y luego enfriada hasta temperatura ambiente a razón de 60 °C/h. Se obtiene material homogéneo luego de moler y calentar nuevamente a 750°C por una semana.

4.2. Análisis elemental y microscopía electrónica MEB-EDX

4.2.1. Compuestos $A_{1-3X}Bi_{1+X}P_2Se_6$ (A = Cu, Ag; x = 0.1)

Los productos de reacción fueron materiales en polvo policristalino y cristales. Muestras obtenidas de cuatro reacciones fueron prensadas y analizadas. Se realizó análisis general y puntual (30 adquisiciones por muestra). El análisis químico puntual y general (SEM-EDX) realizado en polvo policristalino y cristales seleccionados confirman pureza, homogeneidad y estequiometrías. Los resultados (promedio) del análisis elemental se muestra en la Tabla 4.1. Medidas de absorción atómica, confirman los contenidos ponderales obtenidos por EDX.

Tabla 4.1. Análisis Elemental de fases A_{0.7}Bi_{1.1}P₂Se₆

	Cristales	Cu _{0.7} Bi _{1.1} P ₂ Se ₆		
	Cu	Bi	Р	Se
% masa calculado	5.5	28.4	7.7	58.4
% Experimental	5.5 (4)	28.6 (6)	7.0 (5)	58.9 (3)
	Polvo policris	talino Cu _{0.7} Bi _{1.1} P ₂	Se ₆	
	Cu	Bi	Р	Se
% masa calculado	5.5	28.4	7.7	58.4
% Experimental	5.4 (3)	30.1 (2)	6.9 (9)	57.6 (11)
	Polvo policris	talino Ag _{0.7} Bi _{1.1} P ₂	Se ₆	
The state of the s	Ag	Bi	Р	Se
% masa calculado	9.0	27.3	7.4	56.3
% Experimental	8.7 (6)	29.0 (5)	7.1 (12)	55.2 (3)

Las imágenes de microscopía electrónica de electrones secundarios y de electrones retrodispersados indican distribución homogénea de Bismuto y Cobre en los compuestos obtenidos. Una imagen de la morfología observada del polvo policristalino se muestra en la Figura 4.1 Las imágenes muestran claramente que se trata de fases laminares.

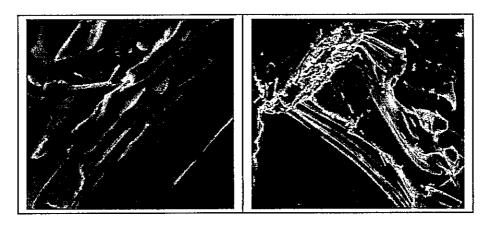


Figura 4.1. Imagen del material policristalino. A la Izquierda electrones secundarios de Ag_{0.7}Bi_{1.1}P₂Se₆. A la derecha electrones secundarios de Cu_{0.7}Bi_{1.1}P₂Se₆.

4.2.2. Compuestos CuBi_{1-x}Sb_xP₂Se₆

Los análisis de microscopía electrónica MEB-EDX confirman pureza y estequiometrías (Tabla 4.2). No es posible obtener soluciones sólidas puras con valores de $x \le 3$. Los productos con X > 3 son mezclas de soluciones sólidas CuBi_{1-x}Sb_xP₂Se₆, calcofofatos ternario, cuaternarios y compuestos binarios.

Tabla 4.2. Análisis elemental de CuBi_{1-X}Sb_XP₂Se₆

X	Estequimetria preparada	Producto
0.1	CuBi _{0.9} Sb _{0.1} P ₂ Se ₆	Cu _{1,10} Bi _{0.88} Sb _{0.14} P _{1.90} Se _{6.02}
0.2	CuBi _{0,8} Sb _{0,2} P ₂ Se ₆	Cu _{1,10} Bi _{0.80} Sb _{0.23} P _{1,80} Se _{6.02}
0.3	CuBi _{0.7} Sb _{0.3} P ₂ Se ₆	Cu _{1.03} Bi _{0.75} Sb _{0.34} P _{1.82} Se _{6.05}
0.4	CuBi _{0.6} Sb _{0.4} P ₂ Se ₆	Cu _{1.0} Bi _{0.71} Sb _{0.32} P _{1.8} Se _{6.0} + M ₂ Se ₃ + Cu ₃ PSe ₄
0.5	CuBi _{0.5} Sb _{0.5} P ₂ Se ₆	Cu _{0.9} Bi _{0.9} Sb _{0.94} P _{1.92} Se _{5.9} + M ₂ Se ₃ + Cu ₃ PSe ₄
0.8	CuBi _{0.2} Sb _{0.8} P ₂ Se ₆	Cu _{1.2} Bi _{0.82} Sb _{0.21} P _{1.88} Se _{6.4} + M ₂ Se ₃ + Cu ₃ PSe ₄

Una imagen de la morfología observada de polvo policristalino se muestra en la Figura 4.2. El análisis de microscopía electrónica de electrones secundarios y de electrones retrodispersados, permiten establecer que los compuestos con valores de $x \le 3$ son fases puras y homogéneas. Las imágenes ER indican una distribución homogénea de metales pesados.

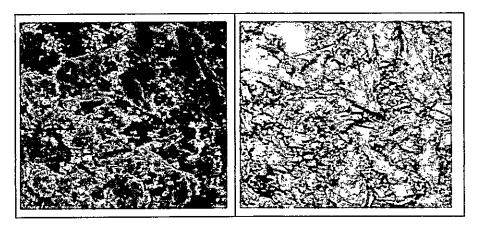


Figura 4.2. Imagen del material policristalino para la fase CuBi_{0.8}Sb_{0.2}P₂Se₆. A la Izquierda electrones secundarios. A la derecha electrones retrodispersados.

4.3. Caracterización estructural y vibracional

4.3.1. Compuestos $A_{1-3X}Bi_{1+X}P_2Se_6$ (A = Cu, Ag; x = 0.1)

Los diagramas de rayos X (DRX) muestran que las fases $A_{1-3X}Bi_{1+X}P_2Se_6$ son isoestructurales con $ABiP_2Se_6$ (Figura 4.3a). Los valores de las constantes de red calculados a partir de los DRX son informados en la Tabla 4.3. La indexación de los difractogramas se muestra en el Anexo 8.4.

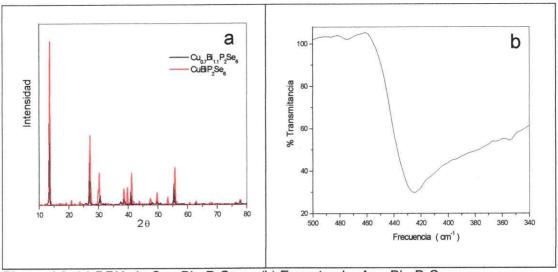


Figura 4.3. (a) DRX de Cu_{0.7}Bi_{1.1}P₂Se₆ y (b) Espectro de Ag_{0.7}Bi_{1.1}P₂Se₆

Tabla 4.3. Constantes de red de las fases A_{1-3X}Bi_{1+X}P₂Se₆

Fase	a (Å)	b (Å)	c (Å)	β (°)	V (Å ³)
Ag _{0.7} Bi _{1.1} P ₂ Se ₆	6.18 (4)	10.66(1)	6.89(1)	107.16 (6)	438.38
Cu _{0.7} Bi _{1.1} P ₂ Se ₆	6.18(1)	10.75 (1)	6.92 (2)	107.14 (5)	438.60
CuBiP ₂ Se ₆ [37d]	6.19 (2)	10.73 (2)	6.94 (2)	107.46 (6)	439.37

El espectro infrarrojo en la zona baja muestra una fuerte absorción a 430cm^{-1} en $\text{Cu}_{0.7} \text{Bi}_{1.1} \text{P}_2 \text{Se}_6$ y 426cm^{-1} en $\text{Ag}_{0.7} \text{Bi}_{1.1} \text{P}_2 \text{Se}_6$ (Figura 4.3b). Esta vibración indica la presencia de unidades tipo $[\text{P}_2 \text{Se}_6]^4$.

4.3.2. Compuestos $CuBi_{1-X}Sb_XP_2Se_6$ (X = 0.1, 0.2, 0.3)

Los difractogramas de rayos X (DRX) muestran que estas fases son isoestructurales entre sí (Figura 4.4a). Los valores de las constantes de red calculados a partir de los DRX son informados en la Tabla 4.4. La indexación de los difractogramas se muestra en el Anexo 8.4.

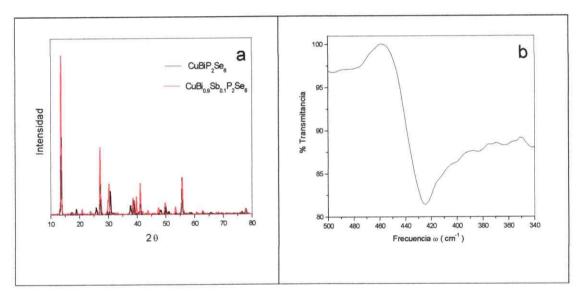


Figura 4.4. (a) DRX y (b) Espectro de la solución sólida CuBi_{0.9}Sb_{0.1}P₂Se₆.

Tabla 4.4. Constantes de red de las fases CuBi_{1-X}Sb_XP₂Se₆

Fase	a (A)	b (Å)	c (Å)	β (°)	V(A*)
CuBiP ₂ Se ₆	6.19 (2)	10.73 (2)	6.94 (2)	107.46 (6)	439.37
CuBi _{0.9} Sb _{0.1} P ₂ Se ₆	6.22(1)	10.73 (1)	6.93 (1)	107.17 (4)	442.18
CuBi _{0.8} Sb _{0.2} P ₂ Se ₆	6.23 (3)	10.74 (2)	6.94 (1)	107.02 (5)	444.01
CuBi _{0.7} Sb _{0.3} P ₂ Se ₆	6.21 (1)	10.72(1)	6.93 (2)	107.10 (3)	443.42
CuCrP ₂ Se ₆ [41]	6.193 (3)	10.724 (2)	6.909 (4)	107.27 (4)	438.33

El espectro infrarrojo en la zona baja muestra una fuerte absorción a 429 cm⁻¹ en CuBi_{0.9}Sb_{0.1}P₂Se₆; 430 cm⁻¹ en CuBi_{0.8}Sb_{0.2}P₂Se₆ y 427 cm⁻¹ en CuBi_{0.7}Sb_{0.3}P₂Se₆. Esta vibración indica la presencia de unidades tipo P₂Se₆⁴ (Figura 4.4 b).

4.3.3. Discusión estructural

La familia de compuestos $A_{1-3X}Bi_{1+X}P_2Se_6$ (A = Cu, Ag; x = 0.1) y $CuBi_{1-X}Sb_XP_2Se_6$ (X = 0.1, 0.2, 0.3) presentan estructura bidimensional 2D con aniones calcofosfato tipo etano $[P_2Se_6]^{4-}$. La estructura consiste en láminas $MP_2Se_6^{-}$, donde los cationes metálicos A^{1+} y M^{3+} poseen las mismas posiciones cristalográficas (Figura 4.5).

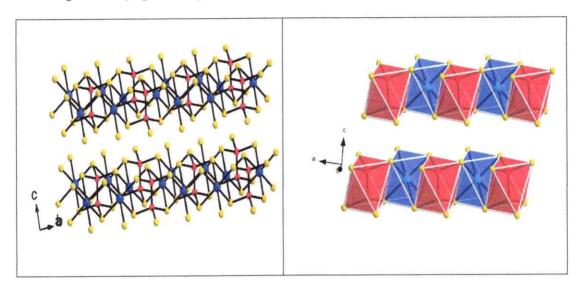


Figura 4.5. A la izquierda la estructura de CuBi_{1-X}Sb_XP₂Se₆. Cu¹ y M^{III}; P; Se. A la derecha un representación poliédrica: Los átomos de selenio ocupan los vértices de los octaedros. Los pares P₂ se encuentran situados dentro de poliedros rojos; A¹ y M^{III} se encuentran situados dentro de poliedros azules (distribución estadística).

Los compuestos $CuBi_{1-X}Sb_XP_2Se_6$ y $A_{1-3X}Bi_{1+X}P_2Se_6$ son isoestructurales con la fase $Fe_2P_2S_6$. Estos compuestos presentan estructura 2D y pueden ser vistas como una sustitución de Fe^{2+} , en las láminas del compuesto $Fe_2P_2S_6$, por los cationes Cu^{+1} , Bi^{3+} y Sb^{3+} .

El análisis de los DRX y de los espectros infrarrojos permiten afirmar que los metales A⁺¹ y M³⁺ se encuentran en la intralámina de la estructura 2D. La distancia interlaminar 00l (Figura 4.6) de los compuestos A_{0.7}Bi_{1.1}P₂Se₆ (~6.7 Å) y CuBi_{1-X}Sb_XP₂Se₆ (~6.8 Å) es comparable a la distancia 00l de los compuestos CuCrP₂Se₆ y Fe₂P₂S₆. Se ha observado que esta distancia aumenta cuando una especie huésped se encuentra ubicada entre las láminas de dichos compuestos.

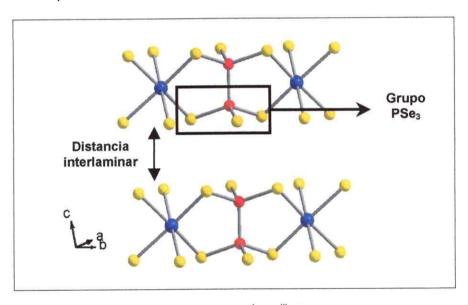


Figura 4.6. Láminas de CuBi_{1-X}Sb_XP₂Se₆: A^I y M^{III}; P; Se. A la izquierda se indica la distancia interlaminar. A la derecha los grupos PSe₃.

Por su parte, el especto Infrarrojo muestra una señal asignada al estiramiento asimétrico vPSe₃ (ver Figura 4.6). Esta señal aparece desdoblada en dos o más grupos de absorción cuando las fases laminares presentan especies intercaladas. Por lo tanto, es posible postular que los metales A¹⁺, Sb³⁺ y Bi³⁺ no están intercalados, si no que se encuentran formando parte de las láminas, ocupando posiciones en la subred catiónica.

Las fases $A_{0.7}Bi_{1.1}P_2Se_6$ presentan una deficiencia de cationes Cu^{+1} y un exceso de cationes Bi^{3+} , comparados con $ABiP_2Se_6$. Estas fases presentan espacios vacíos en la red, producto de la deficiencia de cationes Cu^{+1} . La fórmula química más adecuada para estos compuestos no-estequiométricos es $A_{0.7}Bi_{1.1}\square_{0.2}P_2Se_6$, donde \square representa los espacios vacíos (Figura 4.7).

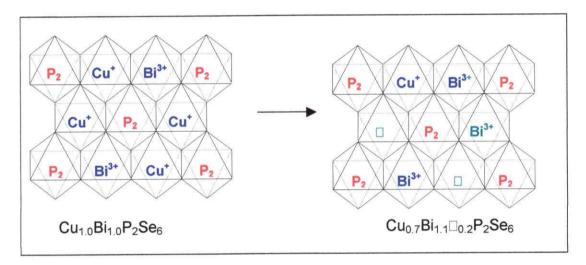


Figura 4.7. Representación de los compuestos no estequimétricos tipo $A_{0.7}Bi_{1.1}\Box_{0.2}P_2Se_6$. La incorporación de un catión Bi^{3+} en la red $Cu_{1.0}Bi_{1.0}P_2Se_6$; exige la salida de tres cationes Cu^+ para mantener electro neutralidad.

4.4. Análisis Térmico

4.4.1. Compuestos $A_{1-3X}Bi_{1+X}P_2Se_6$ (A = Cu, Ag; x = 0.1)

Para estudiar la estabilidad térmica y posibles transiciones de fases, se realizó análisis termogravimétrico (ATG) y análisis térmico diferencial (ATD). Los compuestos A_{1-3X}Bi_{1+X}P₂Se₆ presentan curvas muy similares a la familia AMP₂Se₆. El análisis térmico muestra la descomposición de los compuestos en dos pasos. El primer paso, entre 270°C y 400°C, corresponde a una pérdida de peso de aproximadamente 4% y el segundo paso a 400 °C, corresponde a una pérdida de peso de aproximadamente 30%. Los DRX de los residuos indican compuestos tipo M₂Se₃.

4.4.2. Compuestos $CuBi_{1-X}Sb_XP_2Se_6$ (X = 0.1, 0.2, 0.3)

Los compuestos CuBi_{1-X}Sb_XP₂Se₆ presentan curvas ATD/TG muy similares entre sí (Figura 4.8). El Análisis Térmico muestra la descomposición de los compuestos en dos pasos. El primer paso, entre 250°C y 400°C, corresponde a una pérdida de peso de aproximadamente 3% y el segundo paso, para 550 °C, corresponde a una pérdida de peso de aproximadamente 40%. Los DRX y análisis por microsonda EDX de los residuos, indican la presencia de los compuestos M₂Se₃, Se, Cu y CuSe. El compuesto P₄Se₃ fue confirmado por Espectroscopía IR y microsonda EDX.

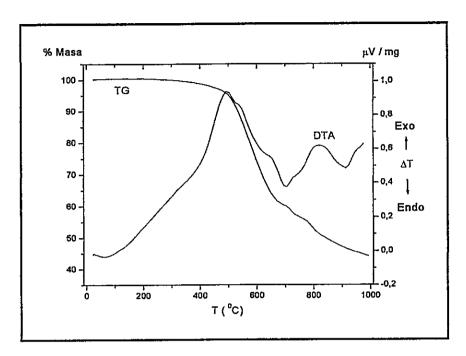


Figura 4.8. Curva análisis térmico simultáneo DTA-TG del calcofosfato CuBi_{1-X}Sb_XP₂Se₆

4.5. Propiedades Eléctricas

4.5.1. Compuestos $A_{1-3X}Bi_{1+X}P_2Se_6$ (A = Cu, Ag; x = 0.1)

Medidas de impedancia compleja (a.c.) a temperatura ambiente, conducen a diagramas de Nyquist consistentes en semicircunferencias. Las medidas a corriente directa (d.c.), muestran curvas intensidad-voltaje (i-v) que presentan comportamiento de Ohm (Figura 4.9). El compuesto $Cu_{0.7}Bi_{1.1}\square_{0.2}P_2Se_6$ es semiconductor con σ =1.39*10⁻⁴ Ω -1cm⁻¹ y el compuesto $Ag_{0.7}Bi_{1.1}\square_{0.2}P_2Se_6$ es semiconductor con σ = 2.12*10⁻⁴ Ω -1cm⁻¹ a temperatura ambiente.

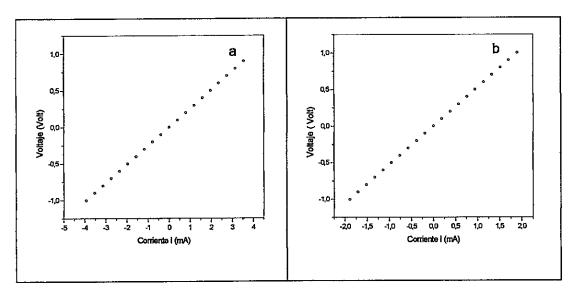


Figura 4.9. Curva Voltaje v/s intensidad de corriente (a) Cu_{0.7}Bi_{1.1}P₂Se₆, (b) Ag_{0.7}Bi_{1.1}P₂Se₆

El valor de resistencia eléctrica obtenido de las curva i-v coincide con el valor obtenido mediante impedancia compleja. Esto permite confirmar que la

conductividad eléctrica del material es electrónica, descartando contribuciones de conductividad iónica en el material. En el caso de que la contribución iónica fuese importante, en el diagrama de Nyquit aparecería una semicircunferencia a mayor resistencia Z´.

4.5.2. Compuestos CuBi_{1-X}Sb_XP₂Se₆

Medidas a corriente directa (d.c.) indican que los compuestos son semiconductores, con valores de conductividad σ del orden de 10^{-5} - 10^{-4} Ω^{-1} cm⁻¹ temperatura ambiente (Tabla 4.5). Estos valores de σ son 10^4 veces mayores que el valor de conductividad de los compuestos cuaternarios $Cs_8M_4(P_2Se_6)_5$ [57].

Tabla 4.5. Conductividad d.c. (σ_d) de CuBi_{1-X}Sb_XP₂Se₆ a 303 K

Fase	$\sigma_{a}(\Omega^1cm^1)$
CuBiP ₂ Se ₆	1.46 * 10 ⁻⁴
CuBi _{0.9} Sb _{0.1} P ₂ Se ₆	1.24 *10 ⁻⁵
CuBi _{0.8} Sb _{0.2} P ₂ Se ₆	1.57 *10 ⁻⁴
CuSbP ₂ Se ₆	4.56 * 10 ⁻⁵

Las medidas de impedancia compleja (a.c.) conducen a diagramas de Nyquist consistentes en semicircunferencias, sugiriendo distribuciones anchas en los tiempos de relajación. En la Figura 4.10 se presentan los gráficos representativos de CuBi_{0.9}Sb_{0.1}P₂Se₆ y CuBi_{0.8}Sb_{0.2}P₂Se₆ medidos a temperatura ambiente.

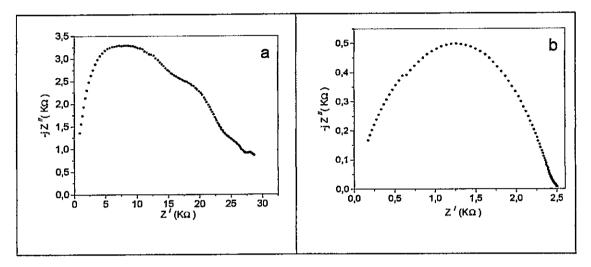


Figura 4.10. Diagrama de impedancia compleja de (a) $CuBi_{0.8}Sb_{0.2}P_2Se_6$ (b) $CuBi_{0.9}Sb_{0.1}P_2Se_6$

Por ajuste de elementos eléctricos discretos, es posible identificar la resistencia y capacitancia efectiva correspondiente a la semicircunferencia resultante para el compuesto CuBi_{0.9}Sb_{0.1}P₂Se₆. El comportamiento de este compuesto se ajusta a la combinación en paralelo de una resistencia y un elemento de fase constante (circuito simple). La resistencia obtenida es de R = 2.5 kΩ y la capacitancia es de Q = 0,42 nF. El valor de capacitancia efectiva sugiere que el proceso de conducción eléctrica es controlado por la frontera de grano. La curva de Nyquist de CuBi_{0.8}Sb_{0.2}P₂Se₆ se puede interpretar como una superposición de dos o más arcos consecutivos. La superposición de los arcos implica un alto grado de correlación con una gran cantidad de circuitos equivalentes. Este comportamiento no permite extraer

información respecto del mecanismo de conductividad eléctrica de esta solución sólida. Curvas intensidad-voltaje (i-v) a corriente directa muestran comportamiento de Ohm. El valor de resistencia eléctrica obtenido de las curva i-v coincide con el valor obtenido mediante impedancia compleja. Esto permite confirmar que la conductividad eléctrica del material es electrónica, descartando contribuciones de conductividad iónica en el material.

Las medidas eléctricas de las soluciones sólidas CuBi_{1-X}Sb_XP₂Se₆ muestran un aumento de la conductividad al aumentar el valor de x. La incorporación de antimonio en la red permite que los valores de conductividad eléctrica aumente en un orden de magnitud. Sin embargo, este valor no es superior a las fases límites CuBiP₂Se₆ y CuSbP₂Se₆.

5 Soluciones sólidas tipo $Bi_{1-x}Sb_xPQ_4$ (Q = S,Se)

Entre los calcofosfatos de Bi y Sb, con el anión calcofosfato PQ_4^{3-} informados en literatura, se encuentran las fases $BiPS_4$ y $A_3M(PS_4)_2$ (A = K, Rb, Cs; M = Sb, Bi) y $Cs_3Bi_2(PS_4)_3$. En la síntesis de estos compuestos se ha utilizado química exploratoria (mezcla fundente) para baja temperatura y métodos cerámicos para alta temperatura (transportador químico).

Dada la posibilidad de formación de soluciones sólidas de Bismuto y Antimonio, el objetivo del presente capítulo es el estudio de las condiciones de síntesis, características estructurales y propiedades eléctricas de compuestos tipo MPSe₄ (M = Bi, Sb) y Bi_{1-x}Sb_xPS₄.

5.1 Síntesis

5.1.1. Compuestos BiPSe₄ y SbPSe₄

La preparación de compuestos tipo MPSe₄ (M = Bi, Sb) se realizó por el método cerámico para alta temperatura (750-850°C) y mezcla fundente P_4Se_{10}/Se para temperaturas entre 450-500°C.

Se mezclaron inicialmente cantidades de Selenio en polvo, Fósforo rojo y Bismuto o Antimonio en polvo. Un resumen de las cantidades iniciales, temperatura, tiempo y productos obtenidos se muestran en la Tabla 5.1.

Tabla 5.1. Preparación de MPSe₄ (M = Bi, Sb) para alta temperatura. Cantidades molares iniciales de cada una de los reactivos y temperatura de reacción.

Se	* P **	₩. ₩. 79.4	Temp. (°C)	tiempo (días)	Producto
4.2	1.1	1.0	800	4	β -Bi ₄ (P ₂ Se ₆) ₃ + M ₂ Se ₃ + P ₂ Se _x
5.0	2.1	1.1	750	9	M ₂ Se ₃ + P ₂ Se _x
4.1	3.1	1.0	850	12	Sb ₄ (P ₂ Se ₆) ₃ + M ₂ Se ₃ + P ₂ Se _x
6.5	2.5	0.9	855	21	Sb ₄ (P ₂ Se ₆) ₃ + M ₂ Se ₃ + P ₂ Se _x

La mezcla fundente utilizada fue P₄Se₁₀/Se en diferentes proporciones. Se realizó un barrido de temperatura entre 250 y 550 °C. En ampollas de cuarzo selladas al vació (ver punto 2.1) se depositaron inicialmente cantidades de los precursores P₄Se₁₀, Se y M en diferentes proporciones (ver Tabla 5.2).

Tabla 5.2. Preparación de MPSe₄ (M = Bi, Sb) utilizando mezcla fundente. Cantidades molares iniciales de cada una de los reactivos y temperatura de reacción.

Se.	P ₄ Se ₁₀	*M.	Temp: (°C)	tiempo (días)	Producto
3.0	2.0	1.2	250	3	Sb ₄ (P ₂ Se ₆) ₃ , β-Bi ₄ (P ₂ Se ₆) ₃ + M ₂ Se ₃ + P ₂ Se _x
3.1	2.0	0.25	350	4	M ₂ Se ₃ + P ₂ Se _x + Se
0.0	5.0	0.50	520	6	Sb ₄ (P ₂ Se ₆) ₃ , β-Bi ₄ (P ₂ Se ₆) ₃
0.0	4.0	0.50	380	4	Sb ₄ (P ₂ Se ₆) ₃ , β-Bl ₄ (P ₂ Se ₆) ₃
2.2	6.0	0.25	450	5	M ₂ Se _z + P ₂ Se _x

El análisis al microscopio óptico y análisis MEB-EDX, permite establecer que se trata de mezclas heterogéneas. Los difractogramas de rayos X muestran

señales que son identificables con $Sb_4(P_2Se_6)_3$, β - $Bi_4(P_2Se_6)_3$ y M_2Se_3 . Para el rango de temperaturas estudiadas, se favorece la formación de fases ternarias respecto de fases binarias.

5.1.2. Compuestos Bi_{1-X}Sb_XPS₄

Los compuestos y soluciones sólidas $Bi_{1-x}Sb_xPS_4$ (X = 0.0, 0.10, 0.20, 0.30, 0.40, 0.50, 0.60, 0.70, 0.80 y 1.0) fueron preparados mediante dos procedimientos para alta temperatura. El primero, consiste en una reacción en (99.99%), cantidades puros en sólido de sus elementos estado estequiométricas, con un exceso de fósforo (1% masa) para evitar la formación de impurezas de M2S3. El segundo procedimiento, utiliza lodo (I2) como agente transportador (ver punto 2.1.1.b). En ambos casos, la mezcla de reacción es calentada a 750-800°C por una semana. Después que la reacción fue completada, los compuestos resultantes fueron enfriados lentamente hasta temperatura ambiente. Se obtiene un material homogéneo luego de moler y calentar, en ampollas de cuarzo a presión reducida, a 750°C por 2 semanas. Los materiales obtenidos por ambos procedimientos, fueron calentados a 300°C al vacío por 24 horas, para eliminar impurezas y lodo (I_2) .

5.2. Análisis elemental y microscopía electrónica MEB-EDX

Los análisis de microscopía electrónica MEB-EDX, confirman la formación de nuevos compuestos Bi_{1-X}Sb_XPS₄ para algunos valores de X. En la Tabla 5.3 se indican las estequiometrías de los productos obtenidos para los compuestos y soluciones sólidas.

Tabla 5.3. Estequiometrías de compuestos Bi_{1-X}Sb_XPS₄

X	Estequiometria γ	Producto
0.00	BiPS₄	Bi _{0,99} P _{0.95} S _{4.1}
0.10	Bi _{0.90} Sb _{0.10} PS ₄	Bi _{0.91} Sb _{0.13} P _{1.80} S _{6.02}
0.20	Bi _{0.80} Sb _{0.20} PS ₄	Bi _{0.83} Sb _{0.24} P _{1.82} S _{6.05}
0.30	Bi _{0.70} Sb _{0.30} PS ₄	Bi _{0.75} Sb _{0.34} P _{1.82} S _{6.05} + Bi _{0.88} P _{0.90} S _{4.4} + M _{2.1} S _{3.5}
0.40	Bi _{0.60} Sb _{0.40} PS ₄	Bi _{0.9} P _{0.94} S _{4.1} + M _{2.1} S _{3.5} + P ₂ S _z
0.50	Bi _{0.50} Sb _{0.50} PS ₄	Bi _{0.87} P _{0.88} S _{3.4} + M _{2.1} S _{3.5} + P ₂ S _z
0.60	Bi _{0.40} Sb _{0.60} PS ₄	Sb _{2.4} S _{2.9} + Bi _{1.8} S _{3.5} + P _{2.1} S _{3.5}
0.70	Bi _{0.30} Sb _{0.70} PS ₄	Bi _{1.1} P _{0.96} S _{4.4} + M _{2.0} S _{3.1} +Bi _{0.25} Sb _{0.74} P _{1.8} S _{5.9}
0.80	Bi _{0.20} Sb _{0.80} PS _{4.}	Bi _{0.85} Sb _{0.22} P _{2.0} S _{5.6} + Bi _{0.71} P _{1.3} S _{3.5} + M _{2.1} S _{3.5}
1.00	SbPS ₄	Sb _{2,2} S _{3,3} + P ₂ S _z + S

Cada uno de los productos de reacción fueron separados al microscopio óptico para su posterior identificación. En general, los productos S y P₂S_z son materiales en polvo de tonalidad amarilo-claro. Las fases Bi_{1-x}Sb_xPS₄ se presenta como material en polvo de color rojo oscuro ó negro-rojizo. La fase BiPS₄ se presenta como material en polvo de color rojo o cristales de hábito romboédrico. El sulfuro de antimonio Sb₂S₃ es un polvo policristalino de

tonalidad amarillo-naranja. El compuesto Bi₂S₃ se presenta como polvo policristalino de tonalidad plomo brillante.

Los productos de las reacciones entre Sb, P y S son mezclas (Figura 5.1). El diagrama de rayos X de estas fases, separadas utilizando microscopio óptico, corresponden a sulfuros de Antimonio (Sb_xS_y) .

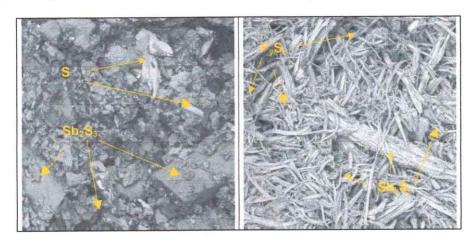


Figura 5.1. Imagen de electrones secundarios del material policristalino para la reacción entre Sb, P y S.

Análisis SEM-EDX y Espectros IR indican la presencia de compuestos P_yS_z . Es importante destacar que no es posible obtener soluciones sólidas puras con x > 2. Los productos son mezclas de $Bi_{1-X}Sb_XPS_4$, $BiPS_4$, M_xS_y y P_2S_z (Tabla 5.3).

5.3. Caracterización estructural y vibracional

Los diagramas de polvo de rayos X muestran que las soluciones sólidas con x<2 son isoestructurales con el compuesto BiPS₄ (Figura 5.2a). La indexación de los diagramas de polvo (anexo 8.4), permite establecer que estos compuestos son isoestructurales y cristalizan en el grupo espacial ortorrómbico lbca. Las constantes de red son mostradas en la Tabla 5.4.

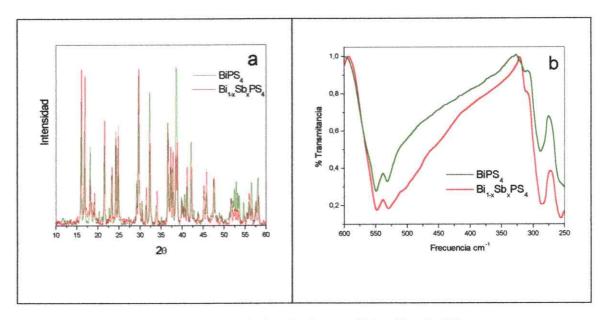


Figura 44. (a) DRX y (b) espectros IR de soluciones sólidas Bi_{1-x}Sb_xPS₄.

Tabla 5.4. Constantes de red de las fases Bi_{1-x}Sb_xPS₄

Fase	a (Å)	b (Å)	c (Å)	V (Å ³)
BiPS ₄	10.61(2)	11.11 (2)	19.67 (3)	2320.3
Bi _{0.9} Sb _{0.1} PS ₄	10.61(1)	11.12 (1)	19.68 (3)	2321.3
Bi _{0.8} Sb _{0.2} PS ₄	10.61(2)	11.15 (2)	19.71 (1)	2333.4
BiPS ₄ [78]	10.601(2)	11.112 (3)	19.661 (4)	2309.1 (1)

El espectro infrarrojo en la zona baja (Figura 5.2b), muestra fuertes absorciones a 547 cm⁻¹; 528 cm⁻¹; 289 cm⁻¹ y 255 cm⁻¹. Las absorciones a 547 cm⁻¹ y 528 cm⁻¹ son asignadas a estiramiento de P-S indicando la presencia de unidades PS₄³⁻ en la estructura [52, 56]. Absorciones bajo 400 cm⁻¹, son asignadas a modos de deformación ("bending") de los grupos S-P-S y modos de vibración de los enlaces M-S (M = Bi, Sb).

5.3.1. Análisis estructural

Soluciones sólidas tipo $Bi_{1-X}Sb_XPS_4$ poseen estructura tridimensional 3D y presenta unidades calcofosfato PS_4^{3-} coordinadas al catión Bi^{3+} . Su estructura puede ser descrita en términos de la fase $BiPS_4$ (Figura 5.3).

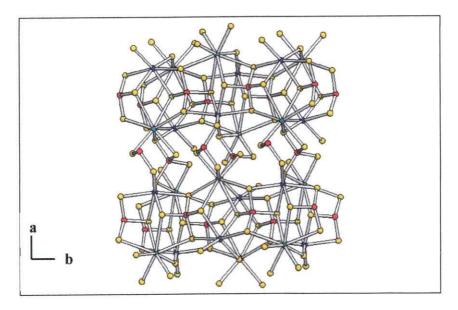


Figura 5.3. Estructura 3D BiPS₄. • BiS₆ • BiS₈ • P • S.

El catión Bi^{3+} posee dos sitios cristalográficos. Un sitio presenta coordinación octaédrica distorsionada BiS_6 y el otro sitio presenta coordinación BiS_8 (Figura 5.4). El antimonio forma compuestos calcofosfatos o calcogenuros, en donde su coordinación es SbS_6 . No se encuentra información en literatura de compuestos basados en Antimonio que posean coordinación mayor a seis. Además, al comparar los radios iónicos del Bi^{3+} (1.03 Å) y el Sb^{3+} (0.76 Å), se observa que el antimonio posee un tamaño menor al Bismuto, impidiendo la posibilidad de aumentar su coordinación de $SbS_6 \rightarrow SbS_8$.

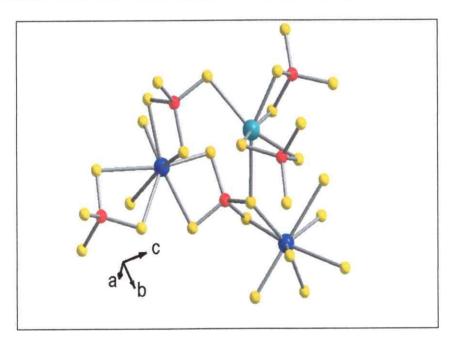


Figura 5.4. Unidades estructurales de BiPS₄. • BiS₆ • BiS₈ • P • S.

Por lo tanto, las soluciones sólidas tipo Bi_{1-X}Sb_XPS₄ pueden ser vistas como una sustitución parcial de las posiciones del Bi³⁺ (BiS₆), en coordinación octaédrica, por el catión Sb³⁺ en la red tridimensional BiPS₄.

5.4. Análisis Térmico

El análisis térmico muestra la descomposición de los compuestos en un paso. El diagrama muestra una pérdida de peso de aproximadamente 40% a 600°C. BiPS₄ descompone a 660 °C. Los DRX de los residuos indican la presencia de M₂S₃.

5.5. Propiedades Eléctricas

El compuesto BiPS₄ es semiconductor, con valor de conductividad σ del orden de $10^{-8}\,\Omega^{-1}$ cm⁻¹ a temperatura ambiente (Tabla 5.5).

Tabla 5.5. Conductividad y Energía activación en Bi_{1-X}Sb_XPS₄

σ a 300 K (Ω ¹ cm ⁻¹)	Rango temperatura (K) E _a / eV		
curas			
5.4 * 10 ⁻⁸	310 – 384	0.11	
< 10 ⁻¹²	_	_	
2.6 * 10 ⁻⁸	340 – 370	0.11	
10 * 10-10	310 – 384	0.16	
	5.4 * 10 ⁻⁸ < 10 ⁻¹² 2.6 * 10 ⁻⁸	5.4 * 10 ⁻⁸ 310 – 384 < 10 ⁻¹² – 2.6 * 10 ⁻⁸ 340 – 370	

Este valor de σ es 10^2 veces menor que el valor de conductividad de compuestos tipo $M_4(P_2Se_6)_3$ (M=Sb, Bi) informados en literatura. Los compuestos $Sb_4(P_2Se_6)_3$ y $Bi_4(P_2Se_6)_3$ son semiconductores con valores de

conductividad $\sigma = 10^{-7}~\Omega^{-1} \text{cm}^{-1}~y~10^{-6}~\Omega^{-1} \text{cm}^{-1}~a$ temperatura ambiente, respectivamente. El compuesto $\text{Bi}_{0.9}\text{Sb}_{0.1}\text{PS}_4$ es aislante, con valor de conductividad $\sigma < 10^{-12}~\Omega^{-1} \text{cm}^{-1}$ a temperatura ambiente. Las medidas eléctricas d.c. de los compuestos indican un comportamiento de materiales fotoconductores (Figura 5.5). Los valores de conductividad a oscuras (σ_d) y fotoconductividad (σ_D) son presentados en la Tabla 5.5.

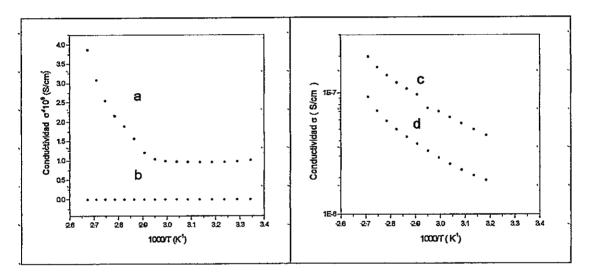


Figura 5.5. Conductividad a oscuras versus temperatura de: (b) Bi_{0.9}Sb_{0.1}PS₄ y (c) BiPS₄. Fotoconductividad versus temperatura de (a) Bi_{0.9}Sb_{0.1}PS₄ y (d) BiPS₄.

La fase BiPS₄ presenta valores de conductividad a oscuras mayores a los valores de fotoconducción. La fotoconductividad decae mientras la fase permanece iluminada. La fase Bi_{0.9}Sb_{0.1}PS₄ presenta valores de fotoconducción 10² veces mayores que los valores de conductividad a oscuras. Conductividad y fotoconductividad son térmicamente activados en el rango de temperatura estudiado.

6 Discusión

De acuerdo a los resultados experimentales presentados en esta tesis, complementados con los de literatura, se observa que los métodos de preparación de los compuestos de calcofosfato de Bismuto y Antimonio favorecen la formación de los aniones $[P_2Se_6]^{4-}$ y $[PS_4]^{3-}$. El anión $[P_2S_6]^{4-}$ esta presente sólo en la familia KMP₂S₆ (M = Bi, Sb). La inestabilidad de este anión se prueba por el comportamiento térmico de estas fases.

La preparación de las fases tiofosfato tipo AMP $_2$ S $_6$ (A = Li, Na, K; M = Bi, Sb), utilizando el método cerámico a alta temperatura, permite obtener nuevas fases KMP $_2$ S $_6$ (M = Bi, Sb) y NaSbP $_2$ S $_6$. Los productos de reacción con Li son compuestos ternarios y binarios del tipo M $_2$ S $_3$, BiPS $_4$, A $_2$ S $_2$ y P $_2$ S $_2$. Existen evidencias experimentales de la formación de compuestos cuaternarios NaSbP $_2$ S $_6$. Sin embargo, las pequeñas cantidades formadas y su baja estabilidad térmica impiden la caracterización estructural y física. Por otro lado, la utilización de mezcla fundente para estas estequiometrías, favorece la formación de los compuestos informados en literatura (BiPS $_4$, K $_3$ M(PS $_4$) $_2$ Na $_{0.16}$ Bi $_{1.28}$ P $_2$ S $_6$ y M $_2$ S $_3$).

En la búsqueda de nuevas fases con metales alcalinos, se intentó la preparación de la familia seleniofosfato AMP₂Se₆ (A = Li, Na, K; M = Bi, Sb). El

análisis de los productos de reacción, permitió establecer que se trata de mezclas heterogéneas (Figura 6.1).

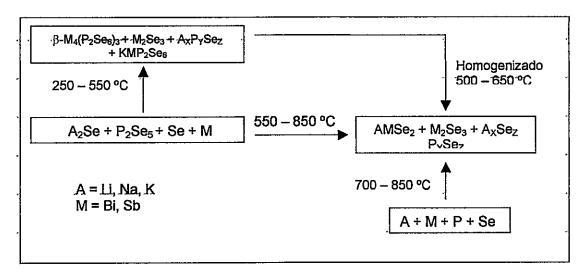


Figura 6.1. Esquema de la preparación de compuestos AMP₂Se₆

En los productos de reacción se identificó fases cuaternarias con estequiometrías tipo $KBiP_2Se_6$ y $NaSbP_2Se_6$ (determinadas por EDX). Los diagramas de polvo de Rayos x indican la formación de fases isoestructurales a los compuesto tipo α,β - $KBiP_2Se_6$. Sin embargo, no fue posible su completa caracterización por métodos espectroscópicos y de rayos X.

Debido a que no fue posible preparar seleniofosfatos de metales alcalinos, se intentó el reemplazo de los cationes Na⁺ y K⁺, por los cationes Cu⁺ y Ag⁺ que tienen radios iónicos semejantes.

Catión	Radio (Å)	Catión	Radio (Å)
Na⁺	0.98	Cu ⁺	0.98
K ⁺	1.33	Ag ⁺	1.26

Los productos de reacción de las fases tíofosfatos tipo AMP_2S_6 (A = Cu, Ag; M = Bi, Sb), fueron mezclas heterogéneas de compuestos binarios y ternarios (Figura 6.2).

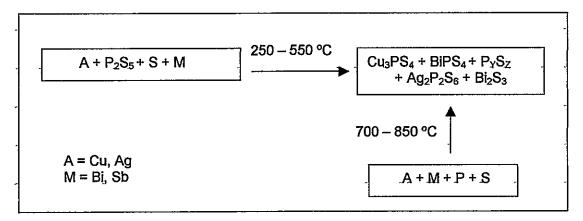


Figura 6.2. Esquema de la preparación de AMP₂S₆ (A = Cu, Ag; M = Bi, Sb).

Sin embargo, los productos de reacción para Q = Se permitieron la formación de una nueva familia de fases cuaternarias tipo AMP_2Se_6 (A = Cu, Ag; M = Bi, Sb).

Dada la analogía estructural de las fases tipo AMP_2Se_6 (A = Cu, Ag; M = Bi, Sb), así como la similitud de los radios iónicos de M^{3+} y A^+ , se extendió el método de síntesis a los compuestos tipo $A_{1-3x}Bi_{1+x}P_2Se_6$ y $CuBi_{1-x}Sb_xP_2Se_6$. Los resultados experimentales indican la formación de soluciones sólidas para valores de x<3.

Para la obtención de nuevas fases calcofosfato con el anión $[PQ_4]^{3}$, se intentó la preparación de compuestos tipo MPQ₄ (M = Bi, Sb, Q = S, Se). La síntesis de compuestos MPSe₄ se realizó por dos procedimientos (Figura 6.3).

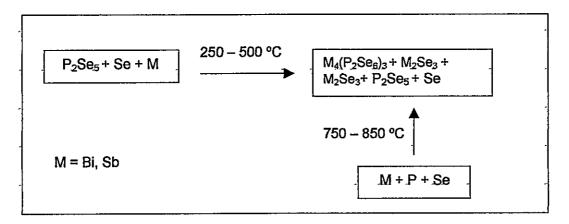


Figura 6.3. Esquema de la preparación de MPSe4

El análisis de los productos de reacción obtenidos por ambos métodos, indican que, los productos de reacción, se trata de mezclas heterogéneas de las fases $Sb_4(P_2Se_6)_3$, β - $Bi_4(P_2Se_6)_3$ y M_2Se_3 . Sin embargo, fue posible obtener nuevos compuestos para Q = S. La síntesis de fases tipo $Bi_{1-X}Sb_XPS_4$ se realizó a alta temperatura. El análisis de los productos de reacción indica la formación de soluciones sólidas tipo $Bi_{1-X}Sb_XPS_4$ (X = 0.10, 0.2, 0.3). Las reacciones entre las especies Sb, P y S son mezclas heterogéneas de sulfuros Sb_2S_3 y P_2S_z .

Fases estables de calcofosfatos con aniones tipo $[P_yQ_z]^{n-}$ pueden ser formadas por el método cerámico a alta temperatura (reacciones sólido-sólido o por transporte de vapor) y métodos a baja temperatura (solventotermales y mezcla fúndente). Bajo esas condiciones, se han observado especies tales como $[P_2Q_6]^{4-}$; $[P_2Q_6]^{2-}$; $[P_2Q_7]^{4-}$ y $[PQ_4]^{3-}$ (Q = S, Se). La información de literatura ha permitido proponer la existencia de complejos equilibrios en la formación de estos aniones calcofosfato (Figura 6.4).

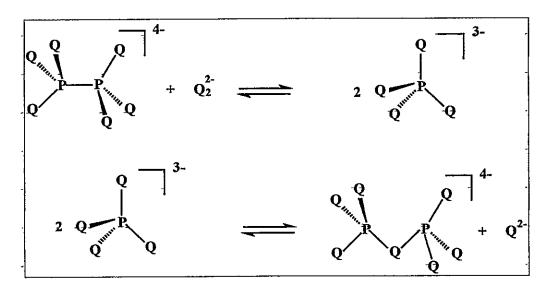


Figura 6.4. Equilibrios de formación entre diferentes aniones calcofosfato

Los resultados de la síntesis de los compuestos AMP_2Q_6 (A = Li, Na, K, Cu, Ag; M = Bi, Sb y Q = S, Se), permite establecer que en estos sistemas se favorece la formación de fases seleniodifosfato, respecto de las fases tiodifosfato. El equilibrio existente entre los aniones $[P_2Q_6]^{4-}$ y $[PQ_4]^{3-}$ (ver Figura 6.4), es desplazado a la formación del anión $[P_2Se_6]^{4-}$;

independiente del tamaño y naturaleza química del cation A^+ . Solo es posible obtener el anión $[P_2S_6]^{4-}$, presente en los compuestos KMP_2S_6 y $NaSbP_2S_6$, por utilización del método cerámico para alta temperatura. Sin embargo, esta familia de compuestos, son estables térmicamente hasta ~60 °C, indicando la inestabilidad a las redes calcofosfatos de Bismuto y Antimonio, cuando poseen en su estructura el anión $[P_2S_6]^{4-}$.

Los resultados de la síntesis de compuestos tipo MPQ₄ (M = Bi, Sb, Q = S, Se), permite establecer que en estos sistemas, se favorece la formación de fases tiofosfato, respecto de las fases seleniofosfato. El equilibrio existente entre los aniones $[P_2Q_6]^{4-}$ y $[PQ_4]^{3-}$ es desplazado a la formación de $[PS_4]^{3-}$; independiente del método utilizado en la formación de compuestos tipo MPQ₄.

Se observa que el método de síntesis utilizado influye en la formación de nuevos compuestos. De acuerdo, con los equilibrios de formación de los aniones calcofosfato (Figura 6.4), se puede establecer que el método para alta temperatura favorece la obtención de compuestos tales como AMP_2Se_6 , $A_{1-3x}Bi_{1+x}P_2Se_6$, $CuBi_{1-x}Sb_xP_2Se_6$ y KMP_2S_6 (A = Cu, Ag; M= Bi, Sb), estabilizados por aniones calcofosfato $[P_2Q_6]^{4-}$ (Q = S, Se). Sin embargo, el método de la mezcla fundente y método a alta temperatura, permite la preparación de una serie de compuesto, tales como, $A_3M[PS_4]_2$ (A = K, Rb, Cs; M = Sb, Bi), $Bi_{1-x}Sb_xPS_4$ y $Cs_3Bi_2[PS_4]_3$, estabilizados por el anión $[PS_4]^3$. En el

caso de las fases que poseen metales alcalinos, sólo es posible su preparación por utilización de la mezcla $A_2S/M/P_2S_5/S$. Las fases $Bi_{1-X}Sb_xPS_4$ pueden obtenerse por ambos métodos de síntesis. Finalmente, se destaca que solo se ha observado la presencia del anión $[P_2S_7]^{4-}$, en el compuesto $KBi[P_2S_7]$, utilizando mezcla fundente.

La estructura de los compuestos tipo AMP₂Q₆ se puede describir como octaedros unidos por las aristas formando láminas. Los octaedros MQ₆, AQ₆ y P₂Q₆ contienen en su interior el metal y el par de átomos de fósforo, respectivamente [61]. El par de átomos de fósforo se ubica, al interior del octaedro como se muestra en la Figura 6.5a. El átomo metálico se ubica al centro del octaedro (Figura 6.5b).

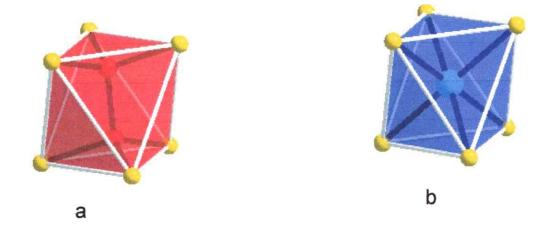


Figura 6.5. Estructura de los octaedros (a) P₂Q₆ y (b) MQ₆.

Los octaedros se encuentra perpendicular a las láminas y unidos por las aristas como se muestra en la Figura 6.6.

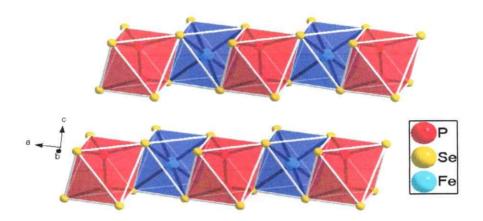


Figura 6.6. Estructura de los Fe₂P₂Se₆.

Las diferentes combinaciones de metales, en los compuestos calcofosfato, se puede explicar porque el octaedro P_2Q_6 puede sufrir una elongación o contracción trigonal si la distancia P-P aumenta o disminuye. De este modo, la unidad P_2Q_6 puede aumentar o disminuir la longitud de las aristas del octaedro para lograr unirse con el octaedro que contiene al metal. En el caso de los compuestos bimetálicos tipo MM $^\circ$ P $_2Q_6$ (M $^\prime$ = Ni, Mn, Cd, Fe, Ag; M = Ni, Fe, Cr, Ga y Q = S, Se) el octaedro P_2Q_6 se une a dos octaedros MQ $_6$ y M $^\prime$ Q $_6$ distintos, permitiendo la estabilización de las redes con Q = S, Se. Debido a que el octaedro formado por Bi y Sb es fuertemente distorsionado, se favorece la formación de calcofosfatos cuaternarios con las unidades P_2Se_6 . El

átomo de selenio, al ser más polarizable que el átomo de S, permite que los aniones P₂Se₆⁴⁻ se distorsionen adecuadamente para formar fases calcofosfato estables.

Otro factor importante en la estabilización de las redes Calcofosfato, es el radio iónico de los cationes A $^+$. El radio iónico del Li $^+$ es 0.6 Å, Na $^+$ es 0.98 Å, Cu $^+$ es 0.98 Å, Ag $^+$ es 1.28 Å y K $^+$ es 1.33 Å. La utilización de cationes pequeños (Li $^+$ y Na $^+$), en la preparación de fases seleniodifosfato, produce mezclas de calcofosfatos ternarios y calcogenuros binarios. El aumento del radio iónico de los cationes (Ag $^+$, K $^+$), permite la estabilización de nuevas redes calcofosfato tipo ABiP $_2$ Q $_6$ (A = Ag, K; Q = S, Se) . Las fases calcofosfato con el anión [P $_2$ Se $_6$] $^4-$ también son estabilizadas con Cu $^+$ (0.98 Å) y no con Na $^+$ (0.98 Å). Esto es posible de explicar debido a la naturaleza química y posibilidad de coordinación del catión Cu $^+$ (orbitales d).

Dada la analogía estructural entre las fases AMP₂Se₆ (A = Cu, Ag; M = Bi, Sb) y la similitud de los radios iónicos de los metales M^{3+} y A^+ (Cu⁺ 0.98 Å y Bi^{3+} 1.03 Å), se planteó la posibilidad de extender el método de preparación a una nueva familia de compuestos con estequiometrías $A_{1-3x}Bi_{1+x}P_2Se_6$ y $CuBi_{1-x}Sb_xP_2Se_6$. Bajo las condiciones experimentales utilizadas, fue posible preparar compuestos no estequiométricos tipo $A_{1-3x}Bi_{1+x}P_2Se_6$ (A = Cu, Ag; x = 0.1) y soluciones sólidas x = 0.10 y soluciones sólidas x = 0.11 y soluciones sólidas x = 0.12 Se₆ (x = 0.13 CuBi_{1-x}Sb_xP₂Se₆ (x = 0.14 CuBi_{1-x}Sb_xP₂Se₆ (x = 0.15 CuBi_{1-x}Sb_xP

condiciones de preparación son similares a las utilizadas en la familia AMP₂Se₆ (alta temperatura). Los productos de reacción para valores de x mayores a 0.3 son mezclas heterogéneas de fases ternarias y cuaternarias. Esto es debido a que en el tamaño del catión Sb³⁺ (0.76 Å) es menor al tamaño de los cationes Cu⁺ (0.98 Å) y Bi³⁺ (1.03 Å), impidiendo la estabilización de los octaedros de Se₆ en la estructura (Figura 6.6). La utilización de mezcla fundente no favorece la formación de soluciones sólidas homogéneas.

Las fases AMP_2Se_6 $A_{1-3X}Bi_{1+X}P_2Se_6$ y $CuBi_{1-X}Sb_XP_2Se_6$ poseen estructura bidimensional 2D relacionada con las fases $CuCrP_2Se_6$ y $Fe_2P_2S_6$. Estas fases presentan láminas tipo $MM'P_2Q_6$ (Q = S, Se), con átomos M hexacoordinados (M = Cu, Ag y M' = Cr y Bi) por el anión calcofosfato $[P_2Q_6]^4$.

Los compuestos KBiP₂S₆, KSbP₂S₆ y NaSbP₂S₆ son isoestructurales y están relacionados con los compuestos Na_{0.16}Bi_{1.28}P₂S₆ (3D), Cs₈M₄(P₂Se₆)₅ (2D) y β -KSbP₂Se₆ (2D). Las fases sólidas β -KMP₂Se₆ y KBiP₂S₆ poseen estructura laminar con capas de [MP₂Q₆]¹⁻ (Q = S, Se) y átomos de Bi hexacoordinados por aniones tipo [P₂Q₆]⁴⁻. Las láminas [BiP₂Q₆]¹⁻ se encuentran separadas por cationes K⁺. Las fases KBiP₂S₆ y Cs₈M₄(P₂Se₆)₅ poseen canales definidos por las láminas de la estructura. Sin embargo, los cationes Cs⁺ se encuentran ubicados en las láminas de los compuestos Cs₈M₄(P₂Se₆)₅. Este tipo de fases poseen una fuerte distorsión de la

coordinación de los cationes M^{3+} . Este tipo de comportamiento se explica debido a la influencia estereoquímica de los pares de electrones S^2 en la estructura. Finalmente, se destaca que las fases $Na_{0.16}Bi_{1.28}P_2S_6$, $NaSbP_2S_6$ y KMP_2S_6 (M=Sb,Bi), son los únicos compuestos cuaternarios informados en literatura, que poseen en su estructura aniones $[P_2S_6]^{4-}$ coordinados a los átomos de Sb y Bi.

La estructura de los compuestos AMP $_2$ Se $_6$ (A = Cu, Ag; M = Bi, Sb) y KMP $_2$ S $_6$ puede ser descrita por láminas formadas por octaedros distorsionados Q $_6$ (Q = S, Se), ocupados alternadamente por pares P $_2$ y átomos metálicos. Los cationes Cu $^+$ (0.98 Å), Bi $^{3+}$ (1.03 Å) y Sb $^{3+}$ (0.76 Å) ocupan posiciones dentro de los octaedros distorsionados de calcógeno Q $_6$. Sin embargo, el catión K $^+$ (1.33 Å) ocupa posiciones entre las láminas de los compuestos obtenidos. La utilización de cationes Cu $^+$ (0.98 Å) y Ag $^+$ (1.28 Å) de radio iónico menor al potasio, favorece la sustitución de posiciones cristalográficas en la red, respecto del espacio interlaminar.

La fase BiPS₄ es tridimensional 3D y presenta unidades calcofosfato PS₄³⁻ coordinadas al catión Bi³⁺. El cation Bi³⁺ posee dos sitios cristalográficos, uno con coordinación octaédrica distorsionada BiS₆ y el otro con coordinación BiS₆. Las soluciones sólidas Bi_{1-x}Sb_xPS₄ pueden ser vistas

como una sustitución parcial de las posiciones del Bi³⁺ en coordinación octaédrica (BiS₆), por el catión Sb³⁺, en la red tipo BiPS₄.

 AMP_2Se_6 , $A_{1-3X}Bi_{1+X}P_2Se_6$ y $CuBi_{1-X}Sb_XP_2Se_6$ son fases Las semiconductores, con valores de conductividad σ del orden de 10⁻⁴ $\Omega^{\text{-1}}\text{cm}^{\text{-1}}$ a temperatura ambiente. Este valor de σ es 10^5 veces mayor, que el valor de conductividad de los compuestos cuaternarios Cs₈M₄(P₂Se₆)₅ (M=Sb, Bi). Las medidas de impedancia compleja indican que el proceso de conducción eléctrica es controlado por la frontera de grano. El valor de resistencia eléctrica obtenido de las curva i-v coincide con el valor obtenido mediante impedancia compleja. Esto permite confirmar que la conductividad eléctrica del material es electrónica, descartando contribuciones de conductividad iónica en el material. Las medidas eléctricas d.c. de AMP₂Se₆ (A = Cu, Ag; M = Bi, Sb), indican un comportamiento de materiales fotoconductores. Cálculos Huckel Extendido (EH) permiten interpretar el comportamiento eléctrico. La banda de conducción de estos materiales está formada fundamentalmente por orbitales s no enlazantes del metal A (Figura 3.22). Este diagrama permite establecer que la presencia del cobre en las fases AMP2Se6 es responsable de la conductividad eléctrica observada. La banda de conducción (LUMO) esta formada fundamentalmente por orbitales antienlazantes del cobre. Los orbitales S del metal M no participan de los orbitales cercanos a la banda de valencia y conducción (LUMO y HOMO). Además, este diagrama permite dar una interpretación teórica al fenómeno de fotoconductividad. La exposición a la luz de las muestras produciría huecos positivos en la banda de valencia, compuesta fundamentalmente por orbitales p no enlazantes del Se y electrones en la banda de conducción, compuesta fundamentalmente por orbitales s vacíos del metal A. Los centros libres en la banda de valencia (orbitales p enlazantes), actuarían como centros de recombinación de electrones y huecos positivos. Un diagrama resumido de la estructura electrónica se encuentra en la Figura 3.22.

Las medidas eléctricas d.c. de los compuestos BiPS₄ y Bi_{0.9}Sb_{0.1}PS₄ indican un comportamiento de materiales fotoconductores. Estos materiales son aislantes eléctricos, con valor $\sigma\approx 10^{-8}~\Omega^{-1} \text{cm}^{-1}$ y $\sigma<10^{-12}~\Omega^{-1} \text{cm}^{-1}$ a temperatura ambiente, respectivamente. La fotoconductividad de la fase BiPS₄ decae mientras la fase permanece iluminada. Este fenómeno es debido a que la luz crea nuevos centros de recombinación y trampas en el material, de modo que los electrones foto generados se recombinan o quedan atrapados en bandas intermedias.

7 Conclusiones

La síntesis por el método a alta temperatura y mezcla fundente permite la obtención de fases puras AMP_2Se_6 (A = Cu, Ag; M = Bi, Sb), KMP_2S_6 (M = Bi, Sb), $NaSbP_2S_6$, soluciones sólidas $A_{1-3X}Bi_{1+X}P_2Se_6$ (A = Cu, Ag), $CuBi_{1-X}Sb_XP_2Se_6$ y $Bi_{1-X}Sb_XPS_4$. La estabilidad termodinámica de compuestos ternarios y binarios no permite la formación de compuestos puros tipo $SbPS_4$, $MPSe_4$ (M = Bi, Sb), $LiMP_2Q_6$ (M = Bi, Sb y Q = S, Se) y AMP_2S_6 (A = Cu, Ag; M = Bi, Sb).

La familia de compuestos AMP_2Se_6 (A= Cu, Ag; M = Bi, Sb), $A_{1-3\times}Bi_{1+\times}$ P_2Se_6 (A = Cu, Ag) y $CuBi_{1-\times}Sb_{\times}P_2Se_6$ presentan estructura 2D con el ligando calcofosfato tipo etano $[P_2Se_6]^4$. La estructura de esta familia de compuestos esta relacionada con el compuesto laminar $Fe_2P_2S_6$ (tipo monoclínico l).

Los compuestos KMP₂S₆ (M = Bi, Sb) presentan estructura bidimensional 2D con ligándos calcofosfato tipo etano $[P_2S_6]^{4-}$. Su estructura está relacionada con las fases Na_{0.16}Bi_{1.28}P₂S₆, Cs₈M₄(P₂Se₆)₅ y β -KMP₂Se₆ (M = Sb,Bi).

Las soluciones sólidas Bi_{1-X}Sb_XPS₄ tienen estructura tridimensional 3D y presenta unidades calcofosfato PS₄³⁻ coordinadas al catión Bi³⁺. Las soluciones

sólidas Bi_{1-X}Sb_XPS₄ pueden ser vistas como una sustitución parcial de las posiciones del Bi³⁺ (BiS₆), por el catión Sb³⁺, en el compuesto BiPS₄.

Los compuestos AMP₂Se₆ (A= Cu, Ag; M = Bi, Sb), $A_{1-3x}Bi_{1+x}$ P₂Se₆ (A = Cu, Ag) y CuBi_{1-x}Sb_xP₂Se₆ son semiconductores, con valores de conductividad σ i del orden de 10^{-4} Ω^{-1} cm⁻¹ a temperatura ambiente. Las medidas eléctricas d.c. de los compuestos indican un comportamiento de materiales fotoconductores.

El compuesto BiPS₄ es semiconductor, con valor de conductividad σ del orden de 10⁻⁸ Ω^{-1} cm⁻¹. Bi_{0.9}Sb_{0.1}PS₄ es aislante, con valor de conductividad $\sigma < 10^{-12} \ \Omega^{-1}$ cm⁻¹ a temperatura ambiente. Las medidas eléctricas d.c. de los compuestos indican un comportamiento de materiales fotoconductores.

8.1 Impedancia Compleja

El método de espectroscopia de impedancia compleja [64], permite obtener información respecto a los procesos de transporte eléctrico en las fases sólidas, consiste en la medida de la respuesta de un sistema a la aplicación de una señal eléctrica sinusoidal de pequeña amplitud en un amplio dominio de frecuencias ω (10⁻³ - 10⁶ Hz). La respuesta obtenida consiste en otra señal sinusoidal de igual periodo, pero de distinta amplitud y ángulo de fase. La relación entre ambas señales define totalmente la impedancia (Z) a una frecuencia dada.

La representación cartesiana del vector de impedancia será Z=Z'+Z''j, donde j es la parte imaginaria $(-1)^{1/2}$, $Z'=\cos\phi$ y $Z''=\sin\phi$ y ϕ corresponde al ángulo de la fase.

Para estudiar la variación de la impedancia compleja en función de la frecuencia se hace necesario el estudio de los diagramas de Nyquist, que consisten en la representación gráfica de la parte imaginaria de la impedancia Z" (eje de las ordenadas) frente a la parte real Z' (eje de las abcisas), para las diferentes frecuencias. A partir de estos diagramas se pueden obtener parámetros electroquímicos de las muestras estudiadas.

Para analizar la variación de la impedancia con la frecuencia conviene representar el sistema en estudio mediante un modelo integrado por elementos eléctricos ideales, que describan con gran aproximación el comportamiento de este. El modelo propuesto es el que se conoce como circuito equivalente. Generalmente en el caso de los sólidos, el circuito básico tipo Randles esta constituido por una resistencia (R_i) y un condensador (C_g) en paralelo (Figura 8.1 b), al cual le corresponde un diagrama de Nyquist como el que se observa en la figura 8.1 a.

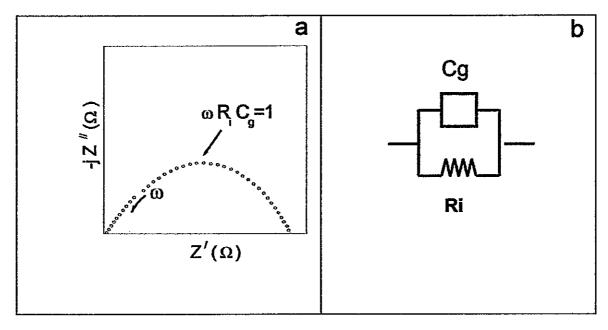


Figura 8.1. (a) Diagrama de Nyquist y (b) circuito equivalente para un circuito tipo Randles.

Puede demostrarse que en el caso de un circuito tipo Randles, la expresión matemática para la impedancia compleja para la parte real Z' es:

$$Z'(\omega) = R_i / (1 + \omega^2 \times C_0^2 \times R_i^2)$$

Y para la parte imaginaria Z"

$$Z''(\omega) = (\omega \times C_g \times R_i^2) / (1 + \omega^2 \times C_g^2 \times R_i^2)$$

Donde

ω es la frecuencia

Ri es la resistencia óhmica del material

C_a es la capacidad del mismo

i es el número imaginario (-1)1/2

Si la capacidad asociada a un arco presenta una magnitud del orden de 10^{-12} Faradios, esta se asocia al transporte intragranular de la señal eléctrica a través del material. Para valores en el rango de $10^{-8} - 10^{-10}$ se asocia a transporte intergranular, es decir a las fronteras del grano. Si la capacidad es del orden de $\sim 10^{-4}$ Faradios la semicircunferencia se asocia a reacciones electroquímicas entre el material y el electrodo [65].

8.2 Fotoconductividad

La absorción de la luz por un sólido es un proceso cuántico en el cual los electrones son elevados a níveles de energía superiores. Es común que esto lleve a una mayor conductividad, en particular cuando los electrones son excitados desde estados localizados hasta la banda de conducción, o desde una banda de valencia que está completa, hasta la banda de conducción. Los procesos que producen este fenómeno pueden ser la fotoexcitación, el bombardeo de rayos catódicos o la inyección eléctrica, pero en general las consideraciones se aplican indistintamente a todos ellos, puesto que lo que interesa es el aumento estacionario en las densidades de portadores libres y los tiempos de vida de los mismos, mediante los cuales se determinan dichos aumentos.

En la Figura 8.2, se muestra un diagrama esquemático general de densidad de estados, donde la línea continua representa los estados extendidos, es decir aquellos estados en los cuales el electrón puede moverse libremente y los localizados en las colas de las bandas en donde el electrón sólo puede desplazarse a través de un "hopping". La línea punteada representa una distribución continua de niveles de defectos e impurezas [66].

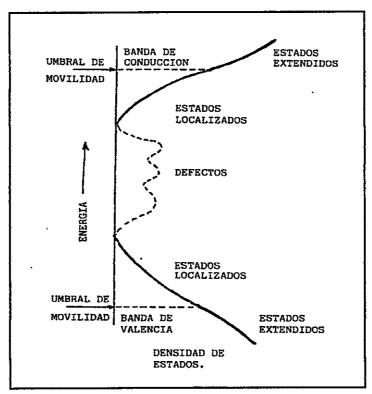


Figura 8.2. Diagrama esquemático de la densidad de estados de un semiconductor

Cuando los electrones son excitados a la banda de conducción desde la banda de valencia del fotoconductor, se generan densidades de electrones y huecos libres. La recombinación directa de estos electrones y huecos, normalmente es un proceso menos probable que su recombinación indirecta por medio de estados de defectos en el gap. Los últimos son generalmente más numerosos y tienen una mayor sección eficaz de captura para los portadores libres. Investigaciones sobre fotoconductividad han mostrado la validez semicuantitativa del modelo de un fotoconductor propuesto por Rose [67]. La esencia de este modelo es la existencia en el fotoconductor de dos tipos diferentes de centros de recombinación [68].

La fotoconductividad depende en gran medida de la densidad de estados en la banda prohibida. Si la densidad de estados es grande, los electrones fotogenerados no tienen tiempo de ser recogidos en los electrodos, pues su probabilidad de recombinación debido a los defectos es importante. La probabilidad de recombinación disminuye si también lo hace el número de defectos, pues la densidad de estados en el gap disminuye.

En el estudio de la fotoconductividad no suele hacerse diferencias entre materiales monocristalinos, policristalinos o amorfos. En la medida en que los electrones excitados tengan mas movilidad que aquellos no excitados, se puede esperar una respuesta fotoconductora y se pueden analizar los resultados en términos de una movilidad real o efectiva de los portadores excitados. Lo que se pretende decir con esto es que la existencia de una estructura de bandas, es decir una banda de valencia, una banda de conducción y una zona prohibida en la cual pueden existir impurezas, se puede obtener a partir de la proximidad de los átomos y de sus propiedades atómicas que no requieren necesariamente una distribución periódica de átomos.

Al estudiar la fotoconductividad se pueden considerar tres procesos a) la generación de pares electrón-hueco debida a una fuente externa b) el transporte de los portadores móviles, ya sea en los estados extendidos o localizados, y c) la recombinación del electrón y del hueco excitados.

Debido a la gran variedad de posibles procesos de atrapamiento y de recombinación en los semiconductores policristalinos, se han presentado multiples modelos para explicar los procesos de recombinación, los cuales incluyen distintas transiciones entre estados [69]. El desconocimiento existente sobre la probabilidad de las distintas transiciones hace que exista una notable controversia entre ellos.

La medida de la fotoconductividad en estado estacionario en función de la intensidad de la luz y de su dependencia con la temperatura, son técnicas de caracterización muy importantes, puesto que proporcionan una información muy útil acerca de los procesos de recombinación y de transporte en un semiconductor. Existen muchos estudios teóricos sobre fotoconductividad en estado estacionario en la literatura pero ninguno de ellos tiene una aceptación general [70-74].

El dispositivo experimental de medida (ver Figura 8.3) está controlado por un Computador Personal (PC), equipado con las interfaz IEEE-488 que controla el electrómetro programable Keithley modelo 617. Mediante esta interfaz el computador puede enviar órdenes al electrómetro, así como leer los datos medidos por el mismo.

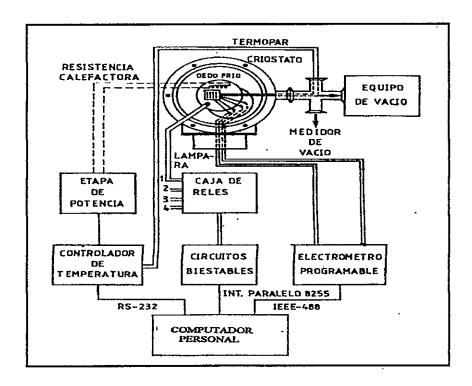


Figura 8.3. Sistema automático para medidas de corriente y fotocorriente en función de la temperatura

El electrómetro realiza las medidas de resistencia de la muestra, la que está colocada en la parte superior del disco de cobre del criostato. La temperatura de la muestra es medida por un controlador programable Philips, modelo KS 4580. En todo momento la muestra se encuentra dentro del criostato de acero inoxidable en el que existe un vacío de 10⁻³ atm. El criostato está provisto de una ventana de cuarzo en su tapa superior, que permite la entrada de la luz procedente de una lámpara halógena fría Doolan Jenner Fiberlite A3200, utilizada para las medidas de fotoconductividad. La conexión del dispositivo de medida con la muestra se realiza mediante 2 agujas de acero inoxidable insertadas en un trozo de teflón de forma semicircular. El encendido

y apagado de la lámpara es realizado automáticamente por una caja de relés controlada por la interfase paralelo PPI-8255, a través un conjunto de circuitos biestables.

El criostato consta de un sistema calefactor que permite calentar hasta 200 °C y enfriar hasta la temperatura de -170 °C. Por otra parte su extremo superior es el soporte de la muestra que se va a caracterizar la que queda situada dentro del criostato. Posee además una cavidad interior donde se aloja una resistencia calefactora. La medida de la temperatura sobre la muestra se hace mediante un termopar de tipo K. (cromel-alumel) en un rango de temperatura que va desde los 23 °C a los 70°C. Otro termopar de las mismas características conectado a un termómetro Fluke, modelo 51 K/J, se sitúa sobre el dedo de cobre para comprobar que no exista un gradiente de temperatura entre el dedo y la superficie de la muestra.

El computador controla los valores de temperatura y de los parámetros PID (proporcional-integral-diferencial), del controlador, y lee los valores actuales de temperatura a través de la interfaz serial RS-232C.

Para efectuar las medidas de fotocorriente de la muestra, los electrodos metálicos pueden tener dos estructuras posibles [75] la estructura coplanar, que es la más usada, con contactos óhmicos para medir fotocorrientes secundarias, y la estructura "sandwich", con contactos bloqueadores que es adecuada para medidas de la fotocorriente primaria, que es típica de la operación de las células solares.

8.3 Determinación de la estructura cristalina por difracción de rayos X en monocristales

Los rayos x son ondas electromagnéticas de longitud de onda corta, del orden de las distancias atómicas. Cuando los rayos x interactúan con la materia, ocurren varios fenómenos propios de las ondas electromagnéticas; entre los cuales se encuentra la difracción.

Para que exista la difracción de ondas en una red cristalina, se deben satisfacer determinadas condiciones geométricas, las que pueden describirse mediante las ecuaciones de Laue y de Bragg [79]. Bragg postuló que al encontrarse los rayos x con un plano del cristal, la difracción puede considerarse como una reflexión. La condicion de Bragg es:

$$n\lambda = 2d \, \text{sen} \, \theta \tag{1}$$

A longitud de onda constante λ , el ángulo θ es el que condiciona la geometría y así la difracción sólo depende de la distancia interplanar d. El ángulo de difracción θ está determinado por las características propias de la red.

La teoría de la difracción de rayos x establece que, a partir de las intensidades refractadas es posible determinar, bajo condiciones

adecuadas, el ordenamiento de los átomos al interior del cristal. La intensidad medida es proporcional al cuadrado de los factores de estructura F_{hkl} . Los factores de estructura están relacionados con el ordenamiento de los átomos en la celda unitaria. Sin embargo, la fase de la onda no puede obtenerse directamente de la medición.

La intensidad de la radiación difractada se ve influida por una serie de factores [80]. Los factores son los siguientes:

- a) Factor atómico (f): La capacidad de difracción de un átomo aumenta con el número de electrones que posee. Este factor es responsable de un debilitamiento de la intensidad total. Este debilitamiento depende del ángulo θ . Se considera f_0 , para un ángulo de 0° , igual al número atómico. Este factor disminuye cuando aumenta el ángulo θ .
- b) Factor de Temperatura (B): Los átomos en el cristal poseen vibraciones en sus posiciones. A consecuencia de estas vibraciones térmicas, se originan diferencias de fase entre las ondas difractadas y la intensidad total disminuye. De acuerdo a la teoría desarrollada por Debye y Waller, el factor atómico f_0 se corrige con un factor B dependiente de la temperatura. Si se consideran las vibraciones anisotrópicas, la expresión es la siguiente:

$$B = \left\{ 2\pi^{2} \begin{bmatrix} U_{11}h^{2}a^{*2} + U_{22}k^{2}b^{*2} + U_{33}l^{2}c^{*2} + 2U_{12}hka^{*}b^{*} + \\ 2U_{13}hla^{*}c^{*} + 2U_{23}klb^{*}c^{*} \end{bmatrix} \right\}$$
(2)

En esta expresión matemática a*, b* y c* corresponden a las constantes de la red recíproca, h k l a los índices de Miller y U_{ij} a las componentes anisotrópicas de las vibraciones térmicas.

c) Factor de Estructura (F_{hkl}): Las relaciones entre el ordenamiento de los átomos en un cristal y la intensidad de la radiación difractada son consideradas a través del factor de estructura F_{hkl} . Como la intensidad difractada es proporcional al cuadrado del factor de estructura, de las medidas experimentales es posible obtener el valor absoluto $|F_{hkl}|$, el que se designa como amplitud de estructura. El factor de estructura se obtiene como la suma de todas las ondas de los j átomos presentes en la celda unitaria y es igual a:

$$F_{hkl} = \sum_{j=1}^{N} f_{j} \exp \left[2\pi i \left(h x_{j} + k y_{j} + l z_{j} \right) \right] \exp \left[-B_{j} \left(\frac{\text{sen}\theta}{\lambda} \right)^{2} \right]$$
(3)

En esta expresión matemática, f_j corresponde al factor atómico del átomo j. Los valores de x,y,z corresponden a las coordenadas fraccionarias del átomo j en la celda unitaria.

Después de resuelto el problema de la fase, se dispone de un conjunto de parámetros que especifican la posición de cada átomo dentro de la celda unitaria. Ligeras variaciones en estos parámetros producirán variaciones en los factores de estructura calculados mediante la ecuación 3. El mejor grupo de parámetros es aquel que producirá los valores más precisos de las distancias

interatómicas y ángulos de enlace. Para esto se refinan las coordenadas atómicas y los factores de temperatura (ecuación 3). Se intenta obtener la mejor concordancia entre los factores de estructuras observados F_o y los valores calculados F_c . Para definir el grado de acuerdo de una estructura, se utilizan una serie de índices. El índice R1está basado en el cálculo de F:

$$R1 = \sum \left(\left| F_o \right| - \left| F_C \right| \right) / \sum F_o \tag{4}$$

wR2 y Goodnes of Fit (**GooF**), basados en el cálculo de F^2 y en factor de peso estadístico ω :

$$WR2 = \sqrt{\sum w (|F_o| - |F_o|)^2 / \sum w |F_o|^2}$$
 (5)

$$GooF = S = \sqrt{w(F_o^2 - F_c^2)/n - p}$$
(6)

n corresponde al número de reflexiones y p al número total de parámetros refinados. ω es un esquema de peso estadístico de los factores de estructura:

$$W = 1/[\sigma F_o^2 + aP^2]_{(7)} P = (F_O^2 + 2F_C^2)/3$$
 (8)

Un valor de R1 < 0.15 puede indicar una estructura o modelo estructural adecuado. Cuando los valores de R1 son cercanos a 0.04, los valores de wR2

a 0.1 y GooF es igual a 1, se puede establecer que la estructura está resuelta correctamente. Debido a que wR2 refina en F^2 , su valor es más grande (más del doble) que los índices basados en F. Es importante destacar que para establecer la correcta solución de la estructura, los parámetros mencionados anteriormente deben cumplir simultáneamente.

En el caso de que el grupo espacial sea quiral, la determinación de la configuración absoluta se realiza a través del parámetro de Flack y de wR2 calculado para cada isómero. El parámetro de Flack considera las contribuciones fraccionarias de cada isómero. La configuración absoluta se obtiene cuando el valor de wR2, para una de las configuraciones es el menor y el parámetro de Flack es igual a cero.

Los Valores de R_{int} y R_{sigma} permiten establecer la consistencia de los datos experimentales medidos. Estos índices se definen como:

$$R_{\text{int}} = \sum \left| F_o^2 - F_o^2 (promedio) \right| / \sum F_o^2$$
 (9)

$$R_{sigma} = \sum \left[\sigma F_o^2 \right] / \sum F_o^2 \tag{10}$$

Valores de R cercanos a 0.02 indican una buena correlación entre las intensidades medidas.

8.4 Datos Cristalográficos de KMP₂S₆ (M = Bi, Sb)

8.4.1 Posiciones cristalográficas de KMP₂S₆

Coordenadas atómicas y factor térmico equivalente a (A) de KBiP₂S₆

Átomo		On Party Man	No.	Ueq
Bi	0.7939(4)	0.7739(6)	0.9801(3)	0.02185(9)
К	0.7017(3)	1.0236(3)	0.5016(2)	0.0312(5)
P1	0.6876(3)	0.3148(2)	0.8258(2)	0.0147(5)
P2	0.7956(3)	0.5409(3)	0.7003(2)	0.0142(4)
S1	1.0521(3)	0.6229(3)	0.8071(2)	0.0194(4)
S2	0.5845(3)	0.7341(2)	0.7305(2)	0.0180(4)
S3	0.6585(3)	0.4287(3)	1.0136(2)	0.0193(5)
S4	0.9127(3)	0.1262(3)	0.8259(2)	0.0190(4)
S5	0.4251(3)	0.2268(2)	0.7458(2)	0.0203(5)
S6	0.8230(4)	0.4592(3)	0.5134(2)	0.0240(5)

El factor térmico equivalente isotrópico es definido como la traza de tensor ortogonalizado U_{ij}

Coordenadas atómicas y factor térmico equivalente a (Å) de KSbP₂S₆

Átomo		Y Y	The state of the s	Ueg 27
Sb	0.81740(3)	0.76783(2)	0.98199(2)	0.02255(7)
К	0.69550(13)	1.05338(14)	0.50699(9)	0.0332(2)
P1	0.69225(13)	0.34919(12)	0.82655(9)	0.01728(18)
P2	0.79569(14)	0.56782(12)	0.69610(9)	0.01875(19)
S1	0.67156(14)	0.46418(13)	1.01839(8)	0.0230(2)
S2	0.91096(14)	0.15923(13)	0.82753(10)	0.02313(19)
S3	0.42846(12)	0.26256(17)	0.74772(8)	0.02313(17)
S4	1.05469(14)	0.64376(13)	0.80623(10)	0.02364(19)
S5	0.58781(13)	0.75455(15)	0.73068(9)	0.02497(19)
S6	0.82713(15)	0.48435(15)	0.50784(10)	0.0286(2)

^a El factor térmico equivalente isotrópico es definido como la traza de tensor ortogonalizado U_{II}

8.4.2 Parámetros térmicos de KMP₂S₆

Factores térmicos anisotrópicos a (Å) de $KBiP_2S_6$

Átomo	JAUN WAR	U22	½, U ₃₃	Ujz	Uis	U23
Bi	0.0244(16)	0.0188(14)	0.0223(16)	-0.0048(18)	0.0009(11)	-0.0012(18)
K	0.0315(13)	0.0354(12)	0.0264(12)	0.0003(9)	-0.0014(10)	-0.0025(9)
P1	0.0172(10)	0.0139(12)	0.0130(10)	0.0005(7)	-0.0014(8)	-0.0003(7)
P2	0.0150(10)	0.0139(9)	0.0135(10)	0.0004(8)	-0.0017(8)	-0.0008(8)
S1	0.0145(10)	0.0231(10)	0.0194(11)	-0.0024(9)	-0.0010(8)	-0.0013(8)
S2	0.0212(10)	0.0185(13)	0.0210(10)	-0.0008(8)	-0.0048(8)	0.0043(8)
S3	0.0260(11)	0.0197(11)	0.0126(10)	-0.0015(8)	0.0015(9)	-0.0044(9)
S4	0.0187(11)	0.0153(9)	0.0199(11)	-0.0003(9)	-0.0028(9)	0.0016(8)
S5	0.0179(10)	0.0203(12)	0.0195(11)	-0.0004(8)	-0.0033(8)	-0.0050(7)
S6	0.0290(13)	0.0306(12)	0.0125(11)	-0.0020(9)	0.0017(9)	-0.0036(10)

^a Desviaciones estándar entre paréntesis y factores térmicos U_{ij}

Factores térmicos anisotrópicos a (Å) de KSbP₂S₆

Átomo	L'EUI	U22	U33	U12	U ₁₃	Uz
Sb	0.0247(12)	0.0193(11)	0.024(12)	-0.0024(12)	-0.0005(9)	-0.0014(12)
K	0.0300(5)	0.0380(5)	0.0314(5)	-0.0003(4)	-0.0020(4)	-0.0002(4)
P1	0.0176(5)	0.0174(4)	0.0167(4)	0.0009(4)	-0.0007(3)	-0.0019(4)
P2	0.0191(4)	0.0199(4)	0.0172(4)	0.0016(4)	-0.0001(3)	-0.0019(4)
S1	0.0297(5)	0.0219(4)	0.0174(5)	-0.0019(4)	0.0032(4)	-0.0062(4)
S2	0.0230(5)	0.0213(4)	0.0247(5)	-0.0015(4)	-0.0038(4)	0.0034(4)
S3	0.0194(4)	0.0263(4)	0.0233(4)	0.0011(5)	-0.0035(3)	-0.0057(5)
S4	0.0180(4)	0.0297(4)	0.0232(5)	-0.0025(4)	0.0002(4)	-0.0036(4)
S5	0.0251(4)	0.0226(4)	0.0268(4)	-0.0007(5)	-0.0041(3)	0.0045(5)
S6	0.0308(6)	0.0367(6)	0.0184(5)	-0.0030(4)	0.0023(4)	-0.0037(5)

Desviaciones estándar entre paréntesis y factores térmicos Uij

8.5 Diagramas de polvo calculados e Indexados

8.5.1 Diagrama de polvo calculado para KBi P_2 S₆. Grupo espacial Monoclínico $P^12_11(N^{\circ}4)$ Radiación Cu-K(α), 5.00 < 20 < 60.00

h	k	I	2 θ	d (Å)	VI ₀	h	k	1	2 θ	d (Å)	<i>l/l₀</i>
0	0	1	8,94	9.8935	100	-1	2	2	32,83	2,7277	15,7
1	0	0	13,38	6,6155	1,53	1	1	3	33,08	2,7076	17,49
0	1	1	14,94	5,9288	3,64	2	0	2	33,13	2,7041	11,48
-1	0	1	15,84	5,5953	19,51	1	2	2	33,39	2,6832	0,79
1	0	1	16,39	5,4082	1,53	-2	1	2	34,26	2,6171	10,27
0	0	2	17,93	4,9468	12,55	2	1	2	35,33	2,5401	6,54
1	1	Ó,	17,98	4,9337	31,19	0	0	4	36,32	2,4734	13,18
-1	1	1	19,89	4,4643	19,89	2	2	0	36,42	2,4669	3,98
1	1	1	20,33	4,3676	33,46	0	2	3	36,48	2,4627	10,84
0	1	2	21,6	4,1135	1	-2	2	1	37,32	2,4091	14,83
-1.	0	2	22,04	4,0335	4,18	0	3	1	37,55	2,3952	0,06
1	0	2	22,84	3,8936	0,03	-2	0	3	37,8	2,3796	0,96
Ω	.2	0.	24,03	3,7029	8,48	.2	.2	1	37,83	2,3783	8,74
-1	1	2	25,14	3,5422	8,96	0	1	4	38,37	2,346	4,47
0	2	1	25,69	3,468	39,33	-1	0	4	38,38	2,3452	0,25
1	1	2	25,85	3,4463	17,2	-1	2	3	38,66	2,329	4,18
2	0	0	26,95	3,3078	10,85	1	3	0	38,94	2,3128	13,6
0	0	3	27,04	3,2978	1,7	2	0	3	39,28	2,2936	3,58
1	2	0	27,61	3,2312	1,42	1	0	4	39,36	2,2893	0,81
-2	0	1	28,13	3,1724	1,9	1	2	3	39,39	2,2875	0,29
2	0	1	28,77	3,1029	3,69	-2	1	3	39,79	2,2655	6,13
-1	2	1	28,91	3,0879	3,5	-1	3	1	39,91	2,2586	6,05
1	2	1	29,23	3,0554	2,06	1	3	1	40,15	2,2457	7,12
2	1	0	29,58	3,0202	1,06	-1	1	4	40,34	2,2358	5,64
0	1	3	29,65	3,0126	2,39	-2	2	2	40,41	2,2322	2,46
-1	0	3.	.29,82	2,9958	0,14	_0_	.3	.2	40,85	.2,2088	0,21
0	2	2	30,15	2,9644	9,35	3	0	0	40,92	2,2052	0,75
-2	1	1	30,66	2,9161	8,61	2	1	3	41,2	2,1909	0,47
1	0	3	30,73	2,909	1	1	1	4	41,28	2,1872	5,62
2	1	1	31,25	2,8619	11,36	2	2	2	41,34	2,1838	4,65
-2	0	2	31,99	2,7976	10,06	-3	0	1	41,63	2,1694	1,31
-1	1	3	32,23	2,7772	18,52	3	0	1	42,32	2,1357	0,12
3	0	1	42,32	2,1357	0,12	-2	2.	4	51,6	1,7711	0,03
3	1	0	42,78	2,1135	1,48	-1	4	1	52,03	1,7577	1,47
-1	3	2	42,95	2,1056	5,3	1	4	1	52;22	1,7516	0,01

h	k	I	2 θ	d (Å)	l/I ₀	h	k	I	2 θ	d (Å)	<i>l/l</i> ₀
1	3.	2.	43,4	2,0849	8;66	3	1'	3	52,22	1,7516	1,61
-3	1	1	43,47	2,0819	2,2	3	2	2	52,24	1,7509	1,26
.0	2	.4	44,03	2,0567	2,53	.0	3	4	52,36	1,7472	0,89
3	1	1	44,13	2,0521	4,14	0	2	5	52,43	1,7452	3,78
-3	0	2	44,35	2,0422	1,3	0.	4.	2	52,79	1,734	2,56
-2	0	4	44,95	2,0167	0,74	-2	0	5	53,05	1,7263	0,02
-2	2	3	45,3	2,0019	1,6	2	2	4	53,15	1,7232	1,02
3	0	2	45,65	1,9871	0,44	-2	3	3	53,48	1,7132	0,2
-1	2	4	45,8	1,9813	0,58	-1	2	5	53,89	1,7011	1,85
0	0	5	45,86	1,9787	1,18	-1	3	4	53,92	1,7003	3,65
2	3	0	45,87	1,9784	3,38	-1	4	2	54,53	1,6826	1,54
0	3	<i>-</i> 3	45,92	41,9763	0,96	-2	.1	5	54,59	1,6812	4,54
-3	1	2	46,1	1,9688	1,79	2	3	3	54,62	1,6803	0,55
2	2	3	46,58	1,9499	3,86	1	3.	4	54,68	1,6786	4,27
-2	3	1	46,62	1,9482	0,98	-3	0	4	54,74	1,6769	1,04
-1	2	4	46,64	1,9472	0,59	1	2	5	54,84	1,6741	0,59
2	0	4	46,65	1,9468	3,45	1	4	2	54,91	1,672	1
-2 2	1.	4.	46,68	1,9459	2,85	2	Q	5	54,94	1,6712	0,72
	3	1	47,04	1,9318	0,67	-3	2	3	55,14	1,6657	2,64
3	1	2	47,36	1,9192	5,98	4	0	0	55,56	1,6539	0,07
-1	0	5	47,47	1,9152	1,3	0	0	6	55,75	1,6489	2,33
0	1	5	47,56	1,9116	2,19	3	3	0	55,91	1,6446	0,05
-1	3	3	47,74	1,9051	2,05	-4	0	1	56,04	1,6411	0,02
3	2	0	48,02	1,8946	1,59	-3	1	4	56,24	1,6355	0,37
.2	ា	4	48,34	1,8828	0,44	2	1	5	56,44	1,6302	0,68
1	3	3	48,35	1,8822	4,69	-3	3	1	56,47	1,6296	0,33
1∙	0	5.	48,5	1,8769	0	4	0	1	56,77	1,6216	0;2
-3	2	1	48,64	1,8718	2,36	3	2	3	56,8	1,6209	0,67
-3	0	3	48,83	1,8651	1,75	3	0	4	56,96	1,6167	0,08
-1	1	5	49,13	1,8542	0,66	2	4	0	57	1,6156	3,42
0	4.	Q	49,21.	1,8515	2,61.	3	3	1	57,02	1,6152	1,45
-2	3	2	49,22	1,851	2,01	0	4	3	57,04	1,6144	2,36
3	2	1	49,25	1,8501	2,09	4	1	0	57,06	1,6141	6,04
2	3	2	50,03	1,8231	0,36	-1	0	6	57,06	1,614	0,85
0	4	1	50,12	1,8199	1,3	0	1	6	57,24	1,6095	1,13
1	1	5	50,14	1,8193	1,58	-4	1	1	57,52	1,6022	3,29
-3	1	3	50,46	1,8086	0,26	-2	4	1	57,64	1,599	1,1
3	0	3	•	.1,8027	0,82	2	4	.1	58,01	1,5899	1,16
-3	2	2	51,07	1,7883	5,08	1	0	6	58,15	1,5863	0,06

8.5.1. Diagrama de polvo de $KBiP_2S_6$ (Continuación)

h	k	1	2 θ	d (Å)	I/I ₀
1	4	0	51,24	1,7829	0,49
4	1	1	58,24	1,584	2,71
3	1	4	58,43	1,5795	0,66
-1	1	6	58,53	1,5769	0,01
-1	4	3	58,61	1,5749	1,67
-3	3	2	58,67	1,5736	1,36
-2	2	5	59,04	1,5646	1,36
1	4	3	59,15	1,5619	0,3
-2	3	4	59,15	1,5618	1,14
4	0	2	59,59	1,5515	0,17
1	1	6	59,6	1,5511	0,61
- :4	~1	2	59,61	1,551	0,58
3	3	2	59,74	1,5479	4,35
-2	4	2	59,91	1,54 4	1,19
0	3	5	59,91	1,5439	0,69
.2	3	<u>,4</u>	60,00	1,5286	0,05

8.5.2 Diagrama de polvo calculado para $KSbP_2S_6$. Grupo espacial Monoclínico $P12_11(N^{\circ}4)$ Radiación $Cu-K(\alpha)$, 5.00 < 2 θ < 60.00

h	k	I	2 θ	d (Å)	I/I ₀	h	k	1	2 θ	d (Å)	I/I ₀
0	0	1	9,07	9,7477	100	1	0	1	16,49	5,3743	2,15
1	0	0	13,41	6,6005	4,34	1	1	0	17,75	4,9978	34,78
0	1	1	14,72	6,0185	14,42	0	0	2	18,2	4,8738	8,54
-1	0	1	15,94	5,5613	45,8	-1	1	1	19,73	4,4985	14,19
1	0	1	16,49	5,3743	2,15	1	1	1	20,19	4,3978	38,34
1	1	0	17,75	4,9978	34,78	0	1	2	21,62	4,1107	1,26
0	0	.2	18,2	4,8738	8,54	-1	0	2	22,27	3,9917	6,22
-1	1	1	19,73	4,4985	14,19	1	0	2	23,08	3,8536	1,16
1	1.	1.	20;19	4,3978	38,34	0.	2	0	23,25	3,8256	11,96
0	1	2	21,62	4,1107	1,26	0	2	1	25	3,5611	56,87
-1	0	-2	-22,27	3,9917	-6,22	-1	1	2	25,16	-3,539	4,89
1	0	2	23,08	3,8536	1,16	1	1	2	25,89	3,4417	13,35
0	2	Q	23,25	3,8256	11,96	1.	2.	Q	26,94.	3,3098	6,87
0	2	1	25	3,5611	56,87	2	0	0	27,02	3,3003	10,91
-1	1	2	25,16	3,539	4,89	0	0	3	27,45	3,2492	0,19
1	1	2	25,89	3,4417	13,35	-2	0	1	28,23	3,1615	0,26
1	2	0	26,94	3,3098	6,87	-1	2	1	28,31	3,1518	12,06
2	0	0	27,02	3,3003	10,91	1	2	1	28,64	3,1166	7,68
0	0	3	27,45	3,2492	0,19	2	0	1	28,88	3,0916	1,47
-2	0	1	28,23	3,1615	0;26	2	1	0	29,47	3,0304	0,85
-1	2	1	28,31	3,1518	12,06	0	2	2	29,69	3,0093	7,25
1	2	1	28,64	3,1166	7, 68	0	1	3	29,87	2,9907	3 , 15
2	0	1	28,88	3,0916	1,47	-1	0	3	30,21	2,9586	0,04
-2	1	0	29,47	3,0304	0,85	-2	1	1	.30,6	2,9219	15,58
0	2	2	29,69	3,0093	7,25	1	0	3	31,12	2,8735	0,74
Q	1.	3.	29,87	2,9907	3,15	2	1	1	31,2	2,8664	24,91
-1	0	3	30,21	2,9586	0,04	-2	0	2	32,19	2,7807	11,78
-2	1	1	30,6	2,9219	15,58	-1	2	2	32,41	2,7619	34,7
1	0	3	31,12	2,8735	0,74	-1	1	3	32,44	2,7595	29,99
2	1	1	31,2	2,8664	24,91	1	2	2	32,99	2,7149	3,5
-2	0	2	32,19	2,7807	11,78	1	1	3	33,31	2,6901	27,18
-1	2	2	32,41	2,7619	34,7	2	0	2	33,34	2,6872	15,36
-1	1		،32,44	2,7595	29,99	-2	1	··2	34,31	2,6134	20,15
1	2	2	32,99	2,7149	3,5	2 2	1	2	35,4	2,5353	21,19
0	0	1	9,07	9,7477	100		2	0	35,94	2,4989	2,61
1	0	0	13,41	6,6005	4,34	0	2	3	36,27	2,4765	10,88
0	1	1	14,72	6,0185	14,42	0	3	1.	36,41	2,4673	0,4
-1	0	1	15,94	5,5613	45,8	-2	2	1	36,88	2,437	14,71

8.5.2. Diagrama de polvo de KSbP₂S₆ (Continuación)

h	k	1	2 θ	d (Å)	l/l ₀	h	k	I	2 θ	d (Å)	I/I ₀
0	0	4	36,88	2,4369	21,38	2	2	3	46,46	1,9547	3,98
2	2	1	37,4	2,4045	7,66	0	0	5	46,58	1,9495	1,03
1	3	-0	37,82	2,37 9	22,59	1	2	4	46,69	1,9453	1,45
-2	0	3	38,14	2,3592	0,26	-1	3	3	47,04	1,9317	0,66
-1	2	3.	38,46	2,3404	5,05	-2	1	4	47,05	1,9312	4,19
0	1	4	38,78	2,322	6,48	2	0	4	47,17	1,9268	4,12
-1	3	1	38,85	2,3182	6,86	3	1	2	47,47	1,9152	4,86
-1	0	4	38,92	2,3139	0,02	0	4	0	47,53	1,9128	4,08
1	3	1	39,09	2,3041	6,13	1	3	3	47,68	1,9074	3,04
1	2	3	39,21	2,2976	0,89	3	2	0	47,68	1,9072	3,61
2	0	3	39,63	2,2739	3,32	0	1	5	48,17	1,8892	2,55
0	3	2	39,89	2,2597	0,66	-1	0	5	48,18	1,8887	1,23
1	0	4	39,9	2,2592	0,57	-3	2	1	48,33	1,8831	4,88
-2	1	3	39,99	2,2545	8,8	-2	3	2	48,43	1,8795	6 ,42
-2	2	2	40,09	2,2493	0,79	0	4	1	48,5	1,877	1,05
-1	.1	4	40,74	2,2149	-6,63	2	1	4	48,73	1,8685	0,34
3	0	0	41,02	2,2002	1,03	3	2	1	48,95	1,8606	6,33
2	2	2	41,05	2,1989	4,9	-3	0	3	49,15	1,,8538.	1,97
2	1	3	41,42	2,1797	2,68	1	0	5	49,22	1,8513	0,37
1	1	4	41,68	2,1667	6,73	2	3	2	49,26	1,8499	1,58
-3	0	1	41,75	2,1634	1,91	1	4	0	49,62	1,8372	0,69
-1	3	2	42,04	2,1491	6,99	-1	1	5	49,72	1,8336	0,25
3	0	1	42,45	2,1294	0,16	-1	4	1	50,45	1,8088	1,28
1	3	2	42,5	2,1268	11,89	1	4	1	50,65	1,802	0,22
3	1	-0	42,76	2,1145	·0,98	-3	1	3	50,67	1,8016	0,55
-3	1	1	43,47	2,0817	0,88	1	1	5	50,74	1,7993	1,6
0	2	4	44,06	2,0553	1,79	-3-	2	2	50,85	1,7956	8,09
3	1	1	44,15	2,0514	2,18	3	0	3	50,98	1,7914	2,57
-3	0	2	44,55	2,0336	1,29	.0	4	2	51,31	1,7806	5,32
2	3	0	44,92	2,018	4,01	-2	2	4	51,65	1,7695	0,31
-2	2	3	45,15	2,0081	1,67	Q	3	4.	51,89	1,7619	0,45
0	3	3	45,2	2,0062	1,31	3	2	2	52,04	1,7572	3,5
-2	0	4	45,44	1,9958	0,17	3	1	3	52,46	1,7443	0,41
-2	3	1	45,7	1,985	3,06	0	2	5	52,69	1,737	5,32
-1	2	4	45,83	1,9799	0,67	-2	3	3	52,86	1,7319	2,95
3	0	2	45,87	1,9782	1,04	-1	4	2	53,09	1,725	3,04
2	3	1	46,14	1,9673	2,51	2	2	4	53,23	1,7208	0,1
-3	1	.2	46,19	1,9654	0,49	-1	3	4	53,47	1,7137	4,95

*I/I*₀

5,7 1,11 3,72 0,45 0,34 0,14

0,04 0,08

8.5.2. Diagrama de polvo de KSbP₂S₆ (Continuación)

h	k	1	2 θ	d (Å)	VI ₀	h	k	I	2 θ	d (Å)
1	4	2	53,48	1,7133	3,66	3	3	2	59,1	1,5631
-2	0	5	53,72	1,7063	0,34	-2	2	5	59,3	1,5583
2	3	3	54,03	1,6973	1,3	2	4	2	59,3	1,5583
-1	2	5	54,16	1,6935	4,28	-1	1	6	59,32	1,5579
1	3	4	54,24	1,6911	7,13	0	3	5	59,7	1,5488
-3	2	3	55,05	1,6682	3,79	-4	1	2	59,73	1,5481
1	2	5	55,11	1,6664	0,68	4	0	2	59,83	1,5458
3	3	0	55,13	1,6659	1,07	2	3	4	60,00	1,5374
-2	1	5	55,15	1,6654	6,83					
-3	0	4	55,2	1,6638	0,77					
2	4	0	55,53	1,6549	2,69					
2	0	5	55,63	1,6521	0,36					
4	0	0	55,7	1,6501	0,23					
-3	3	1	55,71	1,6498	1,03					
0	4	3	55,77	1,6484	5,03					
-4	0	1	56,19	1,6369	0,18					
-2	4	1	56,2	1,6366	0,37					
3	3	1	56,28	1,6346	0,33					
2	4	1	56,58	1,6266	1,2					
-3	1	4	56,61	1,6258	1,54					
0	0	6	56,65	1,6246	3,88					
3	2	3	56,74	1,6224	2,45					
4	0	1	56,94	1,6172	0,01					
2	1	5	57,03	1,6149	1,26					
4	1	0	57,1	1,613	11,93					
-1	4	3	57,36	1,6063	2,43					
3	0	4	57,45	1,604	0,54					
-4	1	1	57,58	1,6007	4,07					
1	4	3	57,91	1,5923	0,97					
-1	0	6	57,96	1,5912	0,86					
-3	3	2	58	1,59	1,24					
0	1	6	58,04	1,5892	0,79					
4	1	1	58,31	1,5823	4,8					
-4	0	2	58,38	1,5808	0					
-2	4	2	58,57	1,5759	1,24					
-2	3	4	58,74	1,5718	0,36					
3	1	4	58,82	1,5698	0,15					
1	0	6	59,05	1,5642	0,89					

8.5.3 Indexación del diagrama de polvo de NaSb P_2 S $_6$ en el grupo espacial Monoclínico $P12_11(N^\circ 4)$ Radiación Cu- $K(\alpha)$, 5.00 < 2 θ < 60.00

2 θ	l/I _o	d _{calculada} (Å)	d _{observada} (Å)		h k I	
8,37	92	9,75	10,57	0	0	1
13,65	25	6,60	6,48	-1	0	Ö
14,78	25	6,02	5,99	0	1	1
16,13	97	5,56	5,49	-1	0	1
16,72	100	5,37	5,33	1	0	1
17,58	27	5,00	5,04	-1	1	0
19,70	13	4,498	4,503	-1	1	1
20,72	49	4,397	4,284	1	1	1
23,85	35	3,826	3,728	0	2	0
25,16	50	3,538	3,537	-1	1	2
25,78	25	3,442	3,452	1	1	2
26,84	37	3,310	3,319	-1	2	0
27,50	24	3,249	3,241	0	0	3
27,97	33	3,161	3,187	-2	0	1
28,67	13	3,116	3,111	1	2	1
29,41	33	3,030	3,034	-2	1	0
29,71	18	3,009	3,004	0	2	2
30,81	42	2,922	2,900	-2	1	1
31,46	43	2,866	2,841	2	1	1
32,35	46	2,761	2,765	-1	2	2
33,76	98	2,687	2,652	2	0	2
34,70	41	2,613	2,583	-2	1	2
36,00	13	2,498	2,492	-2	2	0
36,30	15	2,476	2,472	0	2	3
37,66	21	2,378	2,386	-1	3	0
39,53	27	2,273	2,278	2	0	3
40,70	27	2,215	2,215	-1	1	4
42,24	21	2,129	2,137	3	0	1
42,54	16	2,126	2,123	1	3	2
42,84	17	2,114	2,109	-3	1	0
43,50	13	2,081	2,078	-3	1	1
44,46	29	2,033	2,036	-3	0	2
47,81	27	1,907	1,901	-3	2	0
48,56	16	1,876	1,873	0	4	1
50,39	9	1,809	1,809	-1	4	1
51,55	16 10	1,769	1,771	-2	2 2	4
52,02	12	1,757	1,757	3		2 2
53,02	8	1,725	1,725	-1 4	4	
56,82	30	1,617	1,619	4	0	1

8.5.4 Indexación del diagrama de polvo de CuBi P_2 Se $_6$ en el grupo espacial Monoclínico C2/m. Radiación Cu- $K(\alpha)$, 5.00 < 2 θ < 60.00

2θ	I/I ₀	d _{calculada} (Å)	d _{observada} (Å)	h k i
13.58	100	6.51	6.51	001
17.29	3	5.13	5.13	110
18.83	6	4.708	4.708	-1 1 1
20.86	1	4.256	4.256	021
27.12	58	3.285	3.285	002
29.65	4	3.011	3.011	-2 0 1
30.67	26	2.913	2.913	-1 3 1
31.77	2	2.814	2.814	022
32.42	2	2.759	2.759	040
38.82	16	2.138	2.138	-222
39.55	1	2.277	2.277	-1 1 3
40.62	3	2.219	2.219	221
41.05	23	2.197	2.197	003
48.26	5	1.884	1.884	-2 4 2
49.93	9	1.825	1.825	222
51.00	3	1.789	1.789	-3 3 1
55.60	41	1.652	1.651	004
57.45	1	1.603	1.603	-2 2 4
58.81	2	1.569	1.569	-261
60.25	1	1.5349	1.5347	-402
61.22	1	1.5129	1.5129	223
65.69	2	1.4203	1.4202	171
71.07	1	1.3253	1.3250	-225
76.53	3	1.2439	1.2439	082
77.74	6	1.2274	1.2274	-2 8 1

8.5.5 Indexación del diagrama de polvo de AgBi P_2 Se $_6$ en el grupo espacial Monoclínico C2/m. Radiación Cu- $K(\alpha)$, 5.00 < 2 θ < 60.00

2θ	l/l ₀	d _{calculada} (Å)	d _{observada} (Å)	h k I
13.50	100	6.56	6.55	001
16.80	1	5.28	5.27	020
17.87	1	4.96	4.96	110
19.12	1	4.641	4.637	-1 1 1
20.84	3	4.262	4.259	021
24.39	1	3.649	3.647	111
27.08	42	3.292	3.289	002
27.42	11	3.253	3.250	-1 1 2
29.82	9	2.996	2.993	-2 0 1
30.18	19	2.961	2.959	200
32.52	1	<i>2.</i> 755	<i>2.</i> 753	022
33.29	1	2.692	2.689	040
38.48	10	2.340	2.337	-222
39.67	11	2.272	2.270	220
41.05	19	2.199	2.197	003
44.69	1	2.028	2.026	023
45.41	2	1.997	1.995	240
49.71	7	1.834	1.832	222
55.67	23	1.651	1.648	004
60.63	1	1.5272	1.5250	260
62.80	2	1 <i>.</i> 4797	1.4782	400
67.42	1	1.3890	1.3887	332
70.91	2	1.3290	1.3285	-4 4 2
76.14	1	1.2502	1.2516	224
77.70	4	1.2289	1.2288	-5 1 2
79.07	2	1.2111	1.2107	-3 3 5

8.5.6 Indexación del diagrama de polvo de CuSbP2Se6 en el grupo espacial Monoclínico C2/m. Radiación Cu- $K(\alpha)$, 5.00 < 2 θ < 60.00

2θ	I/I ₀	d _{calculada} (Å)	d _{observada} (Å)	h k I
13.63	50	6.49	6.49	001
17.21	1	5.15	5.15	110
19.31	2	4.594	4.594	-1 1 1
19.62	1	4.521	4.520	021
24.17	1	3.679	3.679	111
27.17	100	3.280	3.279	002
27.76	-5	3.212	3.211	-112
29.68	2	3.008	3.008	-2 0 1
30.89	23	2.892	2.892	-131
31.86	1	2.806	2.805	022
34.44	2	2.602	2.601	-202
39.02	12	2.306	2.306	-222
39.85	3	2.260	2.263	-1 1 3
41.07	8	2.196	2.196	003
44.27	1	2.045	2.044	023
46.00	1	1.972	1.972	-151
48.73	6	1.867	1.867	113
50 .11	11	1.819	1.818	222
55.63	28	1.651	1.650	004
63.19	2	1.4703	1.4702	-262
65.34	2	1.4271	1.4272	420
76.75	2	1.2408	1.2407	082
77.86	7	1.2259	1.2258	-281
79.49	2	1.2047	1.2047	-372

8.5.7 Indexación del diagrama de polvo de $AgSbP_2Se_6$ en el grupo espacial Monoclínico C2/m. Radiación Cu- $K(\alpha)$, 5.00 < 2 θ < 60.00

2θ	I/I ₀	d _{calculada} (Å)	d _{observada} (Å)	h k I
13.36	100	6.62	6.62	001
16.92	3	5.23	5.23	110
21.53	2	4.125	4.124	021
26.85	64	3.318	3.317	002
30.31	13	2.946	2.946	200
31.23	3	2.861	2.861	022
34.17	4	2.622	2.621	-202
35.71	2	2.512	2.512	112
37.21	3	2.414	2.414	-222
40.17	17	2.243	2.214	-1 1 3
41.40	3	2.179	2.179	003
43.73	4	2.068	2.068	023
47.83	6	1.900	1.901	-1 3 3
49.50	8	1.836	1.836	222
51.55	3	1.772	1.771	330
55.24	22	1.661	1.661	-204
57.65	3	1.598	1.597	-2 2 4
62.59	2	1.4828	1.4828	400
63.97	2	1.4541	1.4541	-3 5 2
69.16	2	1.3572	1.3571	351
75.97	1	1.2515	1.2514	224
77.39	3	1.2321	1.2321	-3 5 4



8.5.8 Indexación del diagrama de polvo de $Cu_{0.7}Bi_{1.1}P_2Se_6$ en el grupo espacial Monoclínico C2/m. Radiación Cu- $K(\alpha)$, 5.00 < 2 θ < 60.00

$oldsymbol{2} heta$	I/I ₀	d _{calculada} (Å)	d _{observada} (Å)		h k l	•
13,42	100	6,61	6,59	0	0	1
18,65	1	4,71	4,72	-1	1	1
23,81	2	3,641	3,719	1	1	1
26,97	57	3,307	3,292	0	0	2
27,37	1	3,307	3,245	0	0	2
30,34	14	2,947	2,934	-2	0	0
38,59	2	2,352	2,325	-2	2	2
39,60	20	2,250	2,260	-1	1	3
40,90	32	2,204	2,200	0	0	3
47,73	2	1,875	1,900	-2	4	2
49,75	11	1,820	1,827	2	2	2
53,22	1	1,722	1,719	-3	3	0
55,49	20	1,653	1,652	0	0	4
77,67	5	1,2297	1,2271	-2	8	1

8.5.9 Indexación del diagrama de polvo de $Ag_{0.7}Bi_{1.1}P_2Se_6$ en el grupo espacial Monoclínico C2/m. Radiación Cu- $K(\alpha)$, 5.00 < 20 < 60.00

2θ	I/I ₀	d _{calculada} (Å)	d _{observada} (Å)		h k l	ľ
13,43	49	6,55	6,54	0	0	1
23,53	41	3,72	3,72	1	1	1
27,03	24	3,273	3,260	0	0	2
27,34	9	3,217	3,215	0	0	2
29,73	100	2,930	2,944	-1	3	1
30,06	5	2,930	2,933	-1	3	1
38,40	49	2,330	2,320	-2	2	2
39,65	11	2,226	2,250	-1	1	3
41,01	15	2,182	2,179	0	0	3
43,68	20	2,066	2,053	0	4	2
45,42	10	1,972	1,971	-1	5	1
47,27	8	1,915	1,906	2	0	2
49,65	8	1,802	1,821	2	2	2
51,73	9	1,766	1,756	-3	3	1
55,66	19	1,631	1,631	-2	4	3
56,14	23	1,636	1,636	1	5	2

8.5.10 Indexación del diagrama de polvo de $CuBi_{0.9}Sb_{0.1}P_2Se_6$ en el grupo espacial Monoclínico C2/m. Radiación $Cu-K(\alpha)$, $5.00 < 2\theta < 60.00$

2θ	I/I ₀	d _{calculada} (Å) d _{observada} (Å)			hkl	
13,40	100	6,62	6,58	0	0	1
26,94	31	3,31	3,30	0	0	2
27,42	2	3,225	3,224	-1	1	2
30,46	7	2,957	2,929	-1	3	1
37,48	2	2,362	2,395	-2	2	2
38,67	4	2,362	2,342	-2	2	2
40,86	9	2,208	2,208	0	0	3
48,11	2	1,878	1,888	1	5	1
49,75	3	1,829	1,830	2	2	2
55,44	15	1,6564	1,6550	0	0	4
77,65	2	1,2282	1,2282	-2	8	1

8.5.11 Indexación del diagrama de polvo de $CuBi_{0.8}Sb_{0.2}P_2Se_6$ en el grupo espacial Monoclínico C2/m. Radiación $Cu-K(\alpha)$, $5.00 < 2\theta < 60.00$

2θ	I/I ₀	d _{calculada} (Å) d _{observada} (Å)		h k		1
13,38	100	6,67	6,68	0	0	1
26,91	42	3,32	3,32	0	0	2
30,44	10	2,96	. 2,95	-1	3	1
37,47	3	2,37	2,40	-2	2	2
38,63	6	2,37	2,37	-2	2	2
40,82	13	2,21	2,21	0	0	3
49,70	4	1,838	1,838	2	2	2
55,40	21	1,662	1,661	0	0	4
77,67	4	1,2291	1,2301	-2	8	1

8.5.12 Indexación del diagrama de polvo de $CuBi_{0.7}Sb_{0.3}P_2Se_6$ en el grupo espacial Monoclínico C2/m. Radiación $Cu-K(\alpha)$, 5.00 < 2 θ < 60.00

2θ	I/I ₀	d _{calculada} (Å) d _{observada} (Å)		hi		•
13,39	100	6,64	6,64	0	0	1
26,91	33	3,32	3,32	0	0	2
30,47	7	2,96	2,98	-1	3	1
37,52	2	2,36	2,40	-2	2	2
38,67	4	2,32	2,33	-2	2	2
40,82	10	2,21	2,21	0	0	3
48,15	2	1,88	1,89	1	5	1
49,79	2	1,83	1,83	2	2	2
55,40	1	1,659	1,659	0	0	4
77,65	3	1,230	1,229	-2	8	1

8.5.13 Indexación del diagrama de polvo de BiPS $_4$ en el grupo espacial Ortorrómbico Ibca. Radiación Cu-K(lpha), 5.00 < 2heta < 60.00

$oldsymbol{2} heta$	Ľl₀	d _{calculada} (Å)	d _{observada} (Å)	h k I
16,04	87	5,55	5,55	0 2 0
16,78	73	5,30	5,30	2 0 0
18,16	61	4,91	4,90	0 0 4
19,05	19	4,66	4,67	2 1 1
21,53	63	4,14	4,14	1 1 4
22,68	14	3,93	3,93	1 2 3
23,27	39	3,83	3,83	2 2 0
24,23	73	3,68	3,68	0 2 4
24,74	61	3,60	3,60	2 0 4
29,16	35	3,07	3,07	1 2 5
29,61	100	3,01	3,02	1 1 6
30,41	20	2,95	2,94	3 2 1
31,43	16	2,85	2,85	1 3 4
32,30	94	2,78	2,77	0 4 0
33,91	16	2,65	2,65	4 0 0
36,61	80	2,458	2,457	0 0 8
37,26	47	2,418	2,416	0 4 4
37,70	44	2,387	2,389	2 4 2
38,60	93	2,335	2,335	4 0 4
39,83	22	2,269	2,265	3 3 4
40,22	15	2,238	2,240	0 3 7
40,54	24	2,219	2,221	1 4 5
41,11	31	2,200	2,198	3 0 7
42,11	66	2,144	2,145	0 1 9
42,78	12	2,116	2,115	5 0 1
43,76	11	2,070	2,070	2 2 8
45,18 45,70	27	2,011	2,010	1 3 8
45,73	25 40	1,986	1,986	3 1 8
47,10 47,40	10 26	1,933	1,932	4 2 6 3 4 5
47,49	36 12	1,915 1,900	1,916	3 4 5 4 1 7
47,85			1,902 1,772	
51,61 52,11	21 19	1,770 1,7577	1,7563	5 2 5 3 5 4
	29	1,7460	1,7460	0 5 7
52,44	29 34	1,7333	1,7324	0 6 4
52,88 53.26	26	1,7217	1,7324	2 6 2
53,26	23	1,7111	1,7209	2 6 2 4 3 7
53,57	23 18	1,6801	1,6800	5 4 1
54,64 55.80	19	1,6470	1,6470	5 4 1 2 6 4
55,89 56 53	34	1,6293	1,6289	1 5 8
56,53	34	1,0280	1,0208	1 3 0

8.5.14 Indexación del diagrama de polvo de $Bi_{0.9}Sb_{0.1}PS_4$ en el grupo espacial Ortorrómbico Ibca. Radiación Cu- $K(\alpha)$, 5.00 < 2 θ < 60.00

$oldsymbol{2} heta$!/I o	d _{calculada} (Å)	d _{observada} (Å)	,	h k	I
16,01	88	5,56	5,56	0	2	0
16,83	98	5,30	5,29	2	0	0
18,09	60	4,92	4,92	0	0	4
18,39	24	4,84	4,84	Q	2	2
19,12	36	4,65	4,65	2	1	1
21,52	97	4,14	4,14	1	1	4
23,29	81	3,84	3,83	2	2	0
24,22	96	3,68	3,68	0	2	4
24,77	99	3,61	3,60	2	0	4
29,10	20	3,07	3,07	1	2	5
29,61	100	3,02	3,02	1	1	6
30,43	21	2,95	2,94	3	2	1
31,4 5	37	2,85 [.]	2,85	1	3.	4
32,31	81	2,77	2,77	0	4	0
33,98	32	2,63	2,64	-3	0	5
36,59	96	2,460	2,459	0	0	8
37,22	92	2,419	2,419	Q	4	4
37,74	90	2,388	2,387	2	4	2
38,49	70	2,343	2,342	1	1	8
38,70	68	2,328	2,329	4	2	2
39,81	28	2,269	2,267	3	3	4
41,08	7 5	2,200	2,199	3	0	7
42,11	72	2,146	2,147	0	1	9
45,10	36	2,012	2,012	1	3	8
45,74	46	1,987	1,985	3	1	8
47,53	53	1,911	1,914	3	4	5
51,62	27	1,771	1,771	5	2	5
52,38	23	1,7439	1,7479	-0	5	7
52,86	22	1,7332	1,7332	0	6	4
54,65	19	1,6802	1,6803	5	4	1.
55,53	16	1,6557	1,6556	1	6	5
55,85	31	1,6480	1,6469	2	6	4
56,50	25	1,6299	1,6295	1	5	8
57,52	30	1,6041	1,6031	1	1	12
58,11	41	1,5903	1,5881	5	1	8

8.5.15 Indexación del diagrama de polvo de $Bi_{0.8}Sb_{0.2}PS_4$ en el grupo espacial Ortorrómbico Ibca. Radiación Cu- $K(\alpha)$, 5.00 < 2 θ < 60.00

$oldsymbol{2} heta$	l/l _o	d _{calculada} (A)	d _{observada} (Å)		h k	I
16,10	98	5,57	5,54	0	2	0
16,92	96	5,30	5,27	2	0	Ό
18,15	29	4,92	4,92	0	0	4
18,49	13	4,79	4,82	1 2	2	1
19,21	20	4,65	4,64	2	1	1
21,59	77	4,15	4,14	1	1	4
23,38	39	3,84	3,82	2	2	0
24,29	58	3,69	3,67	0	2	4
24,85	67	3,58	3,59	2	2	2
29,18	16	3,08	3,07	1	2	5
29,70	100	3,00	3,01	2	3	1
31,53	28	2,83	2,84	0	2	6
32,40	66	2,76	2,77	2	3	3
34,09	27	2,635	2,636	3	0	5
36,68	65	2,445	2,455	1 2	2	7
37,30	52	2,409	2,416	2	3	5
37,85	48	2,381	2,382	3	2	5
38,52	47	2,334	2,342	4	0	4
38,82	56	2,328	2,329	4	2	2
39,96	14	2,260	2,261	0	2	8
41,17	39	2,203	2,196	3	0	7
42,22	41	2,144	2,144	1	0	9
45,15	28	2,016	2,016	1	3	8
45,80	43	1,989	1,984	3	1	8
47,64	36	1,914	1,911	3	4	5
51,66	20	1,7691	1,7718	6	0	0
55,96	22	1,6425	1,6451	0	0	12
57,49	15	1,6062	1,6048	1	1	12
58,18	23	1,5880	1,5873	0	7	1

9 Referencias

- 1 M.G. Kanatzidis, Curr. Opinion Solid State Mater. Sci., 2, 139 (1997)
- 2 M. Evain, M. Queignec, R. Brec and J. Rouxel, *J. Solid State Chem.*, 56, 148 (1985)
- 3 J. Aitken, M. Evain, L. lordanidis and M.G. Kanatzidis, *Inorg. Chem.*, 41 (2002) 180-191
- 4 H.J. Moller, Semiconductor for solar cell, Artech House, Boston, 1993
- 5 a) K. Borkowski and J. Pyzyluski, Mater. Res. Bull., 22, 381 (1987)
 - b) Eun-Young Goh et. Al., J. Solid State Chem., 160 (2001) 195-204
 - c) J. Breshears and M. kanatzidis, J. Am. Chem. Soc., 122 (2000) 7839
 - d) J. Aitken et. Al., Inorg. Chem., 38 (1999) 4795
- 6 a) R. Patschke et. Al., Chem Mater, 13 (2001) 613
 - b) Ying C. Wang and F. J. Disalvo, Chem Mater, 12 (2000) 1011
 - c) P.M. Bridenbaugh, Mater.Res.Bull., 8, 1055 (1973)
- 7 C.D. Carpentier and R. Nitsche, Mater. Res. Bull., 9, 1097 (1974)
- 8 E. Arnautova, E. Sviridov, E. Rogach, E. Savchenko and A. Grekov, Integr. Ferroelectrics, 1, 117 (1992)
- 9 S. Harris and R.R. Chianelli, *J. Catal.*, 86, 400 (1984)
- 10 H. Eckert, Angew. Chem. Int. Ed. Engl., 28, 1723 (1989)
- 11 M.G. Kanatzidis, A.C. Sutorik, Progr. Inorg. Chem., 43, 161 (1995)
- 12 J.A. Cody, M.F.Mansuetto, S. Chien and J.A. Ibers, *Mater. Sci. Forum*, 35, 152 (1994)
- a) H. Hahn, R. Ott and W. Klingen, *Z. Anorg. Allg. Chem.*, 396, 271 (1973)b) T. McCarthy and M. Kanatzidis, *Inorg. Chem.*, 34 (1995) 1257-1267
- 14 B.E. Taylor, J. Steger and A. Wold, J. Solid State Chem. 7, 461 (1973)
- 15 R. Clément and M.L.H. Green, *J. Chem. Soc. Dalton Trans.* 10, 1566 (1979)
- 16 F. Menzel, L. Ohse and W. Brockner, Heteroatom. Chem., 1(5), 357 (1990)

- 17 M.G. Kanatzidis, A.C. Sutorik, *Progr. Inorg. Chem.*, 43, 161 (1995)
- 18 M.G. Kanatzidis y col., Chem. Mater., 8, 1465 (1996)
- 19 Duck-Young Chung y col., Chem. Mater., 9, 3060 (1997)
- 20 Ying C Wang and F. J. DiSalvo., Chem. Mater., 12, 1011 (2000)
- 21 Lykourgos I. et. al., Chem. Mater., 13, 622 (2001)
- 22 McCarthy T. et. al. col., Chem. Mater., 6, 1072 (1994)
- 23 C.D. Carpentier and R. Nitsche, Mater. Res. Bull., 9, 1097 (1974)
- 24 E. Arnautova, E. Sviridov, E. Rogach, E. Savchenko and A. Grekov, Integr. Ferroelectrics, 1, 117 (1992)
- 25 P.M. Bridenbaugh, *Mater.Res.Bull.*, 8, 1055 (1973)
- 26 Zimmermann H., Acta Cryst., B31, 2003 (1975)
- 27 W. Klingen, G. Eulenberger and H. Hahn, Z. Anorg. Alig. Chem. 401, 97° (1973)
- 28 G. Ouvrard, R. Brec and J. Rouxel, *Mater.Res.Bull.*, 20, 1181 (1985)
- 29 Brec R., Solid state Ionics, 22, 3 (1986)
- 30 L. Bernard y col., J. Phys. Chem. 88, 3833 (1984)
- 31 R. Clément, M. Doeuff and C. Gledel, *J. Chim. Phys.* 85, 1053 (1988)
- 32 P. Jeevanandam and S. Vasudevan, *J. Phys. Chem. B* 102, 3082 (1998)
- 33 J.W. Johnson: *Intercalation Chemistry*, Ed. M.S. Whittingham and A.J. Jacobson, New York, Academic Press Inc., 267 (1982)
- 34 D.S. Glueck, A.R. Brough, P. Mountford and M.L.H. Green, Inorg. Chem. 32, 1893 (1993)
- 35 C.O. Oriakhi and M.M. Lerner, Chem. Mater. 8, 2016 (1996)
- 36 T. Coradin, R. Clément, P.G. Lacroix and K. Nakatani, Chem. Mater. 8, 2153 (1996)
- a) V. Manríquez, A. Galdámez, A. Villanueva, P. Aranda, J.C. Galván and E. Ruiz-Hitzky, *Mater. Res. Bull.*, 34, 673 (1999)
 - b) V. Manríquez, A. Galdámez, D. Ruiz León, M.T .Garland and M. Jimenes, Z. Kristallogr. NCS, 218 (2003) 151-152

- c) V. Manríquez, A. Galdámez, D. Ruiz León and M.T .Garland, Z. Kristallogr. NCS, 218 (2003) 403-404
- d) A. Galdámez, V. Manríquez, J. Kasaneva and R. Avila, Mater. Res. Bull., 38 (2003) 1063-1070
- 38 R. Clément, A. Léaustic, K. Marney and A.H. Francis, J. Luminescence 60/61, 355 (1994)
- 39 R. Clément, J.J. Girerd and I. Morgenstern-Badarau, *Inorg. Chem.* 19, 2852 (1980)
- 40 J. Qin, C. Yang, K. Yakushi, Y. Nakazawa and K. Ichimura, Solid State Commun. 100, 427 (1996)
- 41 R. Pfeif and R. Kniep, J. Alloys Comp., 186, 111 (1992)
- 42 M. Evain, R. Brec and Y. Mathey, J. Solid State Chem., 90, 8 (1991)
- 43 Y.Mathey, R. Clément, J.P. Auduere, O. Poizat and C. Sourisseau, Solid State Ionics 9/10, 459 (1983)
- 44 Y. Mathey, H. Mercier, A. Michalowics and A. Leblanc, *J. Phys. Chem.*Solids 46, 1025 (1985)
- 45 R. Brec, Solid State Ionics 22, 3 (1986)
- 46 E. Durand, G. Ouvrard, M. Evain and R. Brec, *Inorg. Chem.* 29, 4916 (1990)
- 47 E. Durand, M. Evain and R. Brec, J. Solid State Chem. 102, 146 (1993)
- 48 W. Carrillo-Cabrera, J. Sassmannshausen, H.G. von Schnering, E. Menzel and W. Brockner, Z. Kristallogr., 202, 150 (1992)
- 49 F. Menzel, W. Brockner, W. Carrillo-Cabrera and H.G. von Schnering Z. Anorg. Alig. Chem., 620, 1081 (1994)
- 50 Aitken J., Evian M., Lykourgos I. and Kanatzidis M., *Inorg. Chem.* 41, 180 (2002)
- 51 S.H. Elder y col., J. Solid State Chem. 116, 107 (1995)
- 52 T. McCarthy and M.G. Kanatzidis, *J. Alloys Comp.*, 236, 70 (1996)
- 53 M. Ruck, Z. Anorg. Allg. Chem. 621, 1344 (1995)
- 54 J. Aitken et. al, Inorg. Chem., 38, 4795 (1999)

- 55 T. McCarthy and M.G. Kanatzidis, *J.Chem.Soc., Chem. Commun.*, 9, 1089 (1994)
- 56 Breshears J.D.; Kanatzidis, M.G., J. Am. Chem. Soc., 122, 7839 (2000)
- 57 T. McCarthy y col., Chem. Mater. 6, 1072 (1994)
- 58 R. D. Shannon, Acta Cryst. A32, 751 (1976)
- 59 F. Hulliger, Structural Chemistry of Layered-Type phases, D. Riedel Publishing Company, Dordrecht-Holland/Boston-USA.
- 60 L. Pauling, *The Nature of the Chemical Bond,* Cornell University Press, New York, 1966, 3era edn., p. 260
- 61 P. Barahona, Tesis de Doctorado, Universidad de Chile (2003)
- 62 G.A. Landrum, Yet Another Extender Hückel Molecular Orbital Packege; Cornell University (1997)
- 64 Anthony R. West, Solid State Chemistry and it's Applications, University of Aberdeen, John Wiley & Sons, 1995, p. 482
- 65 Irvine J., Sinclair D., West A. R., Adv. Mater., 2 (1990)132-138
- 66 J. Kasaneva, Tesis Doctoral, Barcelona, España (1990)
- 67 Rose, A. "Concepts in Photoconductivity and Allied Problems Robert E. Krieger Publ. Co. Huntington, N. Y., (1978)
- 68 Bube, R.H J. Phys. Chem. Solids 1, 234 (1957)
- 69 Cohen, M. H., Fritzsche, H. y Ovshinsky, S. R *Phys. Rev. Lett.* 22, 1065 (1969)
- 70 Tiedje, T., Rose, A Solid. State Comm. 37, 49 (1981)
- 71 Fritzsche, H., Chen, K.J Phys. Rev. B 28, 4900 (1983)
- 72 Fritzsche, H., Ibaraki, N Phil. *Mag. B* 52, 299 (1985)
- 73 Tiedje, T Appl. Phys. Lett. 40, 627 (1982)
- 74 Vanier, P.E., Semiconductors and Semimetals Vol. 21 B. ed. por J. I. Pankove, 329 (1984)
- 75 Smith, G.B., Mckenzie, D.R., Phil. Mag. B 54, 255 (1986)
- 76 Carbnabuci, A., et. al., J Appl. Phys. 90, 4526 (2001)

Ą

- 77 Grasso, V., et. al., Phys. Rev. B37, 4419 (1988)
- 78 Zimmerman, H., et. al., Acta. Cryst. B31, 2003 (1975)
- 79 Donald, S., Introducción a la Cristalografía, Editorial Reverté, 1971.
- 80 Giacovazzo, C. et. al., *Fundamental of Crystallogaphy*, International Union of Crystallography, Oxford University Press, 1998.